

现货MEMS滤波器

名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMD020040-2K	2000MHz	4000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	1
滤波器	WLM026040K	2200MHz	3800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	2
滤波器	WLMD030040K	3000MHz	4000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	3
滤波器	WLMD035046K	3500MHz	4600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	4
滤波器	WLMX036038K	3600MHz	3800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	5
滤波器	WLM037051K	3700MHz	5100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	6
滤波器	NEW SM0039	3750MHz	4050MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	7
滤波器	WLM039062K	3900MHz	6200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	8
滤波器	WLMD040050K	4000MHz	5000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	9
滤波器	NEW SM0040	4250MHz	4650MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	10
滤波器	WLMD051053K	5100MHz	5300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	11
滤波器	WLMX054060K	5400MHz	6000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	12
滤波器	WLMD055057K	5500MHz	5700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	13
滤波器	WLMD057059K	5700MHz	5900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	14
滤波器	WLMX058062K	5850MHz	6150MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	15
滤波器	WLMD059061K	5900MHz	6100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	16
滤波器	WLMX059061K	5900MHz	6100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	17
滤波器	WLMX060070K	6000MHz	7000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	18
滤波器	WLM060080-2K	6000MHz	8000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	19
滤波器	WLMD063065K	6300MHz	6500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	20
滤波器	WLMD067069K	6700MHz	6900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	21
滤波器	WLMX067069K	6700MHz	6900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	22
滤波器	WLMX075085K	7500MHz	8500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	23
滤波器	WLMX078082K	7800MHz	8200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	24
滤波器	WLMD079121K	7900MHz	12100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	25



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMD079121-3K	7900MHz	12100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	26
滤波器	NEW SM0041	8000MHz	8600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	27
滤波器	WLMX080090K	8000MHz	9000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	28
滤波器	WLM080096K	8000MHz	9600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	29
滤波器	WLMD080108K	8000MHz	10800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	30
滤波器	WLMX080115K	8000MHz	11500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	31
滤波器	WLM080120K	8000MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	32
滤波器	WLMD080120K	8000MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	33
滤波器	WLMX080120K	8000MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	34
滤波器	WLM085099K	8500MHz	9900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	35
滤波器	WLMD085105K	8500MHz	10500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	36
滤波器	WLM086105K	8600MHz	10500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	37
滤波器	WLMX083093K	8300MHz	9300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	38
滤波器	WLMX085095K	8500MHz	9500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	39
滤波器	WLMX088092K	8800MHz	9200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	40
滤波器	WLM088102K	8800MHz	10200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	41
滤波器	WLMD089101K	8900MHz	10100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	42
滤波器	WLMX090095K	9000MHz	9500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	43
滤波器	WLM090100-2K	9000MHz	10000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	44
滤波器	WLMX094112K	9350MHz	11250MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	45
滤波器	NEW SM0042	9400MHz	10000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	46
滤波器	WLMD094109K	9400MHz	10900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	47
滤波器	WLMX095100K	9500MHz	10000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	48
滤波器	WLMX098102K	9800MHz	10200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	49
滤波器	WLMD098130-2K	9800MHz	13000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	50
滤波器	WLM099103K	9900MHz	10300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	51
滤波器	NEW SM0043	10000MHz	10700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	52
滤波器	WLMX100110K	10000MHz	11000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	53
滤波器	WLM100125-4K	10000MHz	12500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	54



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMX100140K	10000MHz	14000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	55
滤波器	WLMX101120K	10100MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	56
滤波器	WLM104120-1K	10400MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	57
滤波器	WLMD105130-2K	10500MHz	13000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	58
滤波器	NEW SM0044	10700MHz	11400MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	59
滤波器	WLMX109111K	10900MHz	11100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	60
滤波器	WLMX110120K	11000MHz	12000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	61
滤波器	WLMX112152K	11200MHz	15200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	62
滤波器	NEW SM0045	11400MHz	12200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	63
滤波器	WLMX115150K	11500MHz	15000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	64
滤波器	WLMD120135-2K	12000MHz	13500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	65
滤波器	WLMX120145K	12000MHz	14500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	66
滤波器	WLMD121149-2K	12100MHz	14900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	67
滤波器	NEW SM0046	12400MHz	13000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	68
滤波器	WLMD125155-3K	12500MHz	15500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	69
滤波器	WLMX130170-2K	13000MHz	17000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	70
滤波器	WLMX132141K	13200MHz	14100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	71
滤波器	WLMX135148K	13500MHz	14800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	72
滤波器	WLMX137146K	13700MHz	14600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	73
滤波器	WLMX140150K	14000MHz	15000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	74
滤波器	WLMX140180K	14000MHz	18000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	75
滤波器	WLMD145168-3K	14500MHz	16800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	76
滤波器	WLMX147160K	14700MHz	16000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	77
滤波器	WLMX150160K	15000MHz	16000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	78
滤波器	WLMD150170-3K	15000MHz	17000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	79
滤波器	NEW SM0047	15100MHz	16000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	80
滤波器	WLMX159167K	15500MHz	16800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	81
滤波器	WLMX155180K	15500MHz	18000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	82
滤波器	WLMD158176-2K	15800MHz	17600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	83



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMX159172K	15900MHz	17200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	84
滤波器	WLMX160170K	16000MHz	17000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	85
滤波器	WLMX160173K	16000MHz	17300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	86
滤波器	WLMD161173K	16100MHz	17300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	87
滤波器	WLMD165180-2K	16500MHz	1800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	88
滤波器	WLMD166182-2K	16600MHz	18200MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	89
滤波器	WLMD167230K	16700MHz	23000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	90
滤波器	NEW SM0050	16900MHz	18500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	91
滤波器	WLMX170180K	17000MHz	18000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	92
滤波器	WLMX172185K	17200MHz	18500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	93
滤波器	WLMX173193K	17300MHz	19300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	94
滤波器	NEW SM0048	17700MHz	19900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	95
滤波器	WLMX179181K	17900MHz	18100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	96
滤波器	WLMX179189K	17900MHz	18900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	97
滤波器	NEW SM0049	18200MHz	19700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	98
滤波器	WLMX187197K	18700MHz	19700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	99
滤波器	NEW SM0051	19000MHz	20000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	100
滤波器	WLMX190209K	19000MHz	20900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	101
滤波器	WLMD190235K	19000MHz	23500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	102
滤波器	NEW SM0052	19700MHz	21700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	103
滤波器	WLM200225-SK	20000MHz	22500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	104
滤波器	WLM214226K	21400MHz	22600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	105
滤波器	WLMX215225K	21500MHz	22500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	106
滤波器	WLMX215225-2K	21500MHz	22500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	107
滤波器	WLMX218222K	21500MHz	22500MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	108
滤波器	WLMD217223K	21700MHz	22300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	109
滤波器	NEW SM0053	23700MHz	25700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	110
滤波器	WLMD240300K	24000MHz	30000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	111
滤波器	WLMD247253K	24700MHz	25300MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	112



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLM250270-SK	25000MHz	27000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	113
滤波器	WLMX260400K	26000MHz	40000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	114
滤波器	WLMX270280-2K	27000MHz	28000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	115
滤波器	WLMX275300K	27500MHz	30000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	116
滤波器	WLMD294298K	29400MHz	29800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	117
滤波器	WLMX320400K	32000MHz	40000MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	118
滤波器	WLM325329-SK	32500MHz	32900MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	119
滤波器	WLMX331337K	33100MHz	33700MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	120
滤波器	WLM352378-SK	35200MHz	37800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	121
滤波器	WLM356378-3-SK	35600MHz	37800MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	122
滤波器	WLM380406-2-SK	38000MHz	40600MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	123
滤波器	WLM386391-SK	38600MHz	39100MHz	带通	芯片滤波器	MEMS	124



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

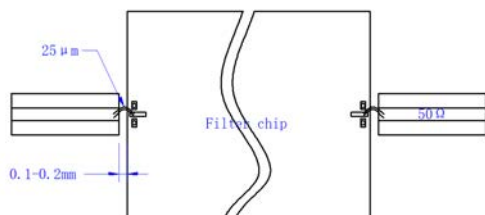
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2000	~	4000	MHz
中心损耗	/	/			2.3	dB
带内波动	/	/			2.5	dB
带外抑制	1.7&4.25	GHz≥	30			dB
带外抑制	1.55&4.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-1.4	GHz≥	50			dB
带外抑制	4.8-7.7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



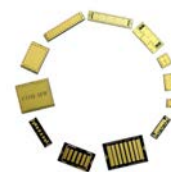
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

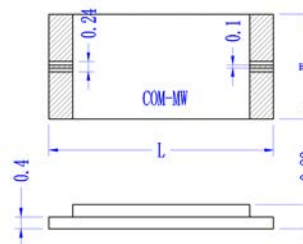
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

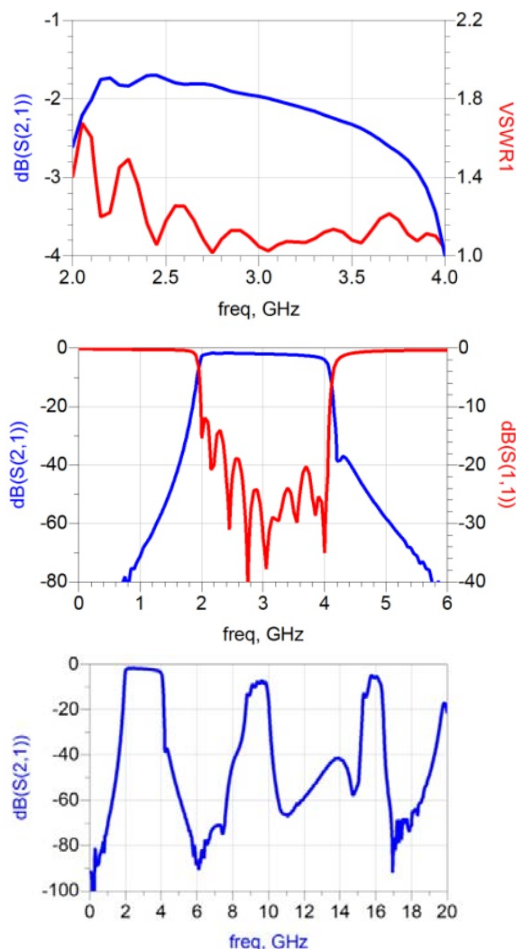


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.4	6.5	6.6
W	9.7	9.8	9.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

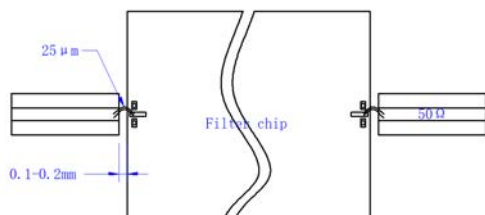
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2200	~	3800	MHz
中心损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	1.55&4.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	1.25&5.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-0.85	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.3-6.9	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2.1	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.9ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



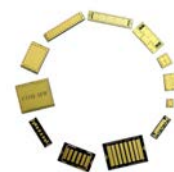
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

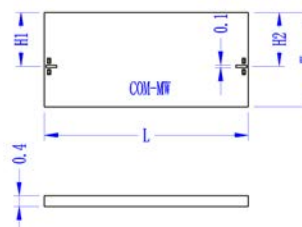
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

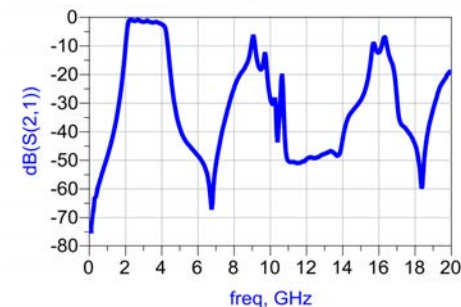
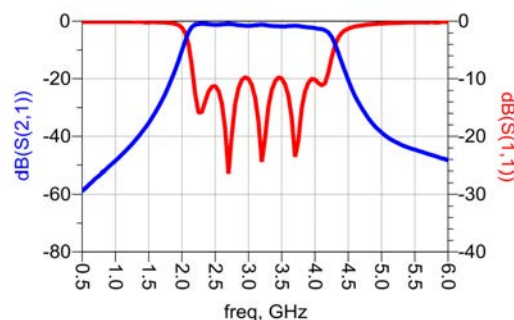
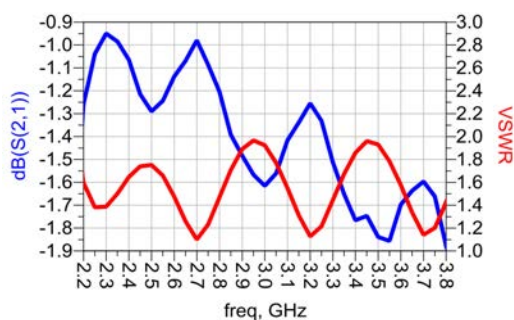


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.4	7.5	7.6
W	8.9	9.0	9.1
H1		4.5	
H2		4.5	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

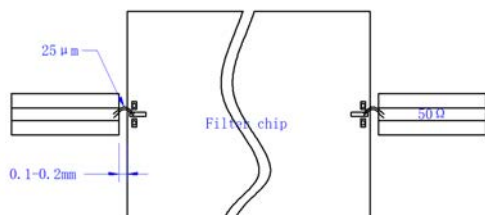
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3000	~	4000	MHz
中心损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2.5&4.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	2.35&4.85	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-2.15	GHz≥	50			dB
带外抑制	5.1-9.7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.8ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



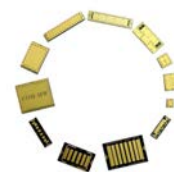
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

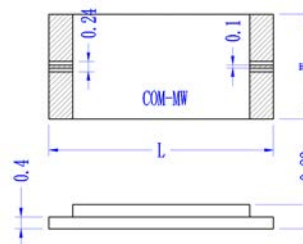
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

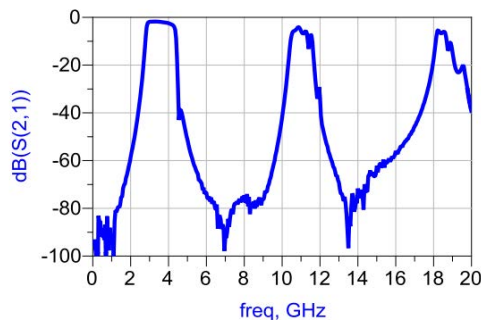
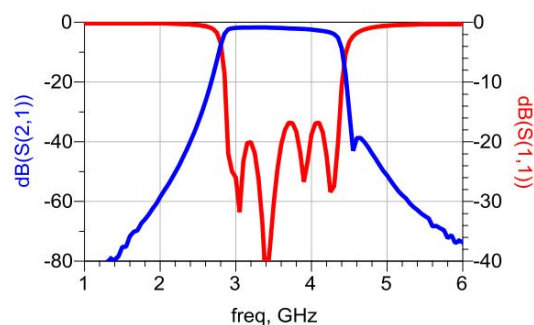
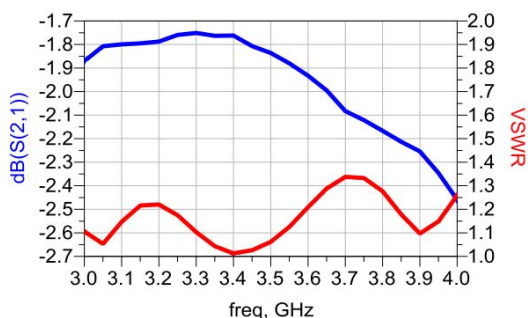


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.2	6.3	6.4
W	8.1	8.2	8.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

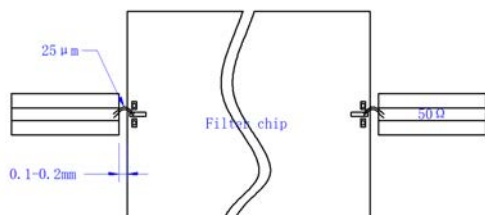
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3500	~	4600	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.7	dB
带外抑制	2.95&5.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	2.75&5.3	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-2.45	GHz≥	50			dB
带外抑制	5.9-10.3	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.0ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



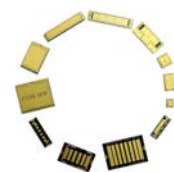
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

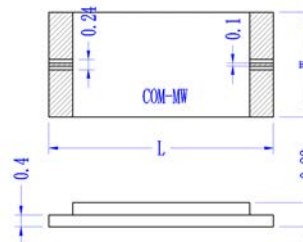
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

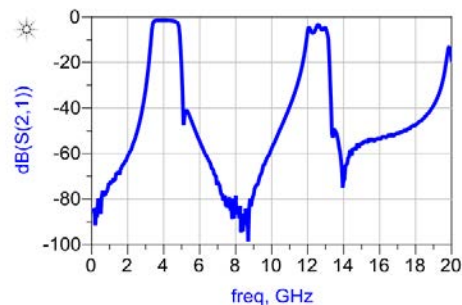
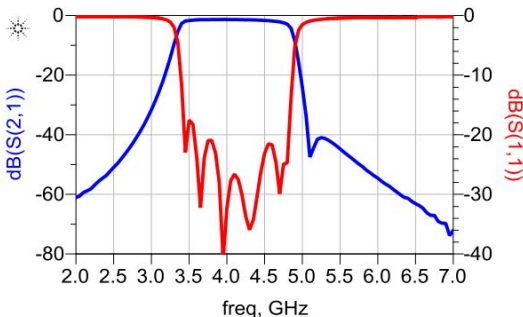
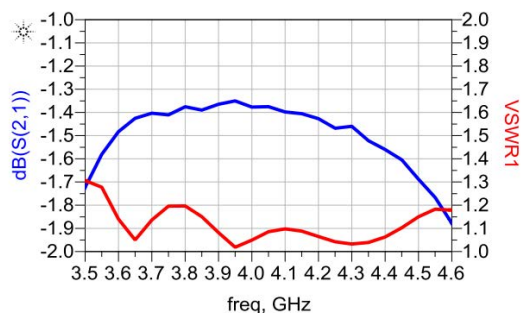


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	5.9	6.0	6.1
W	7.4	7.5	7.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

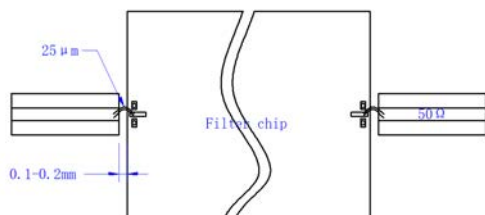
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3600	~	3800	MHz
中心损耗	/	/		6.6		dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	3.35&4.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	3.3&4.15	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-3.0	GHz≥	50			dB
带外抑制	4.3-18	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



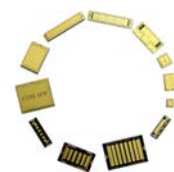
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

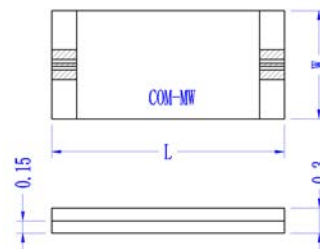
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

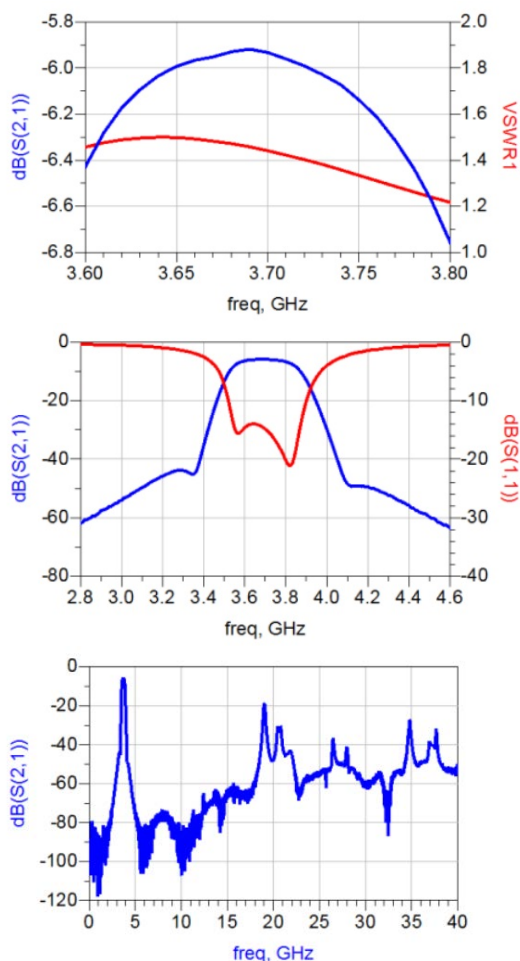


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.9	5.0	5.1
W	6.1	6.2	6.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

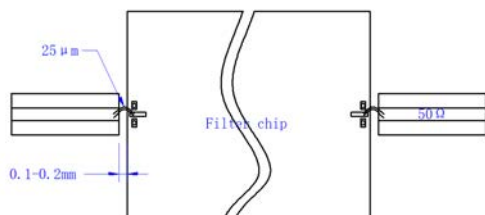
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3700	~	5100	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	2.55&5.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	2.1&5.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-1.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.3-10	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

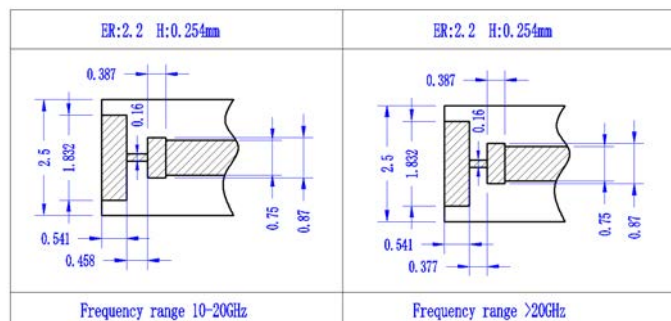
装配示意图



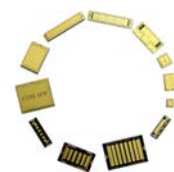
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

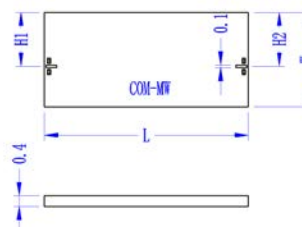
建议PCB布局图



参考实物图

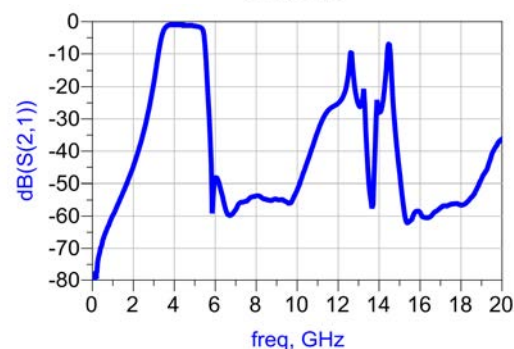
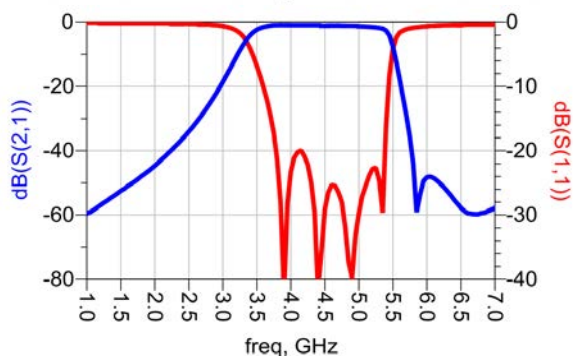
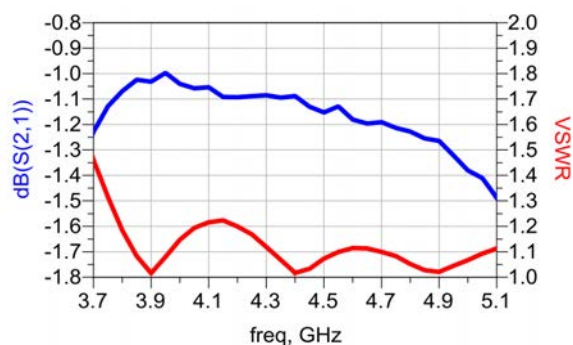


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.4	7.5	7.6
W	6.7	6.8	6.9
H1		3.4	
H2		3.4	

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

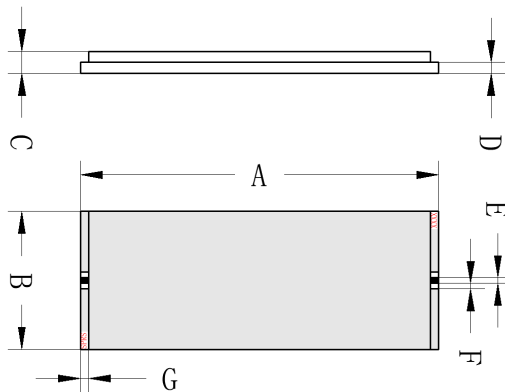
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.9	GHz
工作带宽	3.75-4.05	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-3.35GHz	dBc
带外抑制	40@4.45-10.5GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:7.0, B:7.0, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.67

外形图：端口居中



推荐装配图

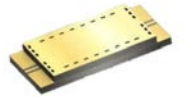


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

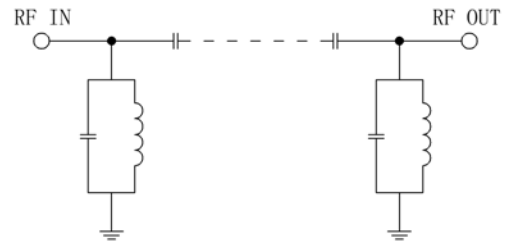
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

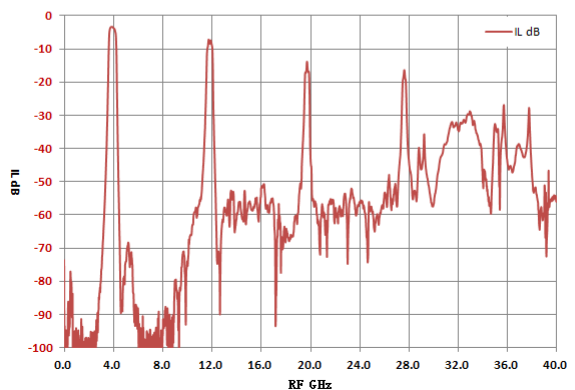
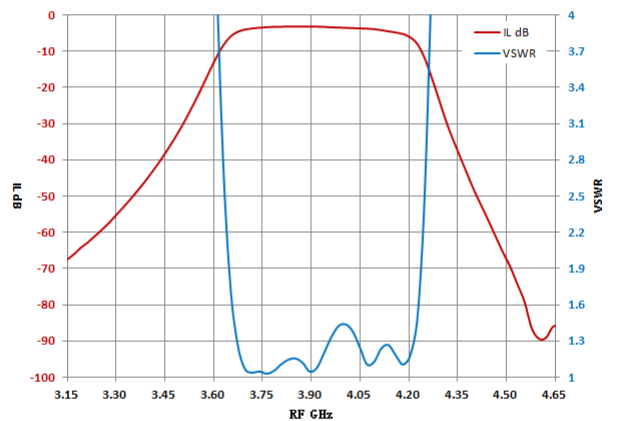
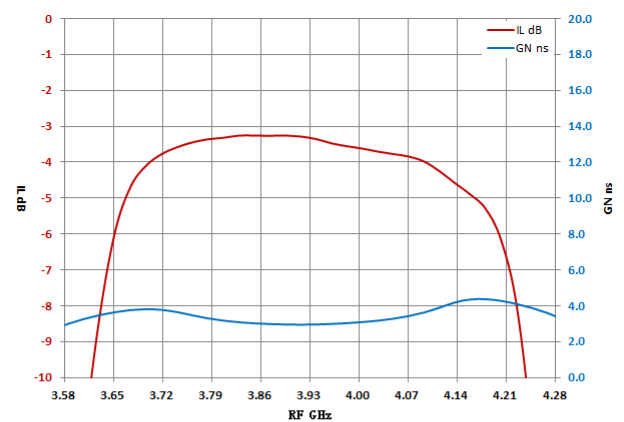
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

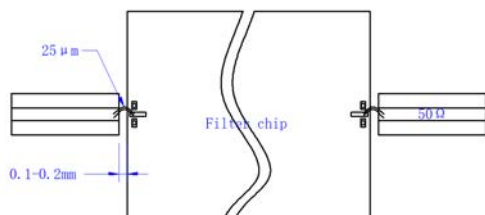
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3900	~	6200	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.4	dB
带外抑制	2.9&6.75	GHz≥	30			dB
带外抑制	2.55&6.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-2.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	7.2-11.3	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.0ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



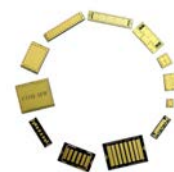
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

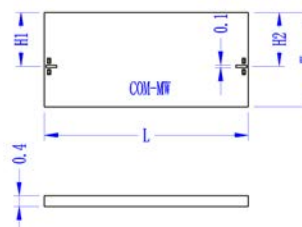
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

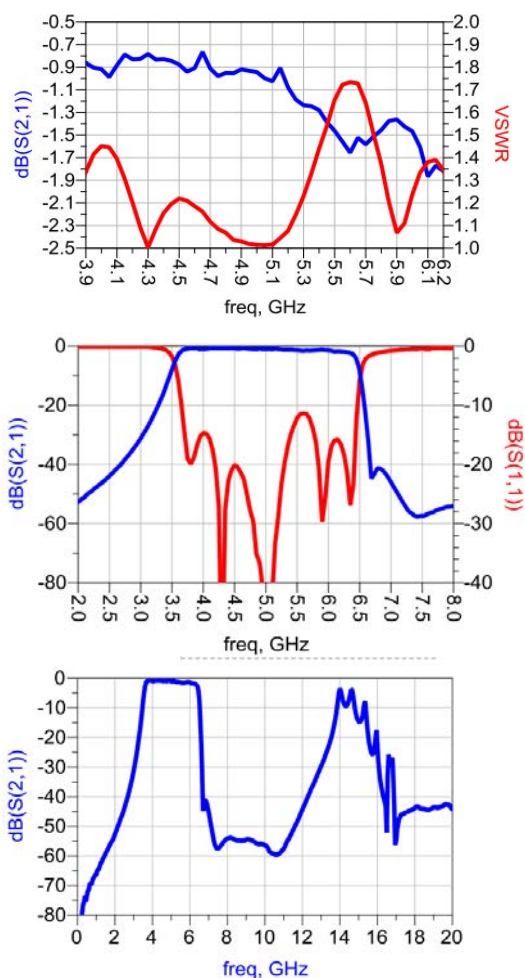


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.7	7.8	7.9
W	6.5	6.6	6.7
H1		3.3	
H2		3.3	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

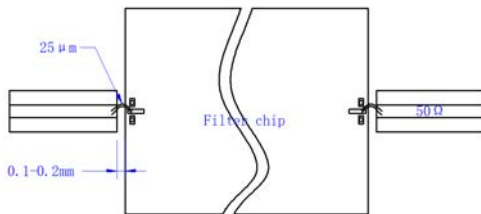
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4000	~	5000	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3.5&5.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	3.35&5.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-3.15	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.1-13	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.9	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

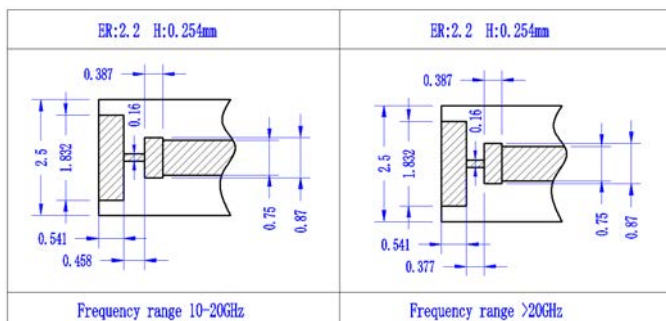
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

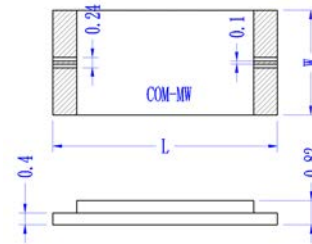
建议PCB布局图



参考实物图

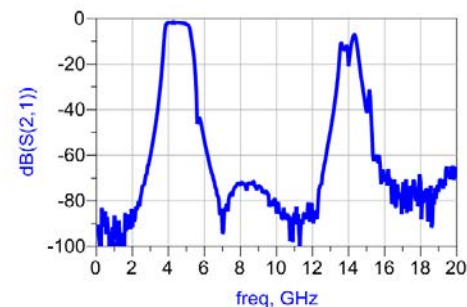
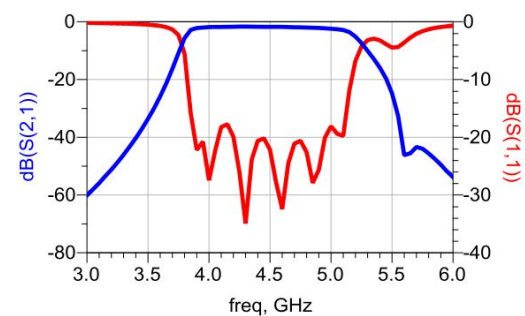
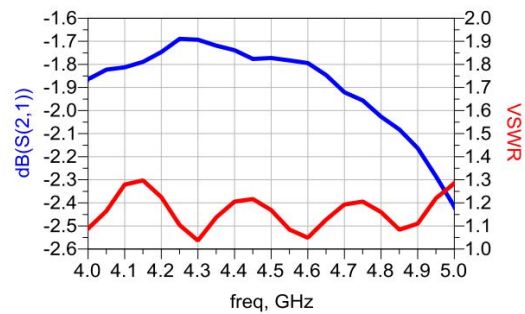


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.1	7.2	7.3
W	6.6	6.7	6.8

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备

高性能, 低温漂, 小体积

陶瓷基板, 50Ω共面波导

金丝键合, 适用于多芯片集成模块

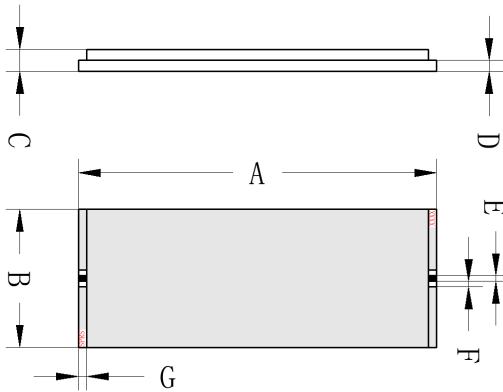
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.45	GHz
工作带宽	4.25-4.65	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	1.2	ns
带外抑制	40@DC-3.8GHz	dBc
带外抑制	40@5.1-12.5GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:7.0, B:6.5, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.72

外形图：端口居中



推荐装配图

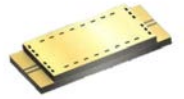


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

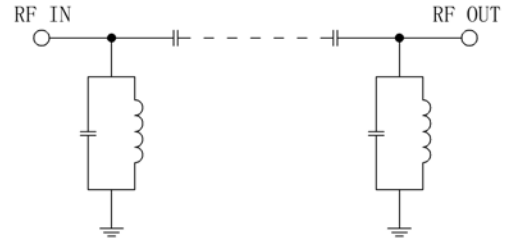
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.2mm, 端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接, 采用不少于2根25-50um金丝键合线连接, 连接线尽量短, 键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料, 载体厚度≥0.2mm,, 不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

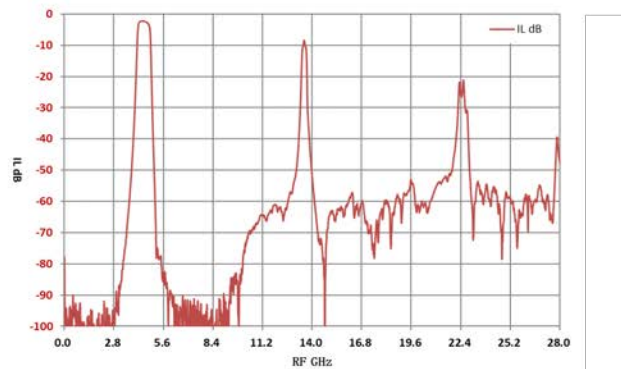
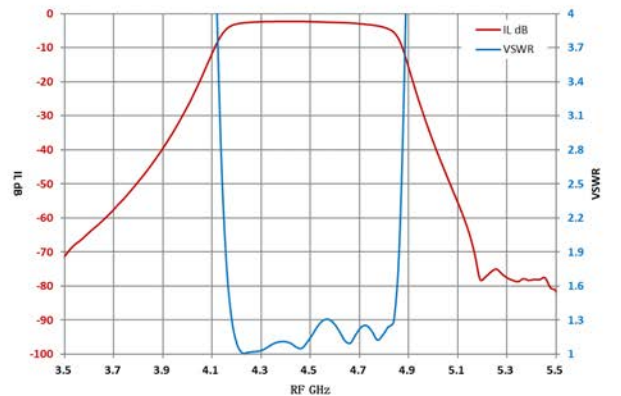
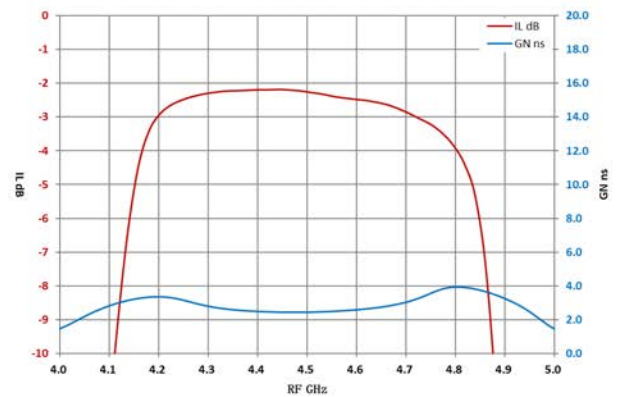
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

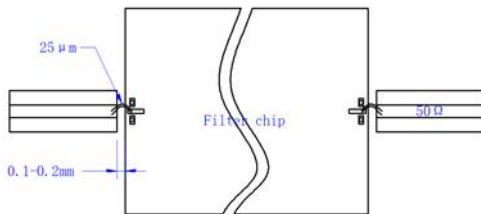
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5100	~	5300	MHz
中心损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	4.9&5.5	GHz $\geq$	20			dB
带外抑制	4.85&5.55	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	DC-4.8	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	5.6-14.9	GHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤ 1.2 ns
相位一致性	$\leq \pm 5^\circ$
工作温度	-55~+85 $^\circ$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^\circ$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

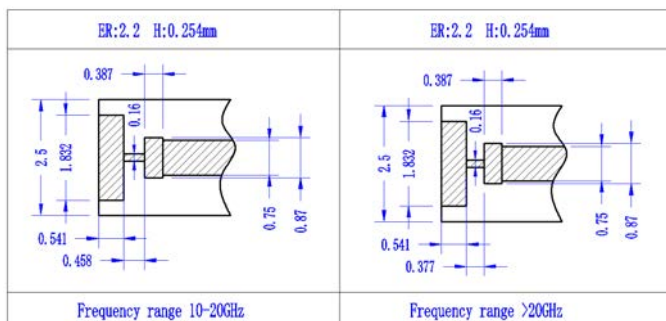
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥ 3 mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/ $^\circ$ C)相当的载体上, 载体厚度 ≥ 0.2 mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

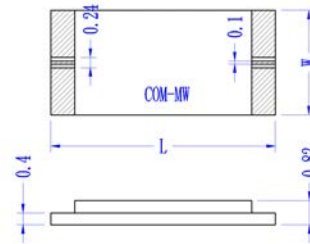
建议PCB布局图



参考实物图

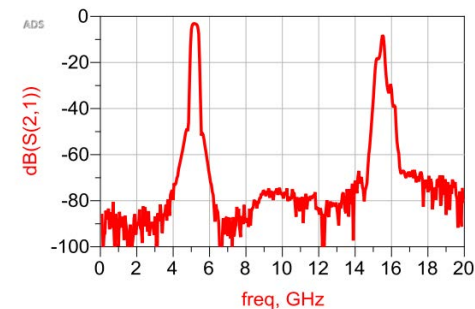
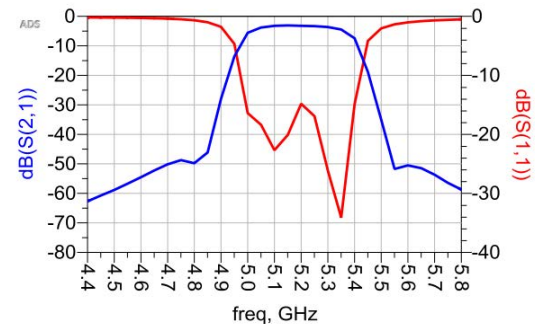
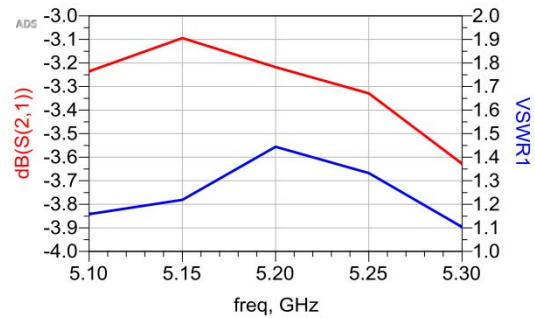


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.4	8.5	8.6
W	5.7	5.8	5.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

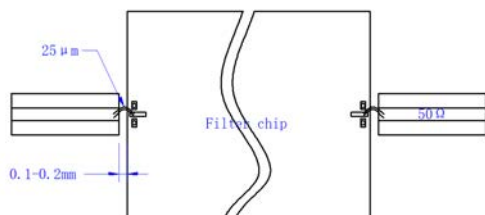
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5400	~	6000	MHz
中心损耗	/	/		3.5		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	4.85&6.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	4.7&6.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-4.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	7-18	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



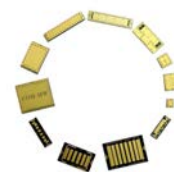
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

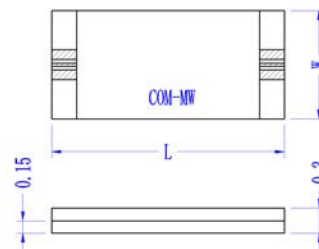
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

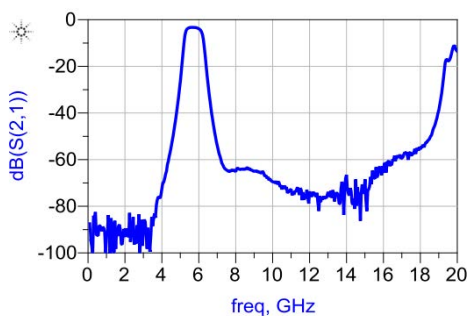
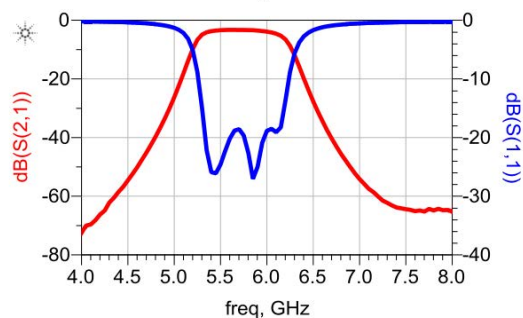
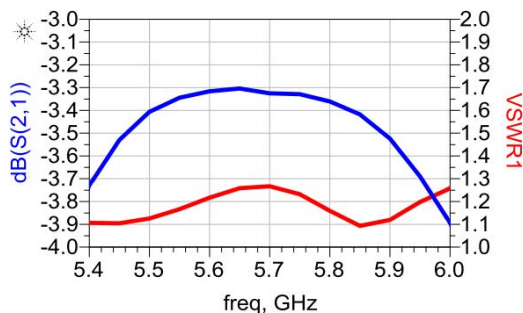


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.6	2.7	2.8
W	4.2	4.3	4.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

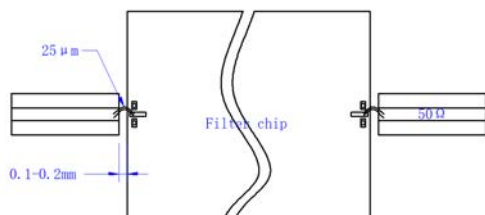
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5500	~	5700	MHz
中心损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	5.2&5.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.15&6.05	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-4.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.3-15.9	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.0ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



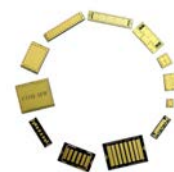
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

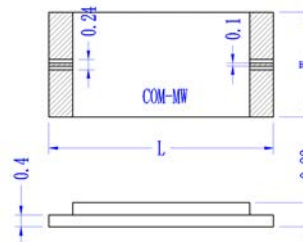
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

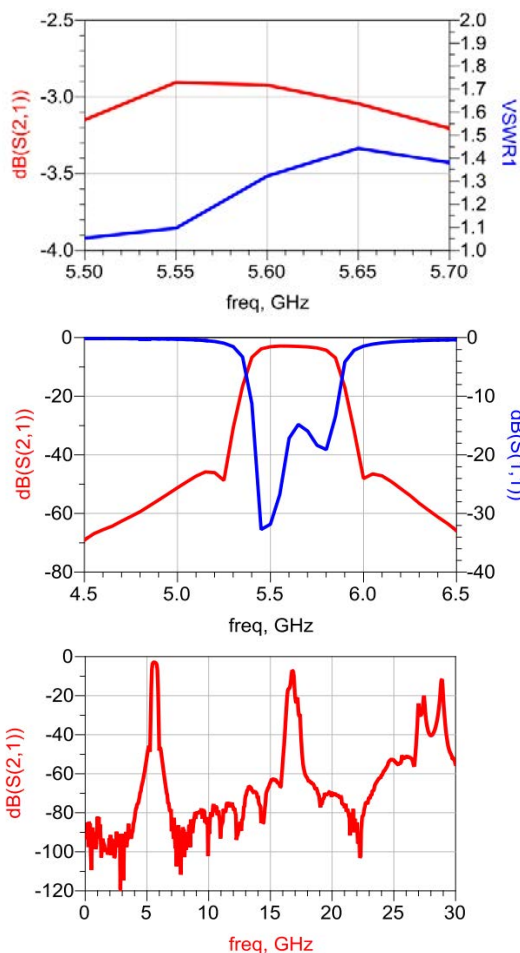


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.9	8	8.1
W	5.4	5.5	5.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

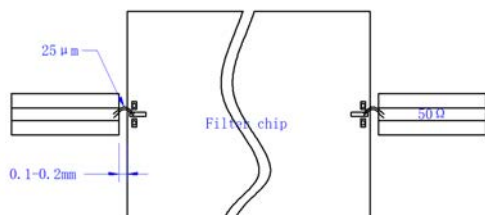
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5700	~	5900	MHz
中心损耗	/	/			4.5	dB
带内波动	/	/			1.4	dB
带外抑制	5.4&6.15	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.35&6.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.25	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.3-16.4	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



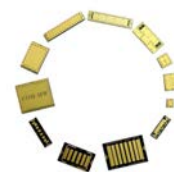
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

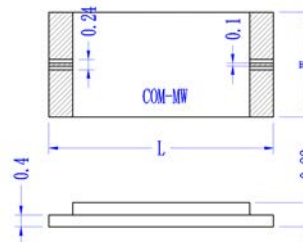
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

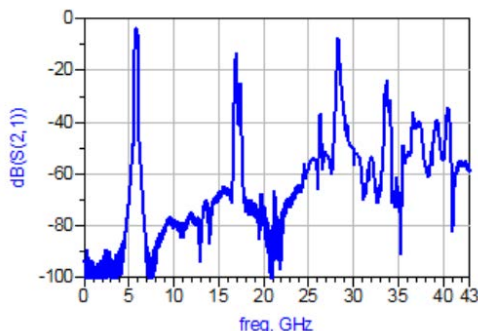
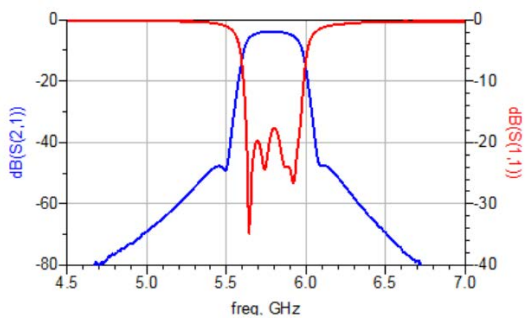
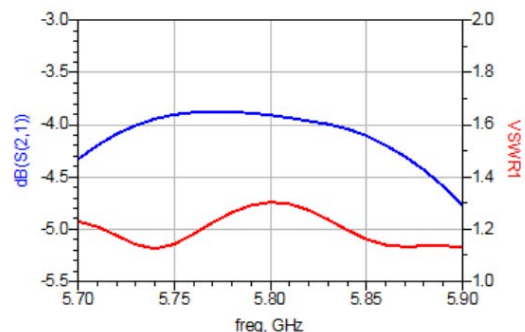


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.4	8.5	8.6
W	5.4	5.5	5.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

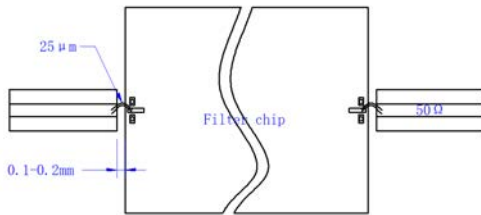
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5850	~	6150	MHz
中心损耗	/	/		6.0		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	5.5&6.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.4&6.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.2	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.85-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.2ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

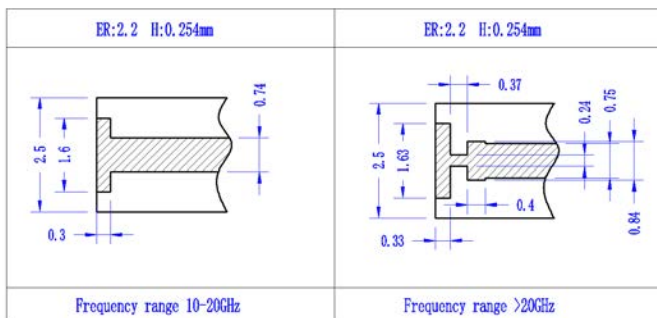
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

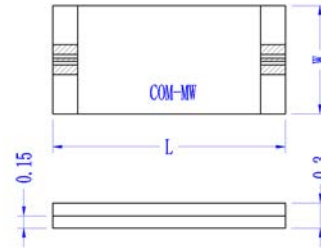
建议PCB布局图



参考实物图

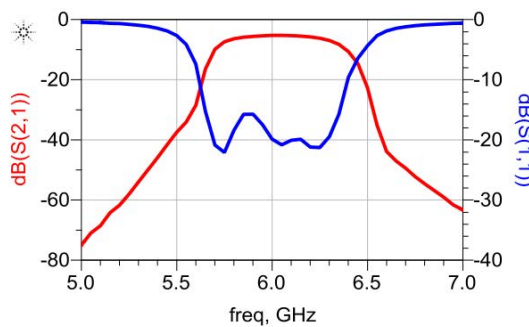
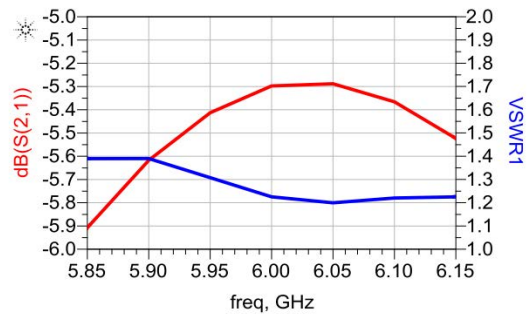


外形结构图 (mm)

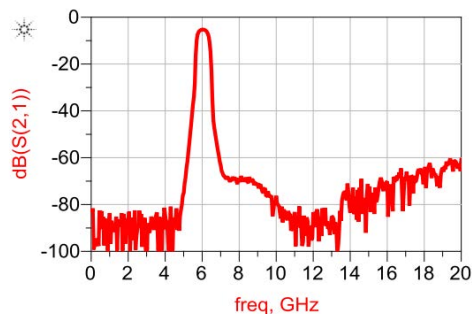


尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	5.4	5.5	5.6
W	4.0	4.1	4.2

典型测试曲线图



带外抑制&回波损耗



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

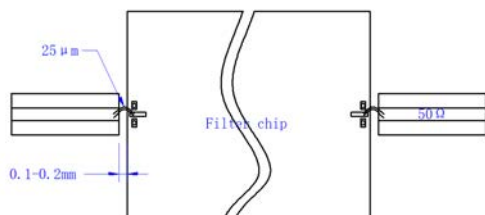
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5900	~	6100	MHz
中心损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	5.6&6.4	GHz≥	20			dB
带外抑制	5.55&6.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.3	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.7-17	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.0ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



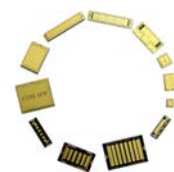
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

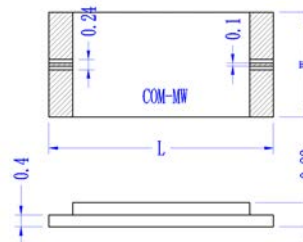
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

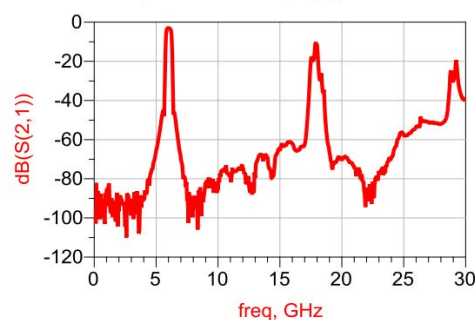
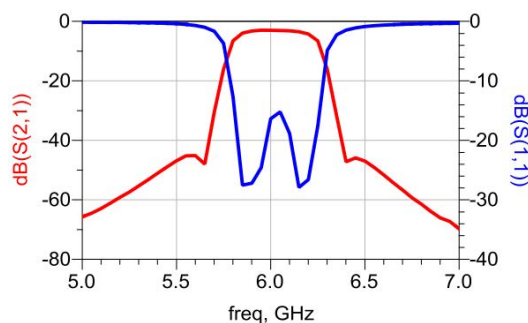
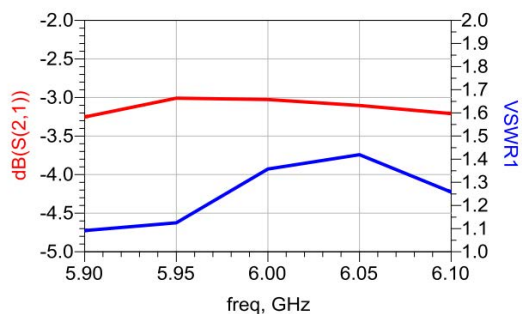


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.9	8	8.1
W	5.1	5.2	5.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

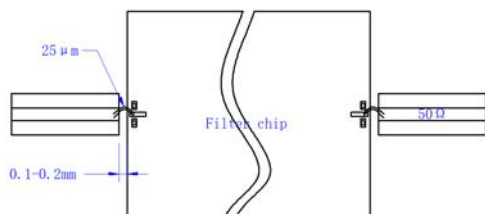
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5900	~	6100	MHz
中心损耗	/	/		9.4		dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	5.65&6.4	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.6&6.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.45	GHz≥	50			dB
带外抑制	6.5-28	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

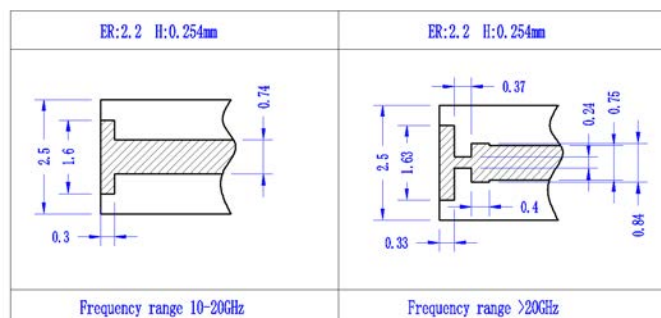
装配示意图



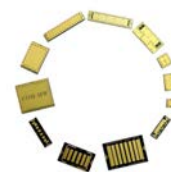
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

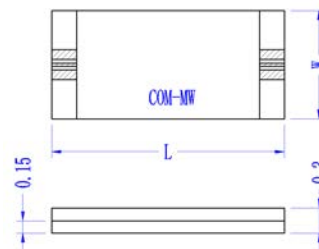
建议PCB布局图



参考实物图

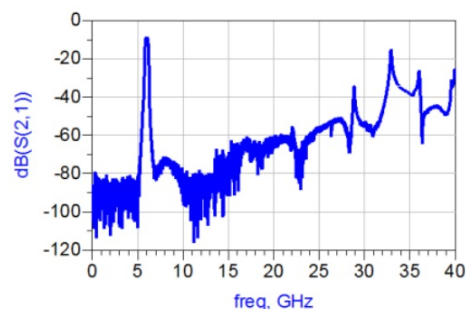
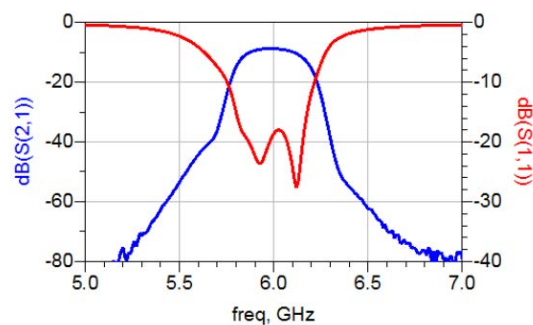
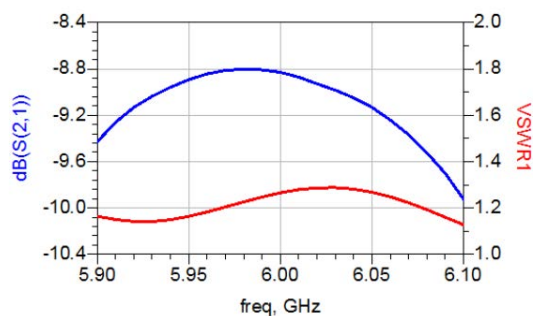


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	5.9	6.0	6.1
W	4.0	4.1	4.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

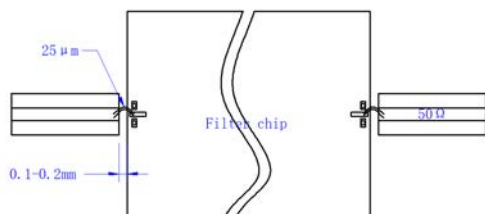
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6000	~	7000	MHz
中心损耗	/	/		3.0		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	5.2&7.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	4.95&7.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-4.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	8.05-18.3	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

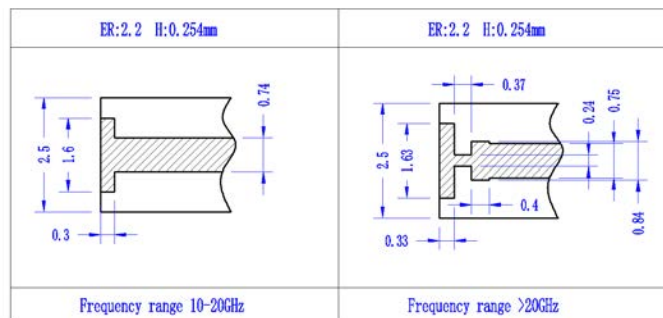
装配示意图



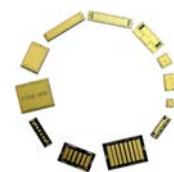
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

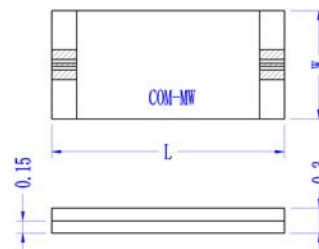
建议PCB布局图



参考实物图

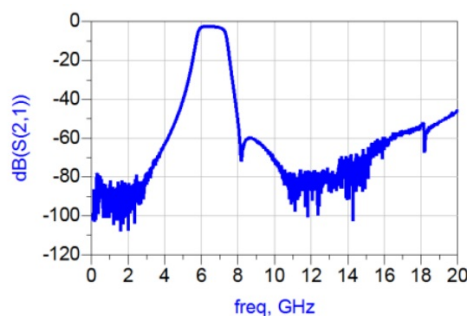
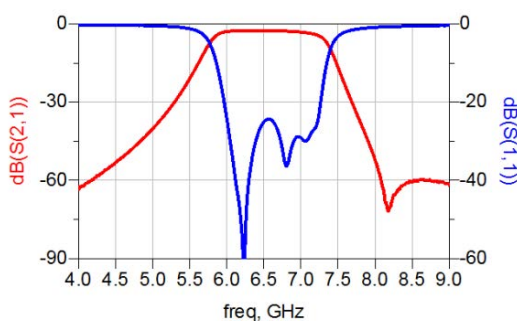
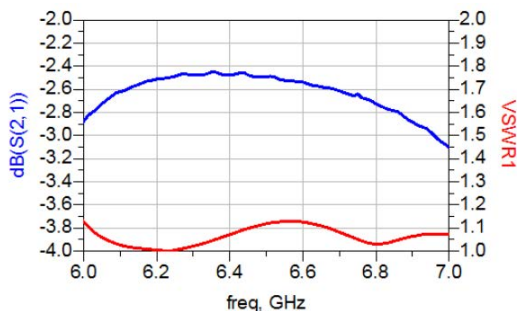


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	4.0	4.1	4.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

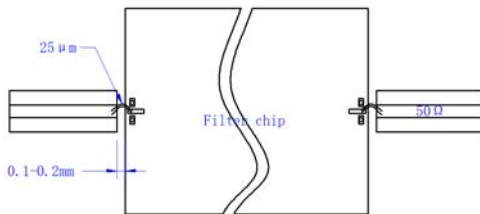
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6000	~	8000	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	5.1&8.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	4.9&8.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-4.75	GHz≥	50			dB
带外抑制	9.2-13.5	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.4ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

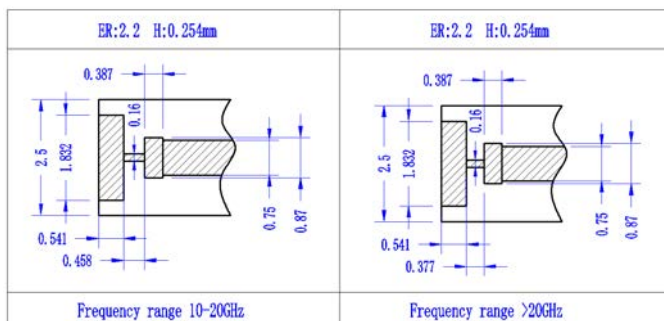
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

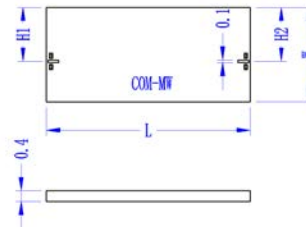
建议PCB布局图



参考实物图

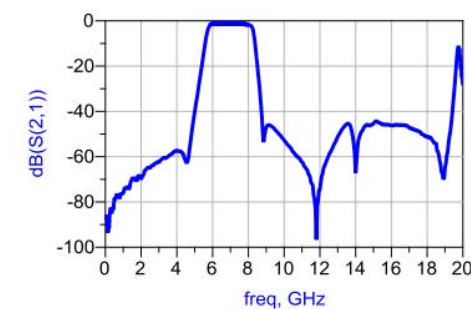
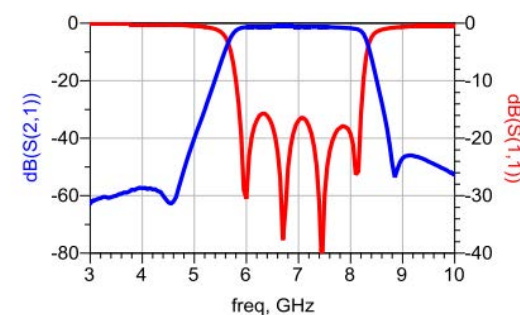
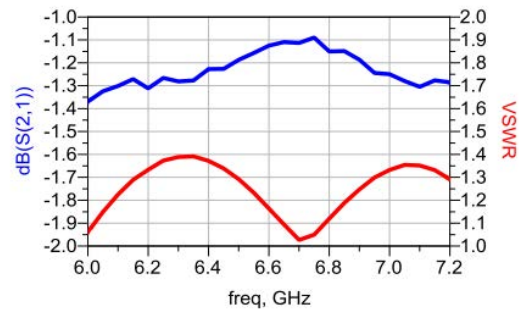


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.05	8.15	8.25
W	5.3	5.4	5.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

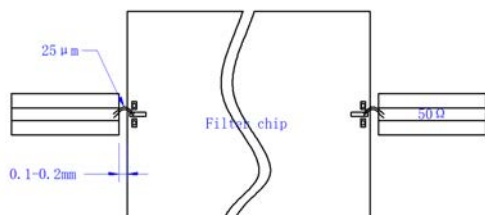
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6300	~	6500	MHz
中心损耗	/	/			3.2	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	6.0&6.75	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.95&6.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	7.05-17.9	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.1ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



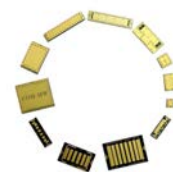
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

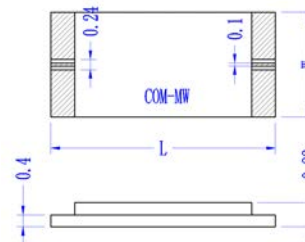
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

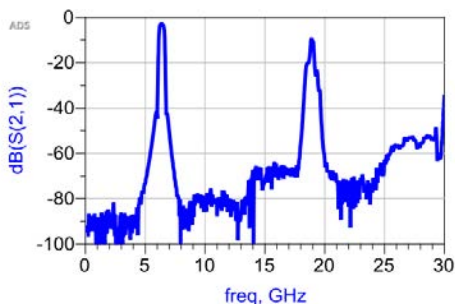
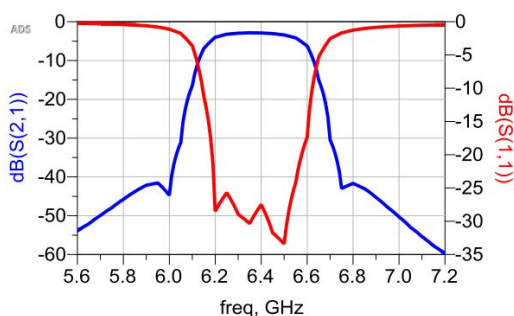
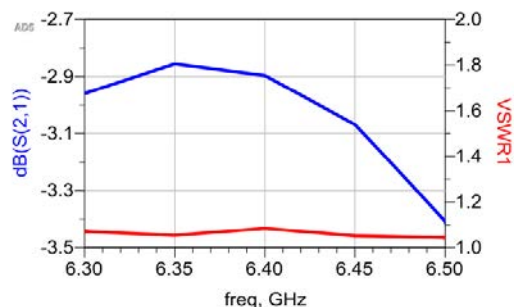


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.9	8.0	8.1
W	4.9	5.0	5.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

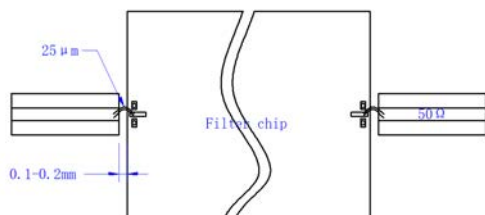
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6700	~	6900	MHz
中心损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	6.4&7.15	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	6.35&7.2	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-6.1	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	7.4-19.1	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤ 0.15 ns
相位一致性	$\leq \pm 5^\circ$
工作温度	-55~+85 $^\circ$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^\circ$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



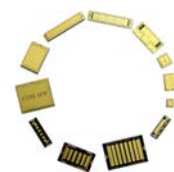
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥ 3 mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/ $^\circ$ C)相当的载体上, 载体厚度 ≥ 0.2 mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

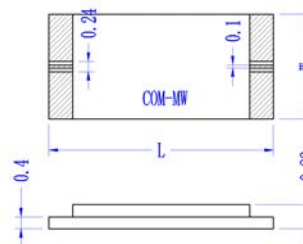
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

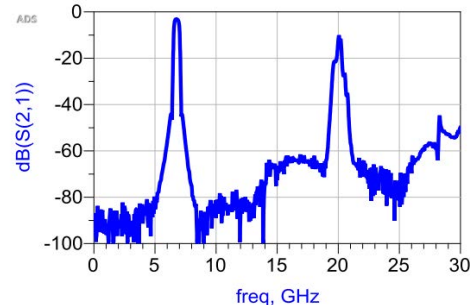
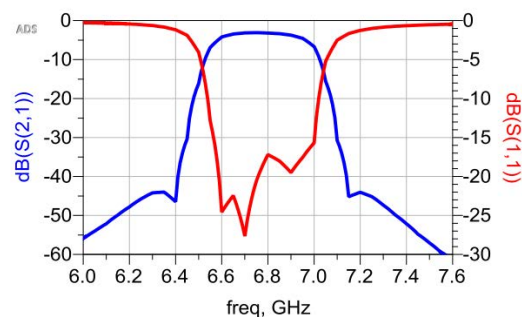
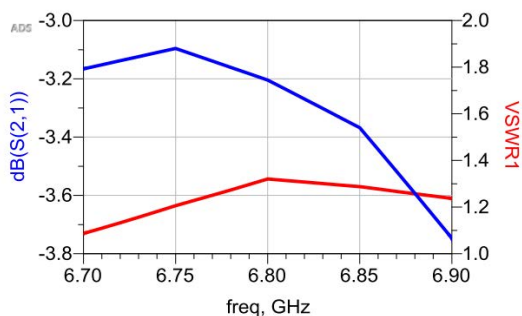


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.4	7.5	7.6
W	4.8	4.9	5.0

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

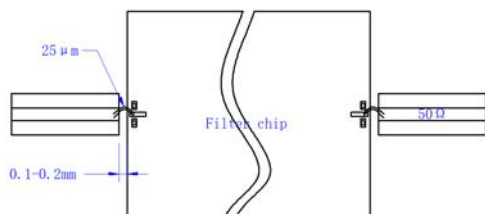
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6700	~	6900	MHz
中心损耗	/	/		7.5		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	6.25&7.35	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.2&7.4	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.15	GHz≥	50			dB
带外抑制	7.45-20.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



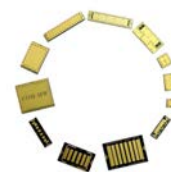
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

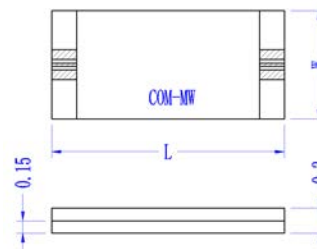
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

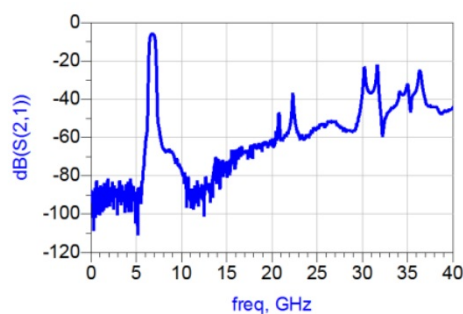
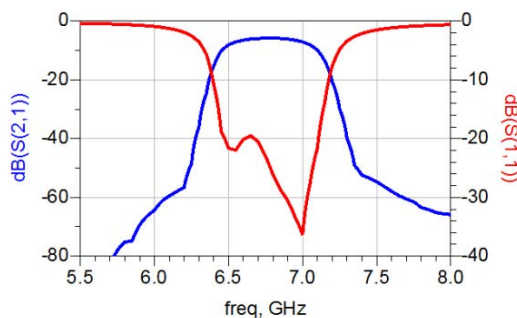
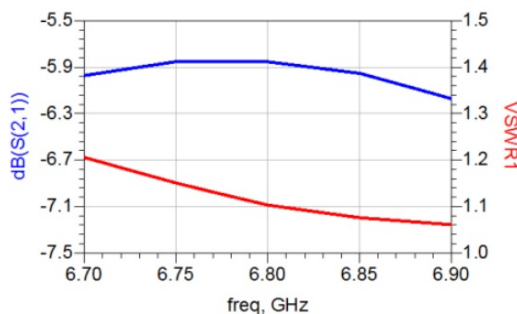


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.9	5.0	5.1
W	4.0	4.1	4.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

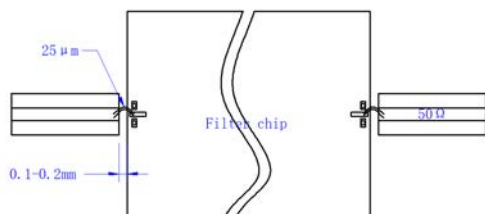
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7500	~	8500	MHz
中心损耗	/	/		3.1		dB
带内波动	/	/			1.4	dB
带外抑制	6.9&9.25	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.3&9.35	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	9.9-22.6	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



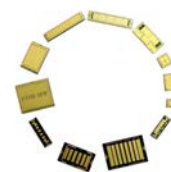
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

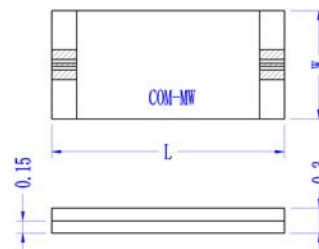
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

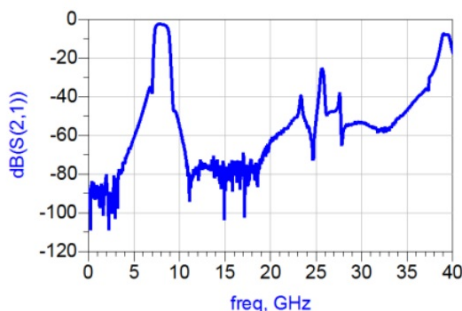
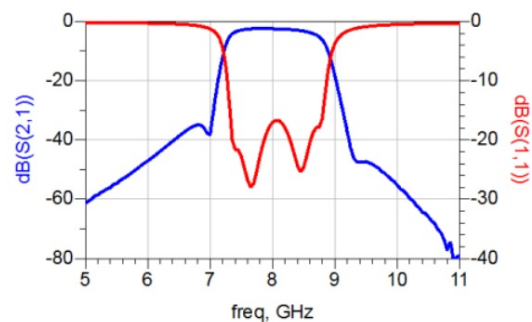
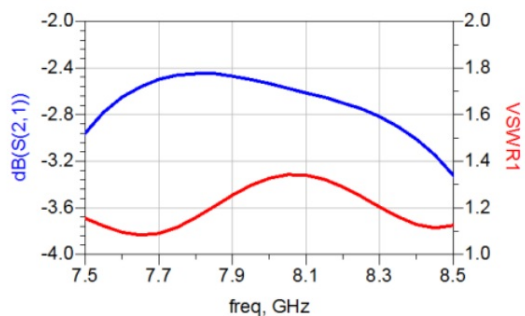


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	3.1	3.2	3.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

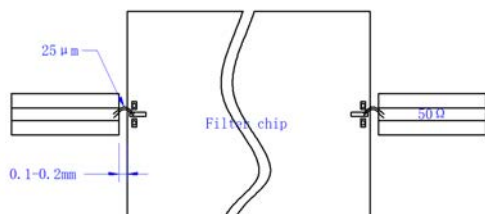
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7800	~	8200	MHz
中心损耗	/	/			6.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.2&8.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.15&8.85	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.1	GHz≥	50			dB
带外抑制	8.95-23.7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.8ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

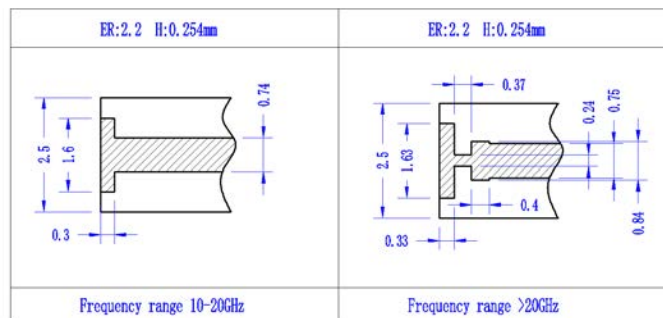
装配示意图



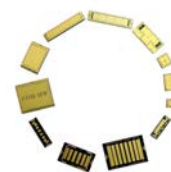
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

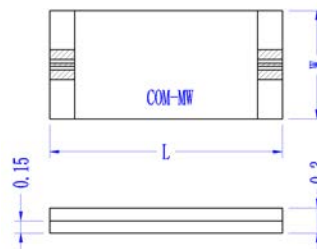
建议PCB布局图



参考实物图

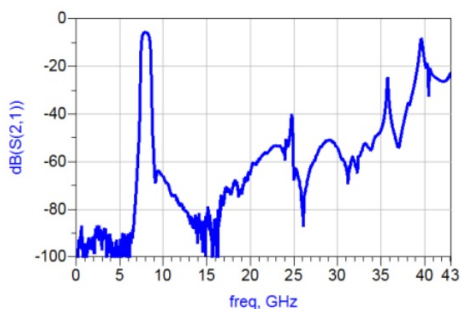
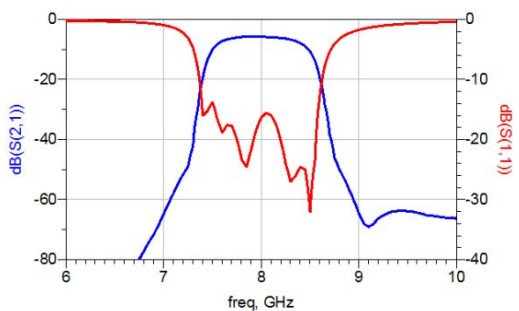
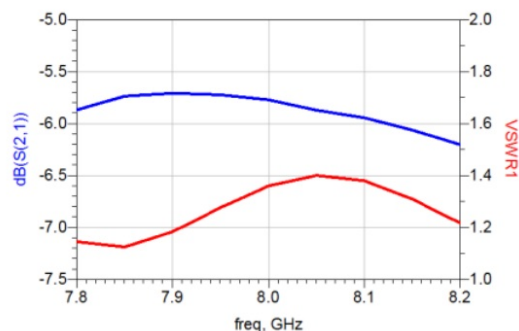


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.4	4.5	4.6
W	3.6	3.7	3.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

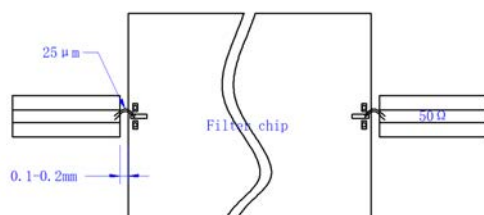
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7900	~	12100	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	6.6&13.35	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.1&13.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.7-30.4	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



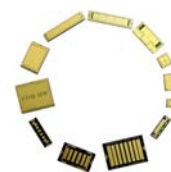
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

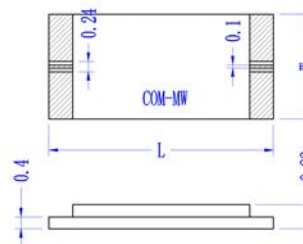
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

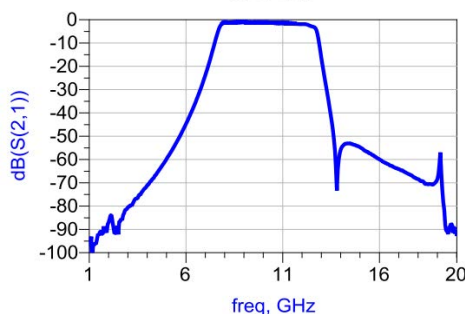
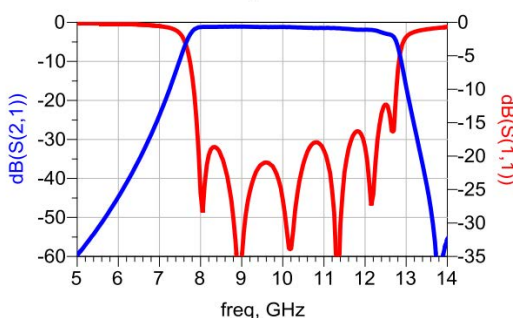
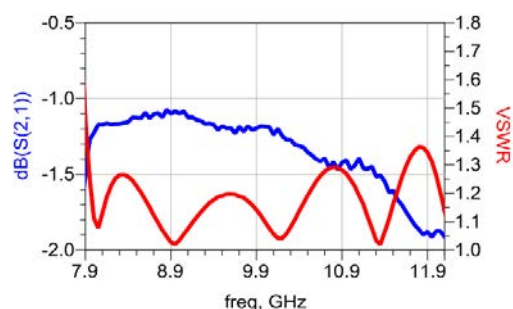


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	5.7	5.8	5.9
W	3.2	3.3	3.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

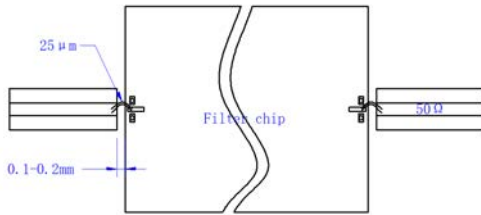
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7900	~	12100	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	6.65&13.4	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.3&13.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	14.1-25	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

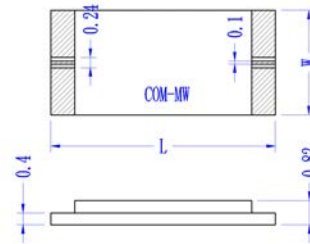
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

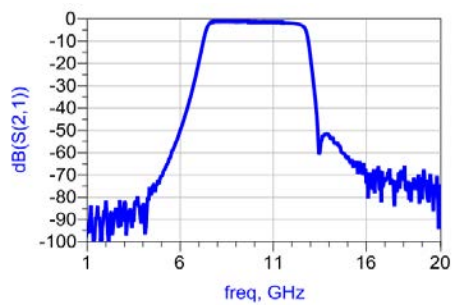
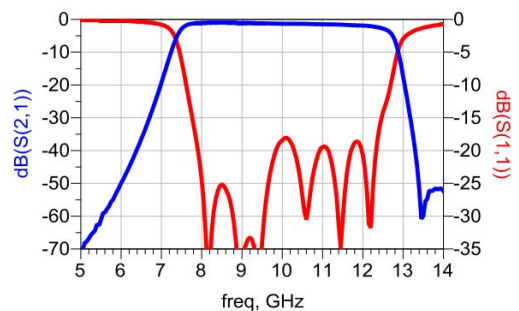
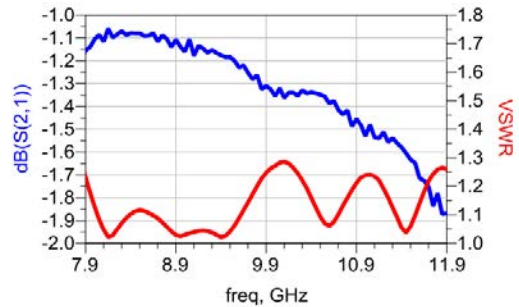


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.7	6.8	6.9
W	3.2	3.3	3.4

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

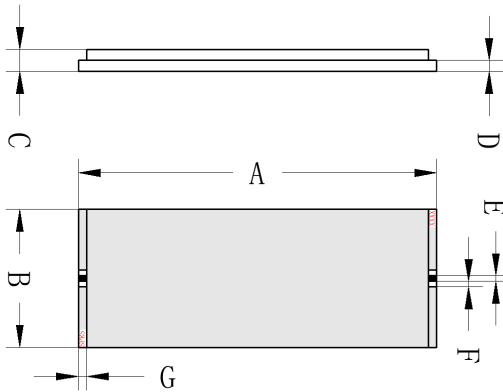
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.3	GHz
工作带宽	8.0-8.6	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	40@DC-7.35GHz	dBc
带外抑制	40@9.3-20.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.6, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.69

外形图：端口居中



推荐装配图

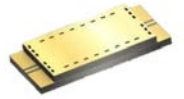


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

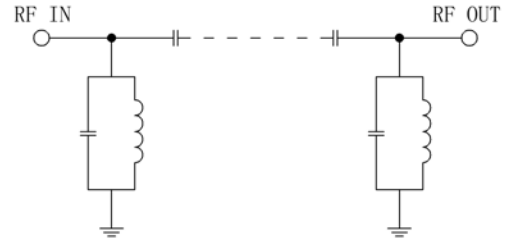
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

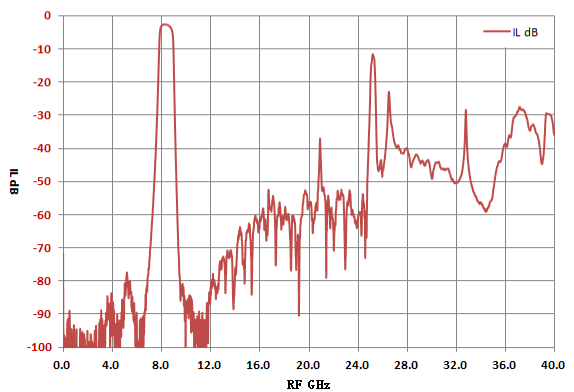
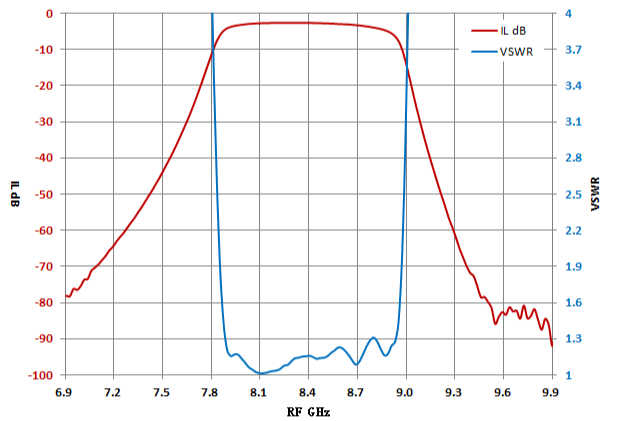
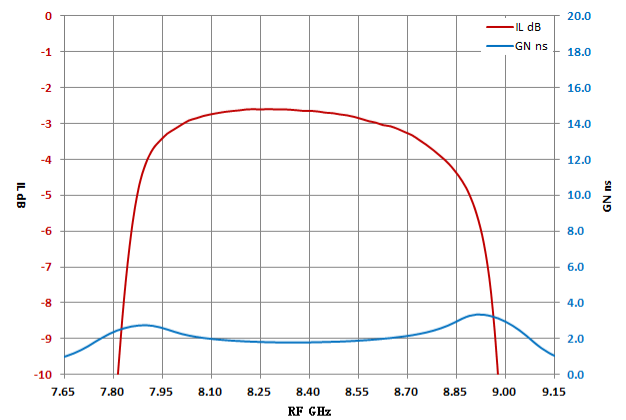
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

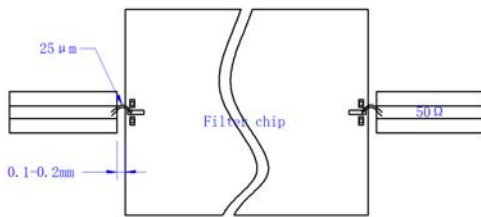
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	9000	MHz
中心损耗	/	/		3.0		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.3&9.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.2&10.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	10.3-21	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

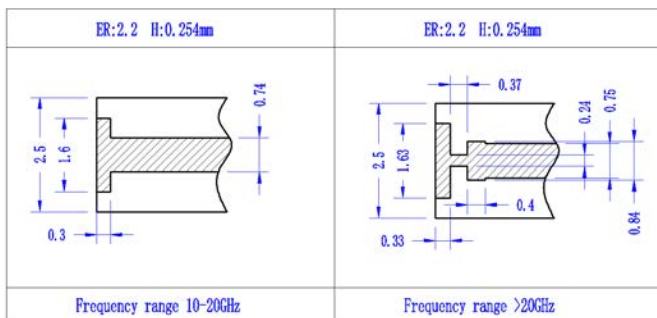
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

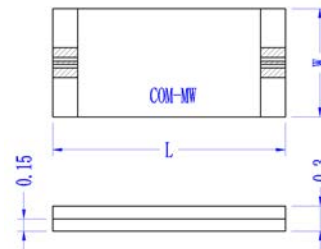
建议PCB布局图



参考实物图

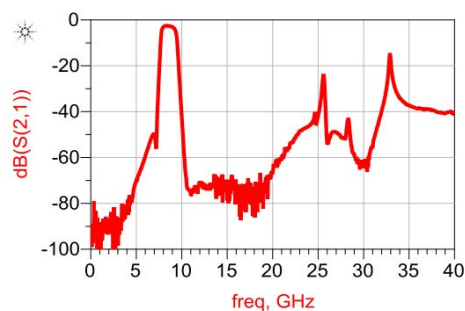
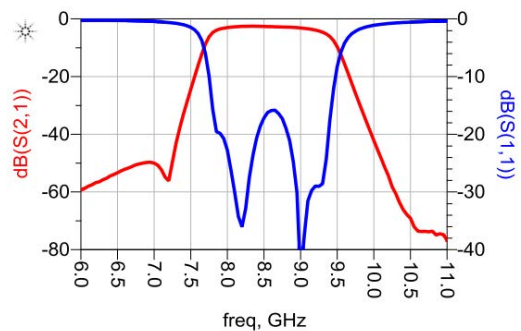
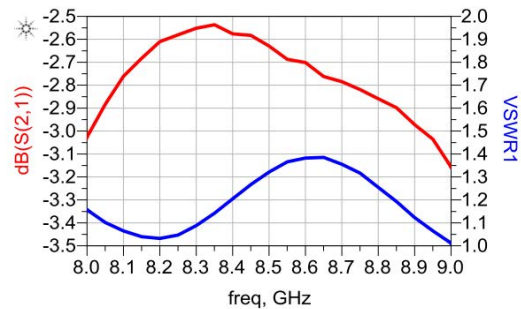


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

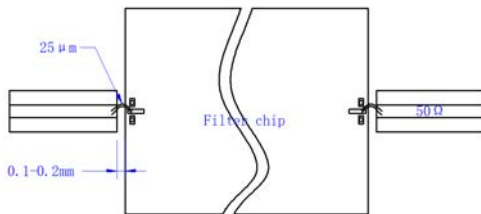
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	9600	MHz
中心损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.0&10.3	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	6.75&10.45	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-6.55	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	10.6-15.2	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤ 0.5 ns
相位一致性	$\leq \pm 5^\circ$
工作温度	-55~+85 $^\circ$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^\circ$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

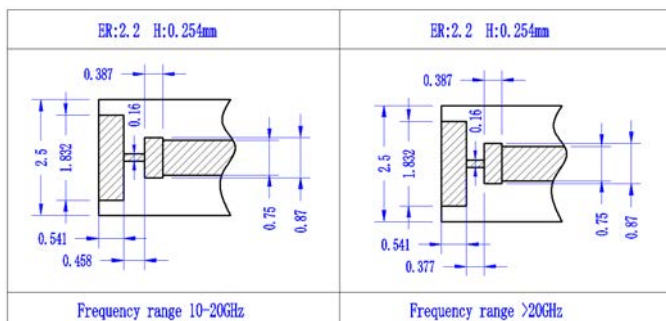
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥ 3 mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/ $^\circ$ C)相当的载体上, 载体厚度 ≥ 0.2 mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

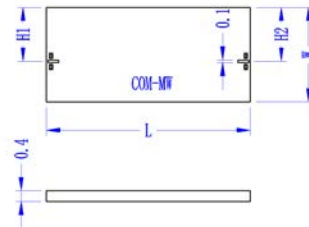
建议PCB布局图



参考实物图

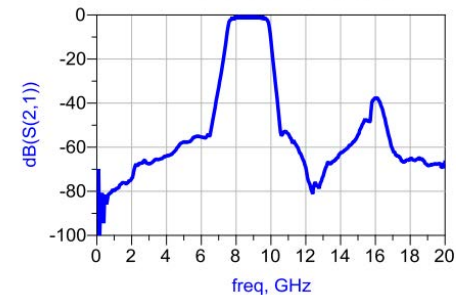
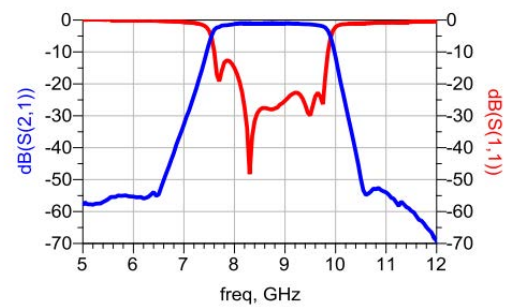
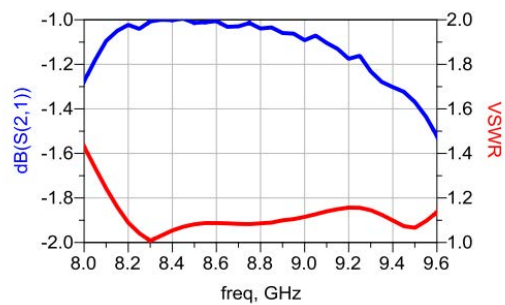


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.8	7.9	8
W	4.5	4.6	4.7
H1		2.4	
H2		2.2	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

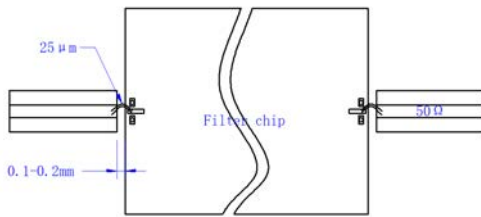
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	10800	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	7.2&11.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.9&11.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	12.3-25.1	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

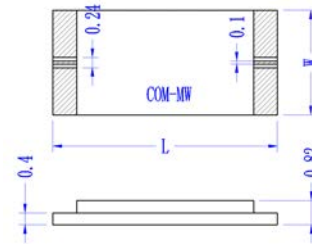
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

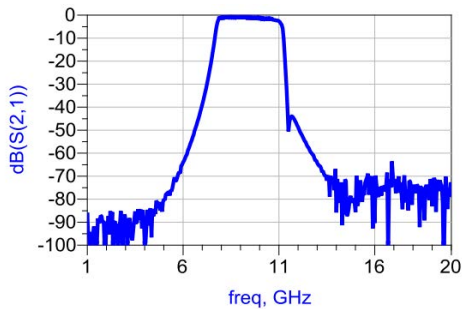
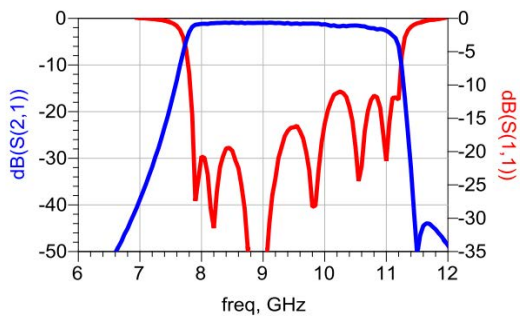
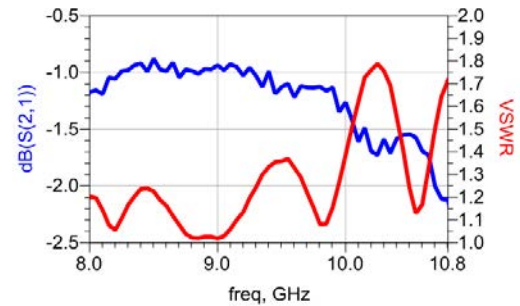


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.9	7.0	7.1
W	3.6	3.7	3.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

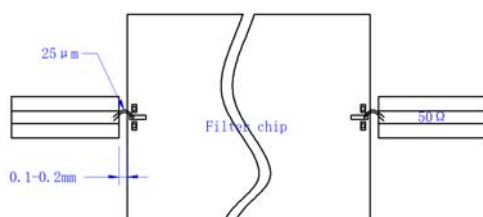
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	11500	MHz
中心损耗	/	/		3.0		dB
带内波动	/	/			2.2	dB
带外抑制	7.2&12.4	GHz≥	30			dB
带外抑制	6.95&12.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.05-21.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

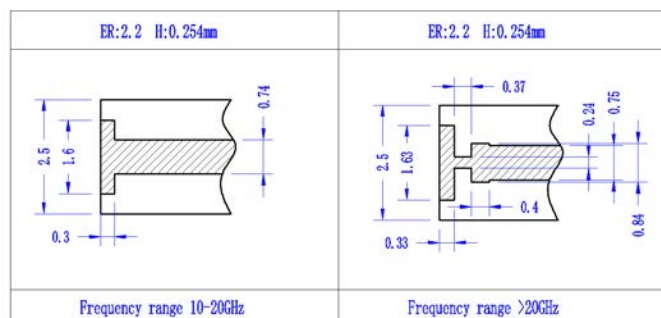
装配示意图



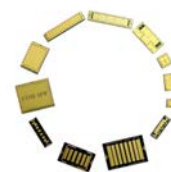
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

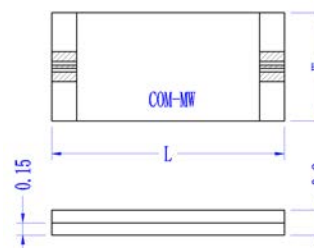
建议PCB布局图



参考实物图

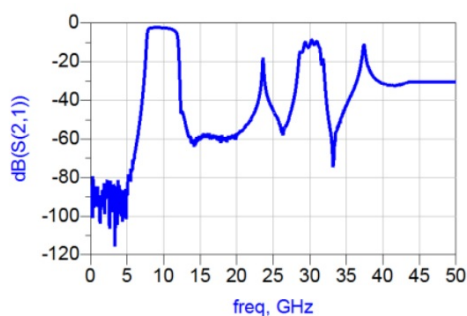
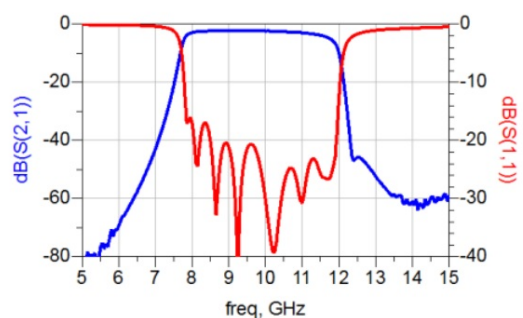
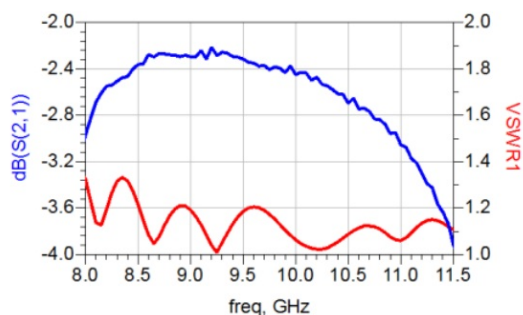


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	3.3	3.4	3.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

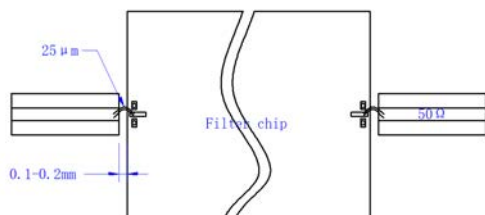
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	12000	MHz
中心损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	6.45&13.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	5.8&13.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-5.0	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.7-17.6	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



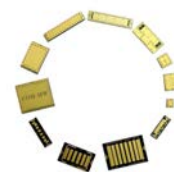
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

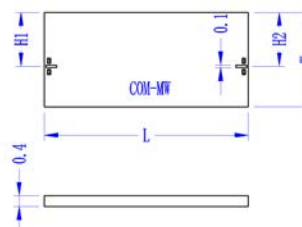
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

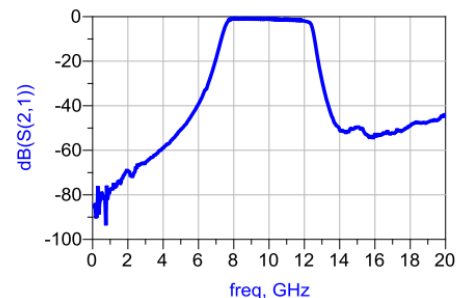
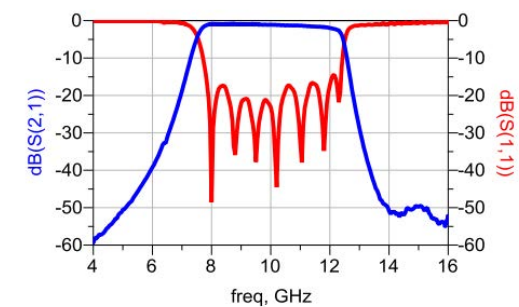
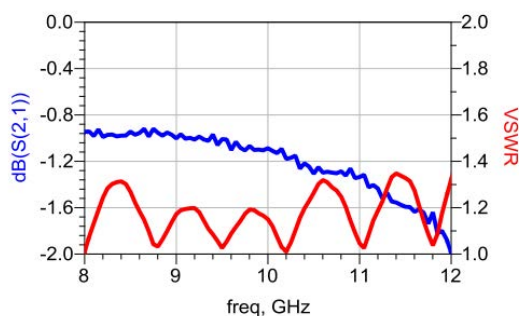


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.9	9	9.1
W	3.3	3.4	3.5
H1		1.5	
H2		1.5	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

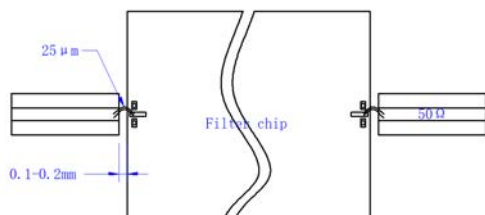
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	12000	MHz
中心损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	7.6&12.9	GHz≥	20			dB
带外抑制	6.45&14.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.0-25.2	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.2ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



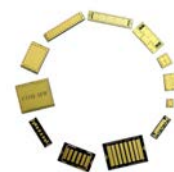
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

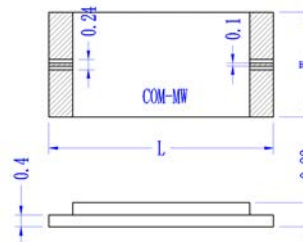
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

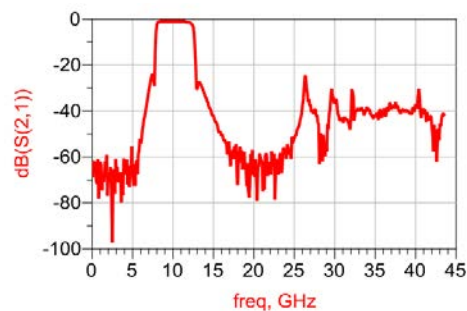
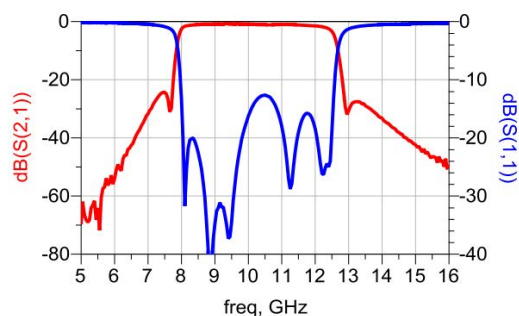
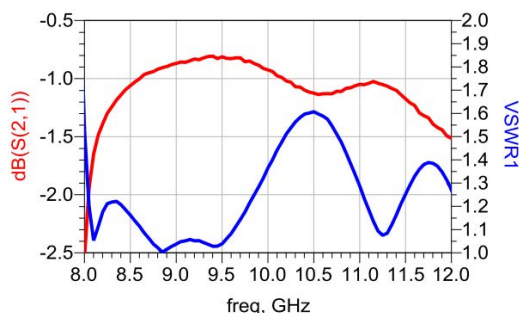


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.5	6.6	6.7
W	3.2	3.3	3.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

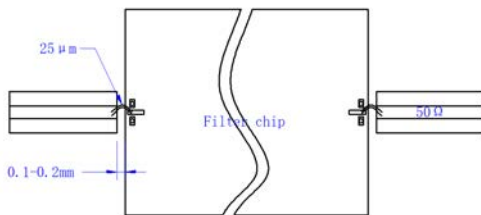
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	12000	MHz
中心损耗	/	/		2.7		dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	7.1&13.45	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	6.85&13.65	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-6.5	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	13.85-22	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	$\leq$ 0.6ns
相位一致性	$\leq$ 5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 $\geq$ 3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 $\geq$ 0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用50 μ m $\times$ 10 μ m的金带或2根25 μ m的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

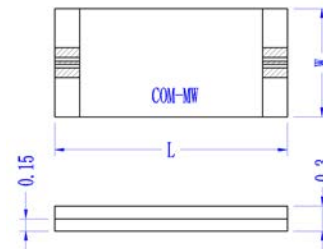
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

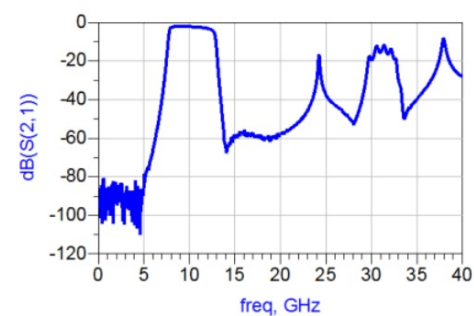
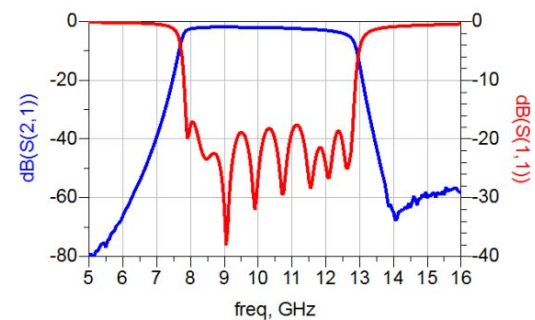
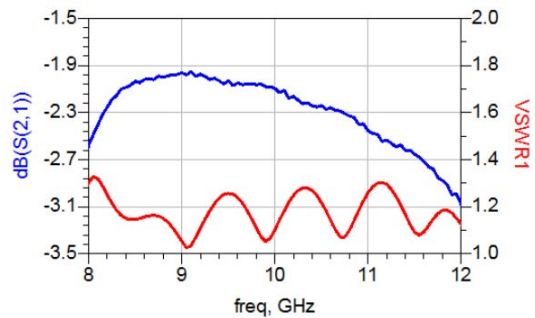


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	3.0	3.1	3.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

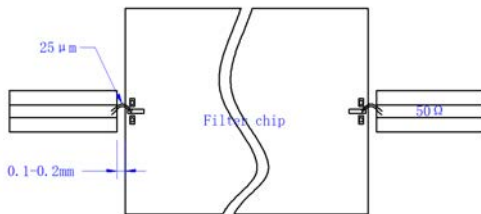
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8500	~	9900	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.4&10.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.15&10.75	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	10.9-15.4	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

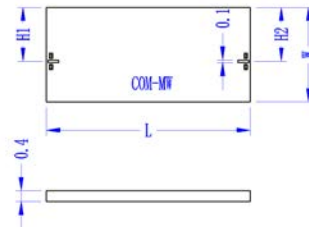
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

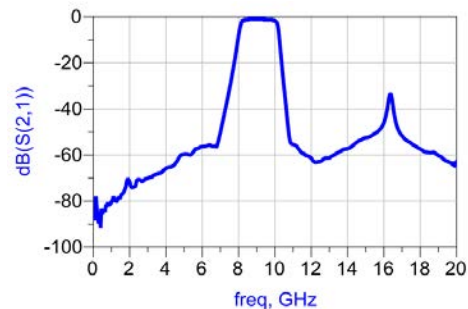
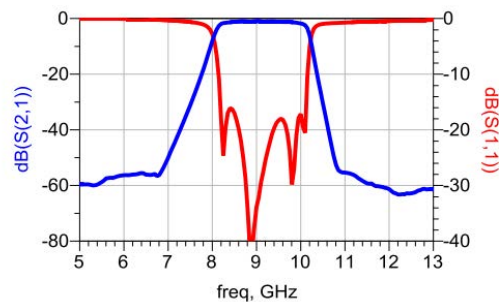
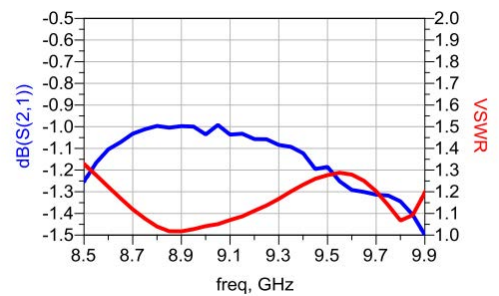


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.9	8.0	8.1
W	4.4	4.5	4.6
H1		2.25	
H2		2.25	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

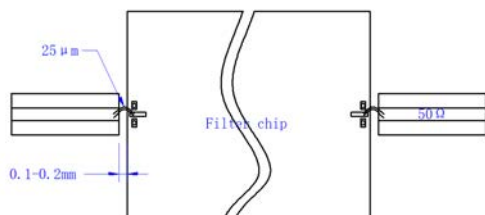
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8500	~	10500	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	7.9&11.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.7&11.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.45	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.3-27	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤1.0ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



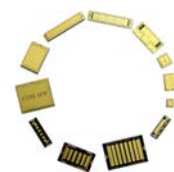
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

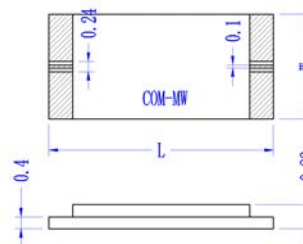
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

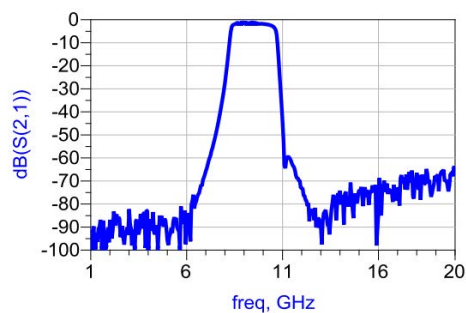
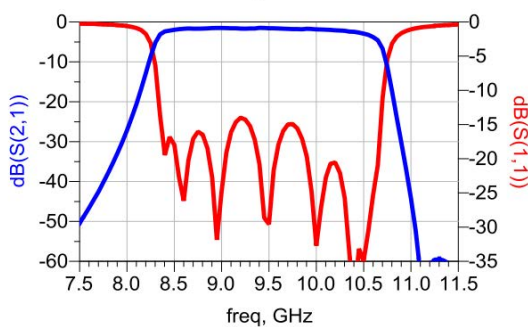
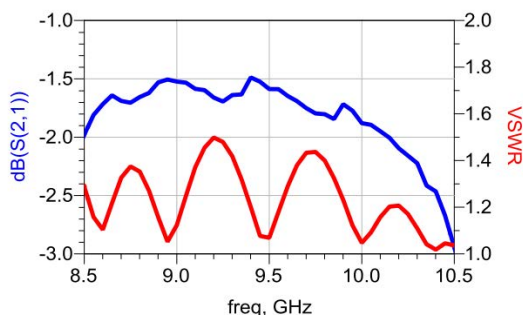


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.2	7.2	7.4
W	3.7	3.8	3.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

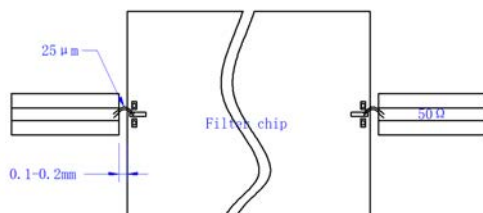
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8600	~	10500	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.7&11.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.45&11.3	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.15	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.6-17	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



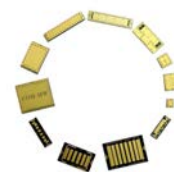
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

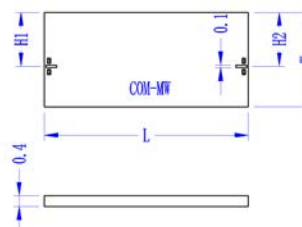
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

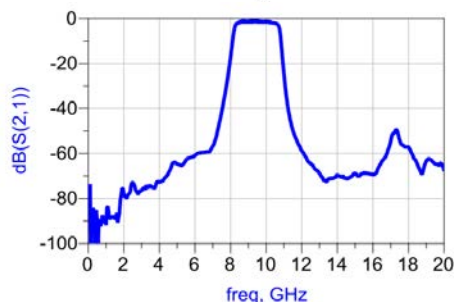
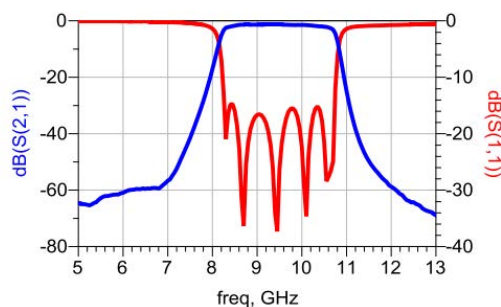
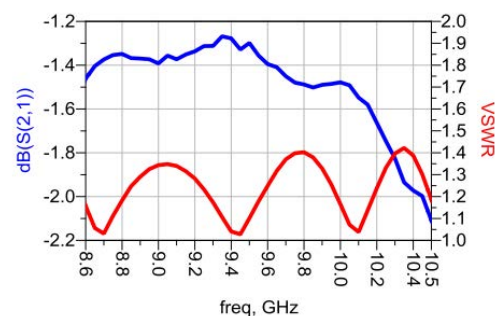


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	10.2	10.3	10.4
W	4.3	4.4	4.5
H1		2.2	
H2		2.2	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

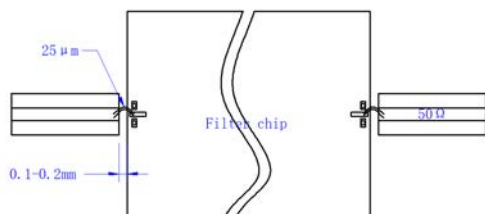
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8300	~	9300	MHz
中心损耗	/	/		3.7		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	7.4&10.2	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	7.35&10.3	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-6.85	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	10.45-25.5	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	$\leq$ 0.6ns
相位一致性	$\leq$ 5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

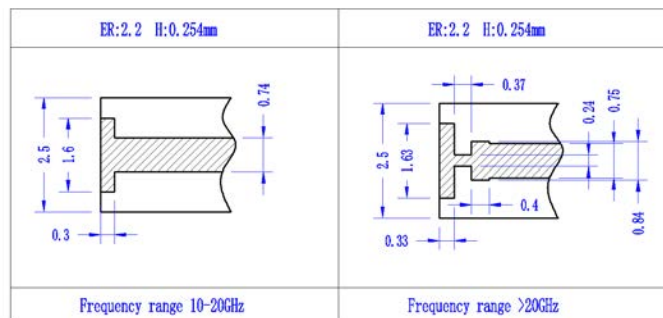
装配示意图



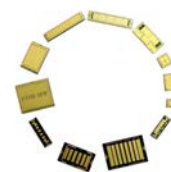
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 $\geq$ 3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 $\geq$ 0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

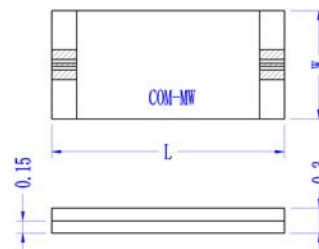
建议PCB布局图



参考实物图

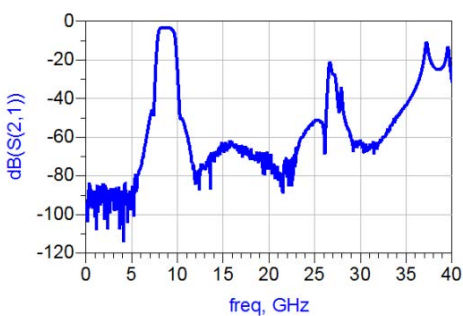
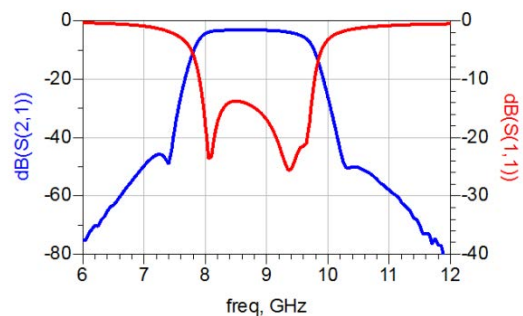
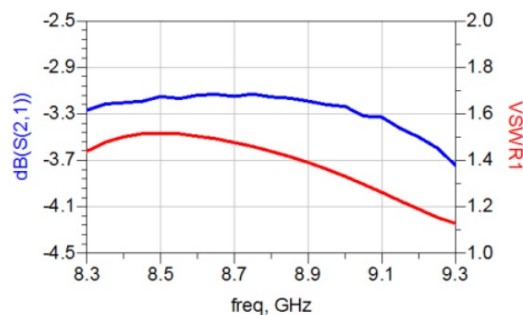


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	3.3	3.4	3.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

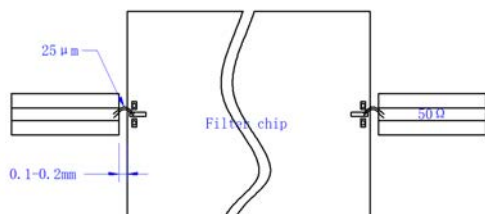
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8500	~	9500	MHz
中心损耗	/	/		3.3		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	7.85&10.35	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.1&10.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-6.45	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.15-23	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

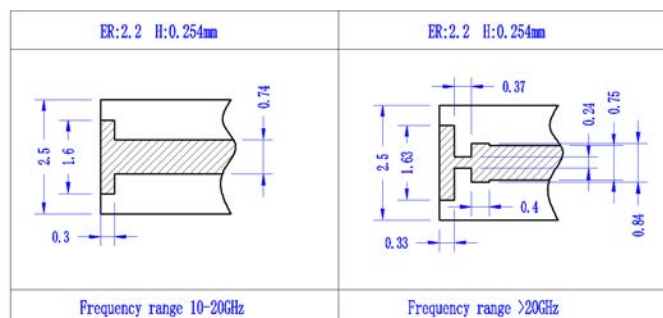
装配示意图



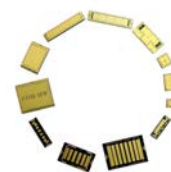
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

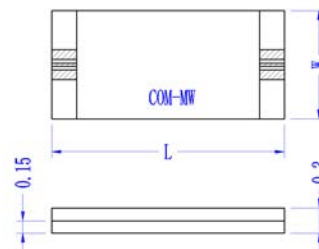
建议PCB布局图



参考实物图

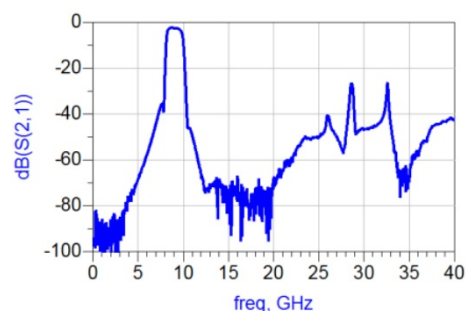
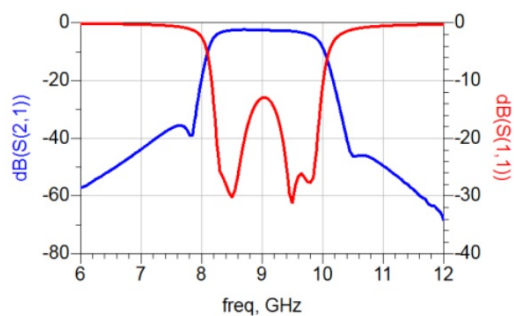
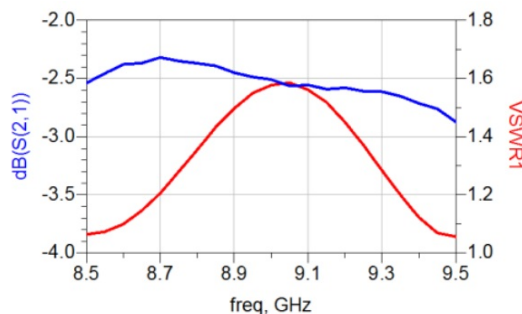


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.9	3.0	3.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

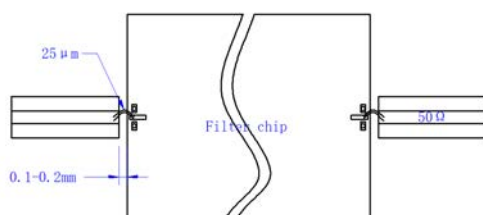
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8800	~	9200	MHz
中心损耗	/	/			6.5	dB
带内波动	/	/			0.9	dB
带外抑制	8.2&9.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.15&9.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8	GHz≥	50			dB
带外抑制	10.05-25	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

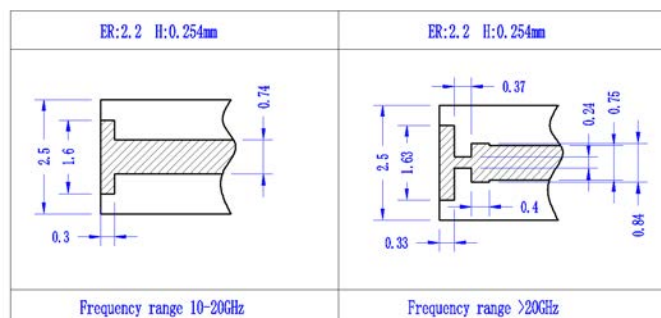
装配示意图



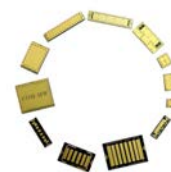
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

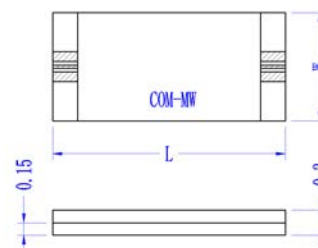
建议PCB布局图



参考实物图

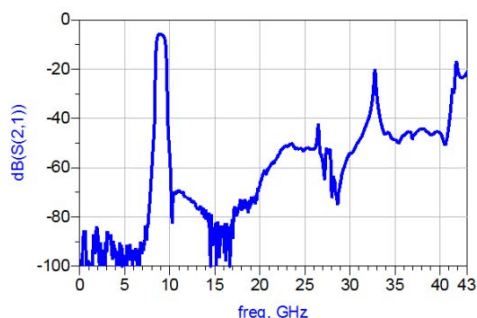
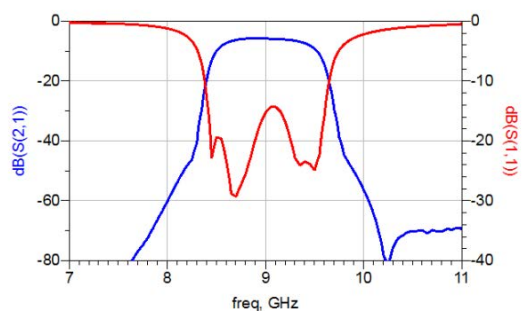
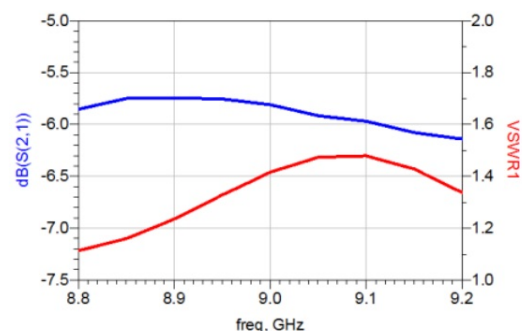


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.4	4.5	4.6
W	3.3	3.4	3.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

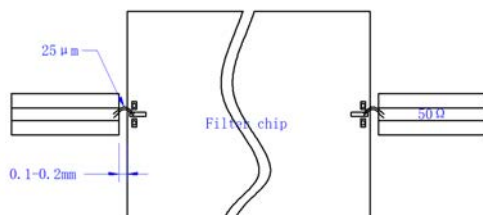
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8800	~	10200	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	8.0&10.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.8&11.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.35-16.2	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

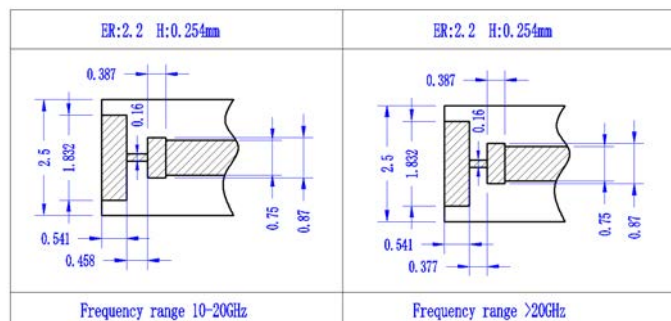
装配示意图



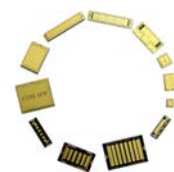
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

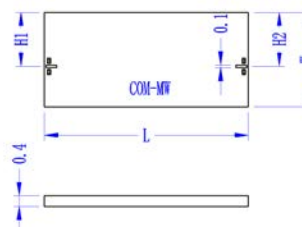
建议PCB布局图



参考实物图

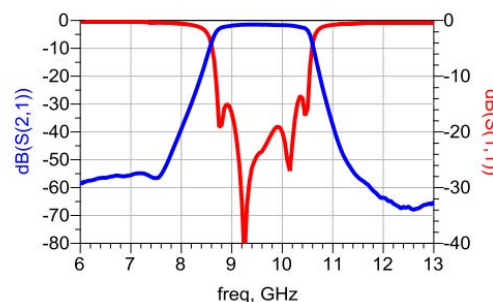
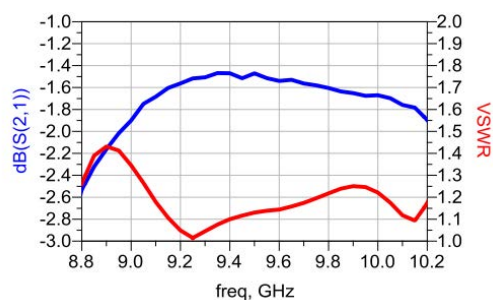


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.4	8.5	8.6
W	4.9	5.0	5.1
H1		2.56	
H2		2.44	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

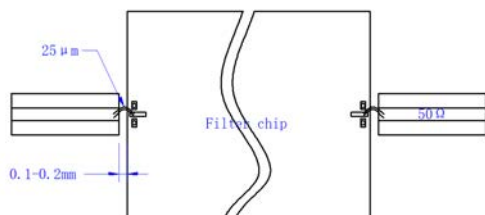
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8900	~	10100	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	8.1&10.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.85&10.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.4-26.3	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



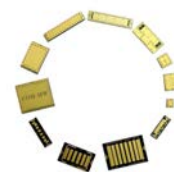
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

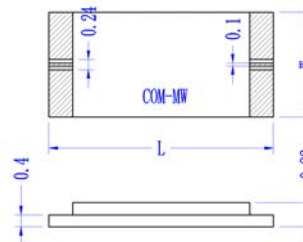
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

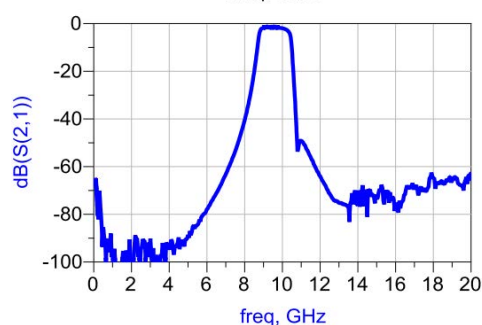
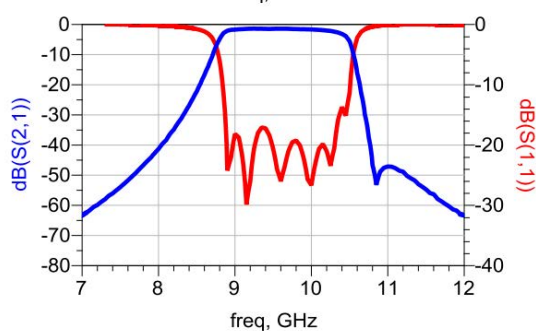
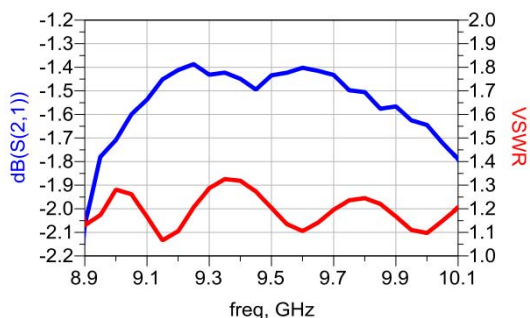


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.5	6.6	6.7
W	3.9	4.0	4.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

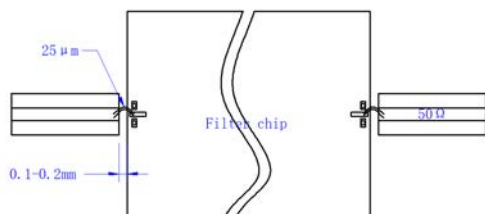
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9000	~	9500	MHz
中心损耗	/	/			7.3	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	8.55&10.0	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.45&10.05	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.35	GHz≥	50			dB
带外抑制	10.1-21	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	dBm
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



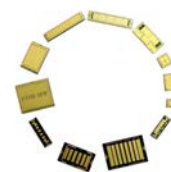
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;

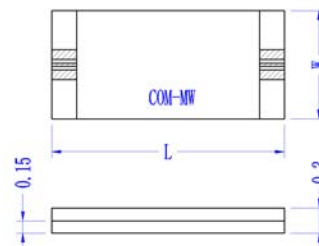
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm Frequency range 10-20GHz	ER:2.2 H:0.254mm Frequency range >20GHz
---	--

参考实物图

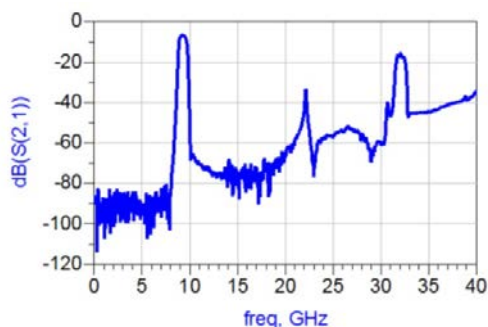
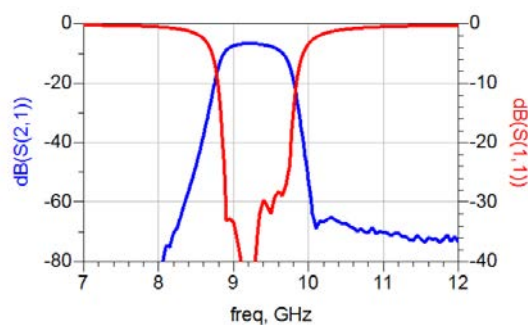
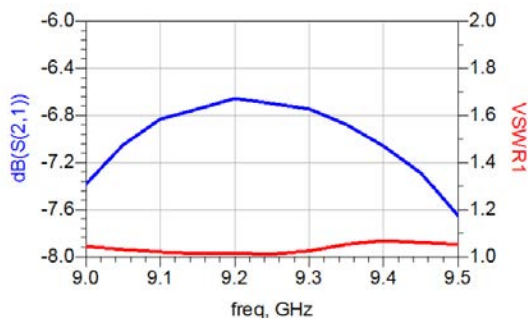


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.9	3.0	3.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

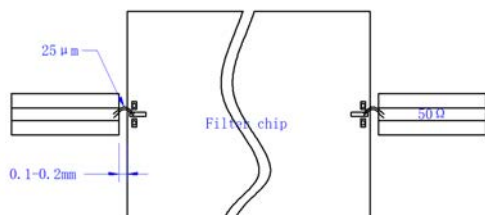
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9000	~	10000	MHz
中心损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	8&10.65	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.7&10.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.3	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.1-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



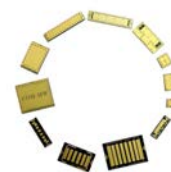
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

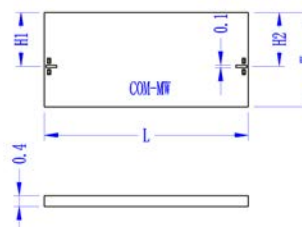
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

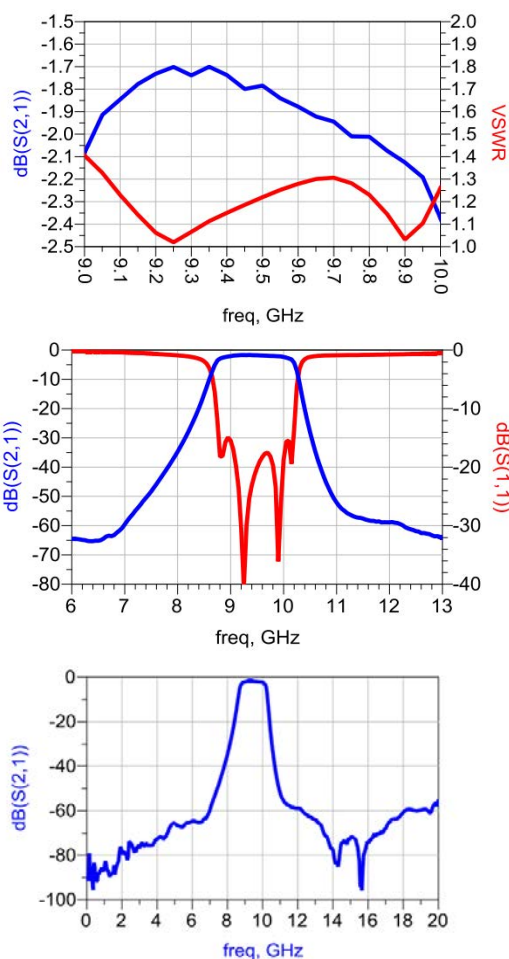


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	9.2	9.3	9.4
W	3.9	4.0	4.1
H1		2.0	
H2		2.0	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

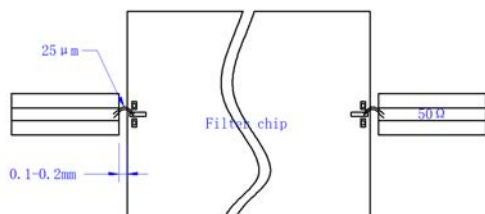
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	93500	~	11250	MHz
中心损耗	/	/		2.8		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	8.6&12.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.35&12.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.1	GHz≥	50			dB
带外抑制	12.75-22.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

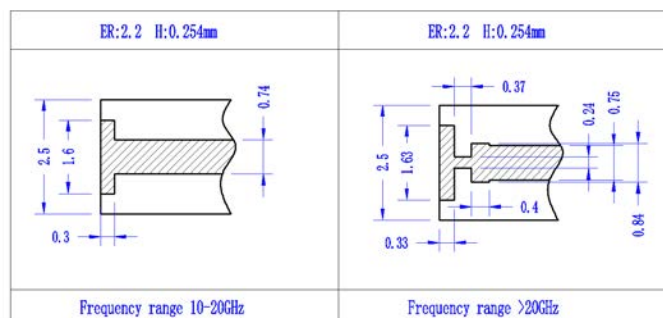
装配示意图



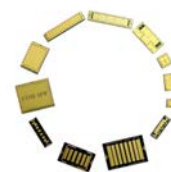
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

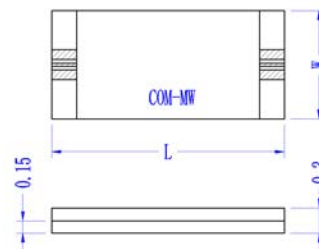
建议PCB布局图



参考实物图

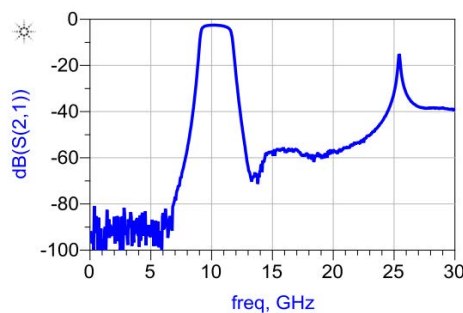
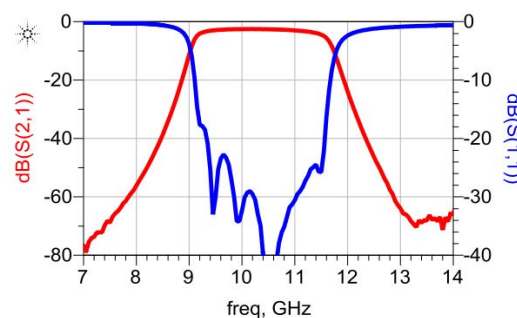
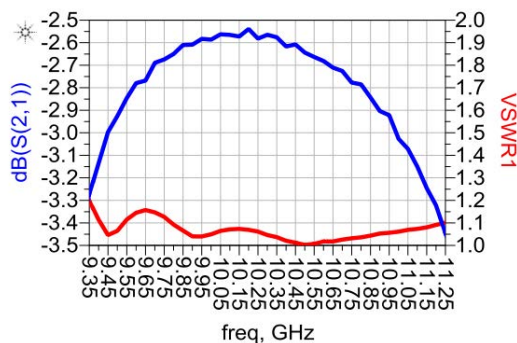


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3	3.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

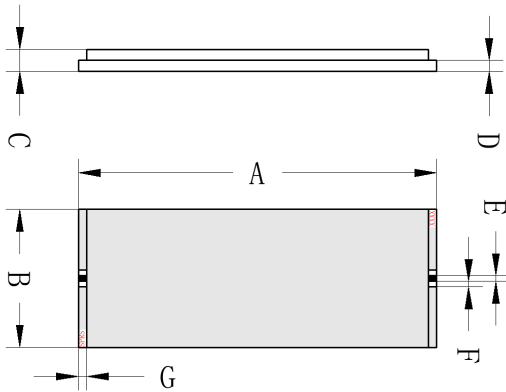
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	9.4-10.0	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-8.7GHz	dBc
带外抑制	40@10.7-26.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.3, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.55

外形图：端口居中



推荐装配图

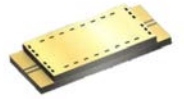


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

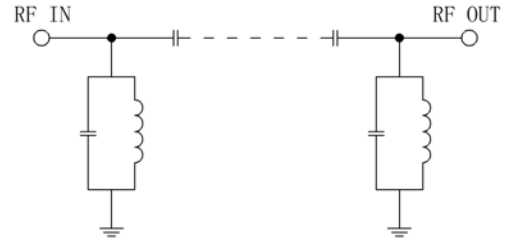
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

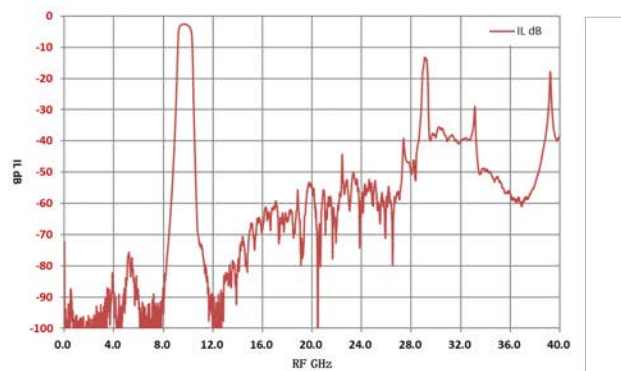
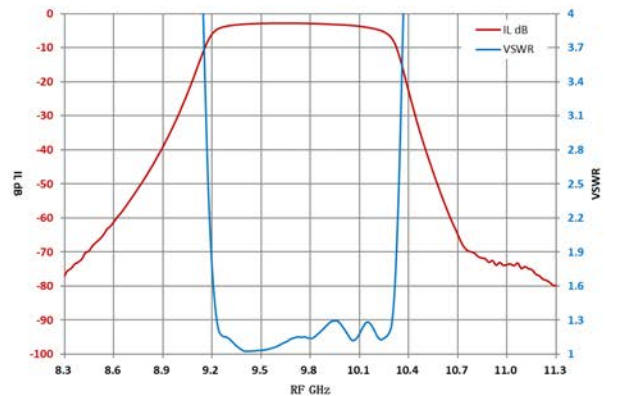
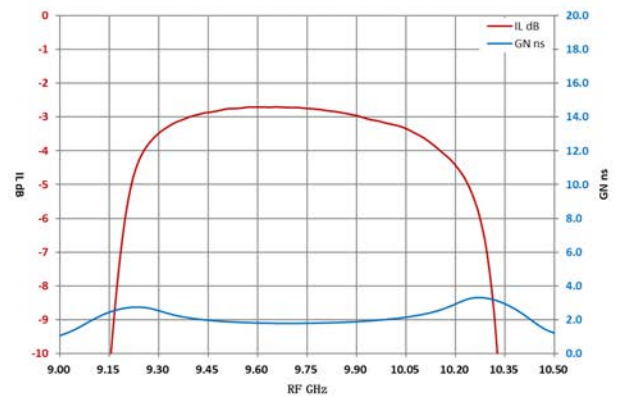
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

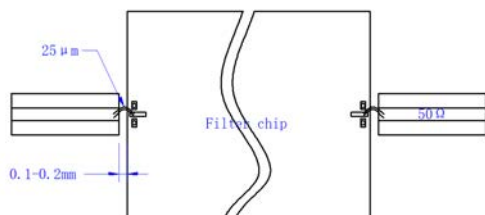
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9400	~	10900	MHz
中心损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	8.8&11.5	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.65&11.6	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.7-28.7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

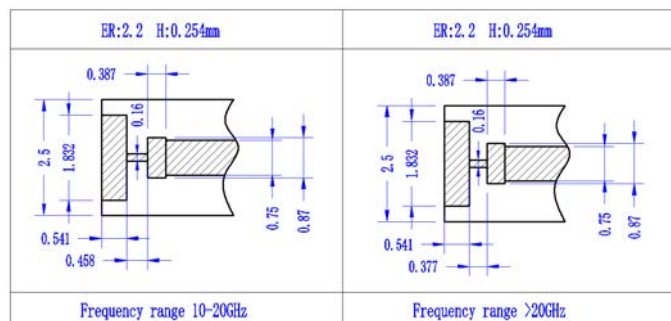
装配示意图



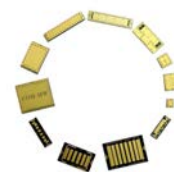
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

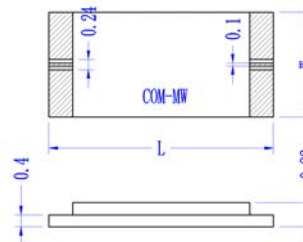
建议PCB布局图



参考实物图

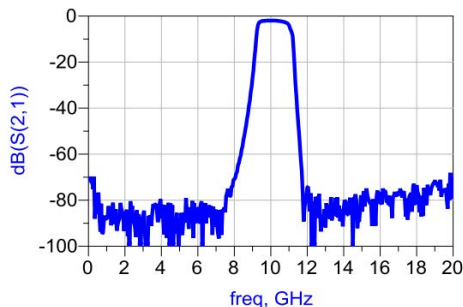
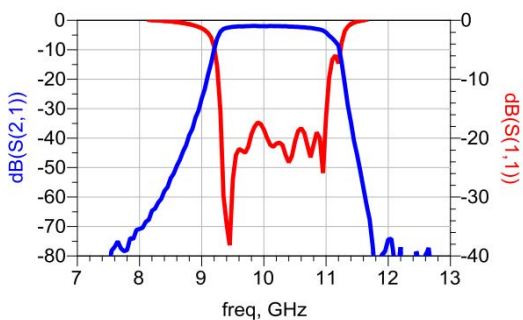
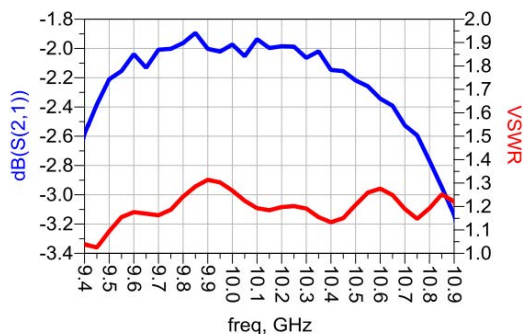


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.5	7.6	7.7
W	3.1	3.2	3.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

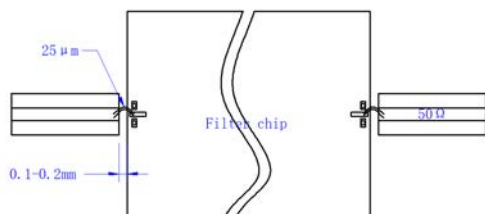
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9500	~	10000	MHz
中心损耗	/	/		7.4		dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	8.8&10.5	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.9&10.55	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-9.0	GHz≥	50			dB
带外抑制	10.6-21.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

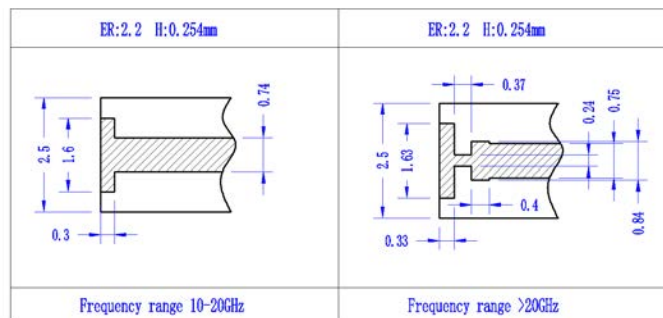
装配示意图



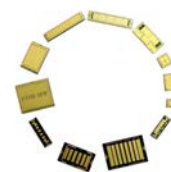
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

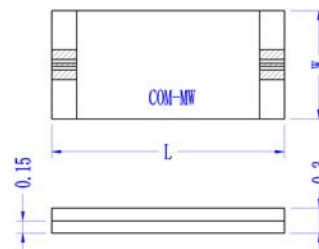
建议PCB布局图



参考实物图

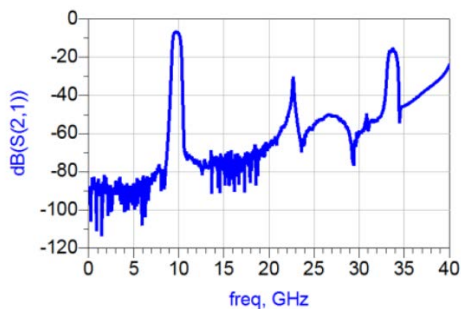
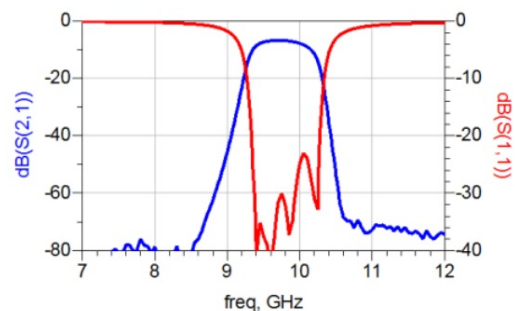
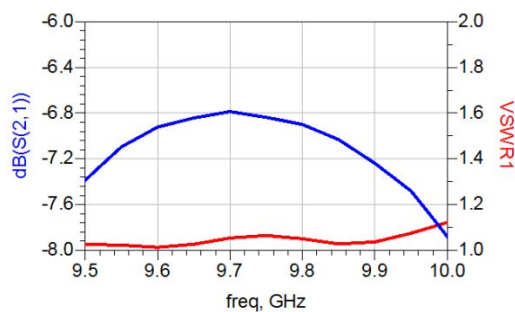


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.8	2.9	3.0

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

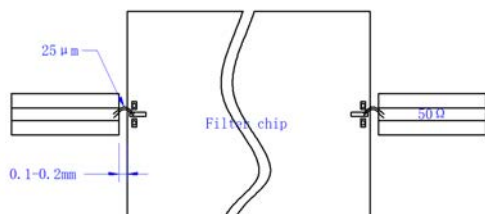
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9800	~	10200	MHz
中心损耗	/	/			6.6	dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	9.15&10.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	9.1&10.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.95	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.1-27	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

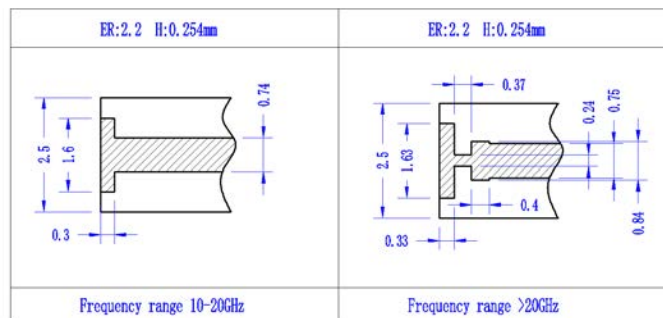
装配示意图



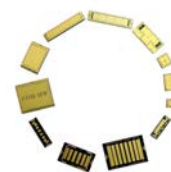
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

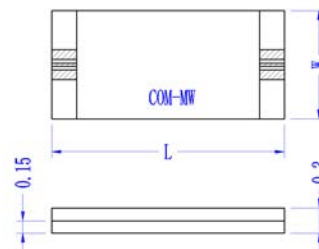
建议PCB布局图



参考实物图

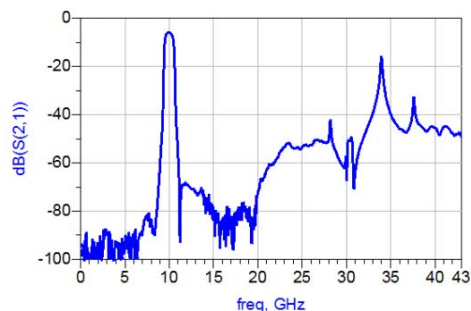
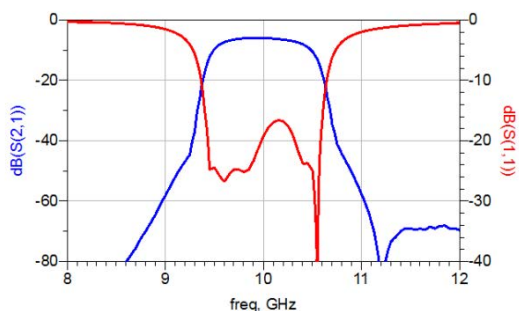
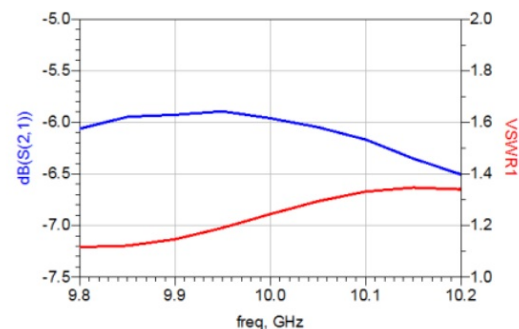


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.4	4.5	4.6
W	3.1	3.2	3.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

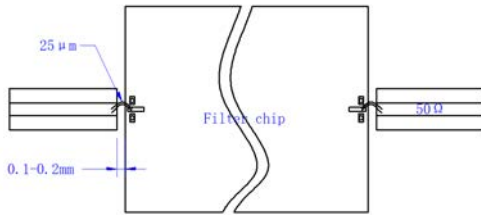
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9800	~	13000	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	8.9&13.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.5&13.85	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.1	GHz≥	50			dB
带外抑制	12.4-29	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

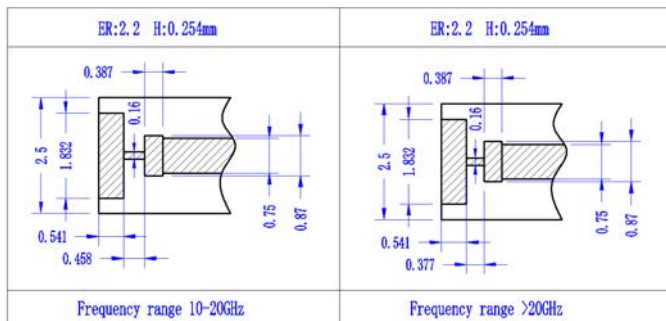
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

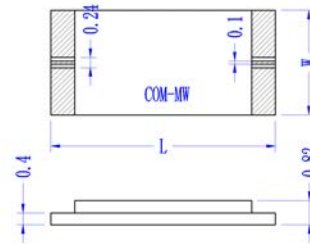
建议PCB布局图



参考实物图

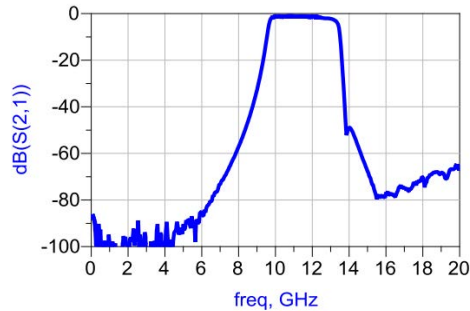
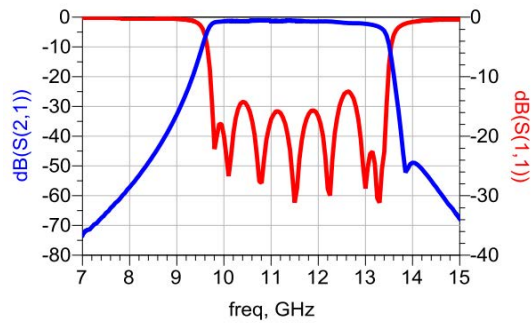
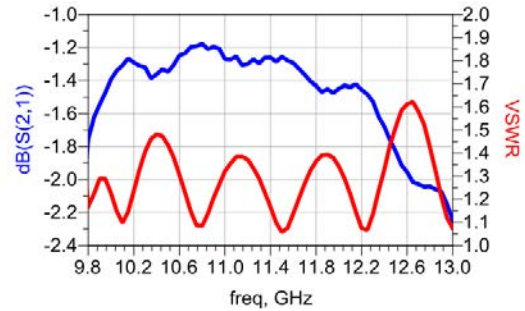


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.1	7.2	7.3
W	3.3	3.4	3.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

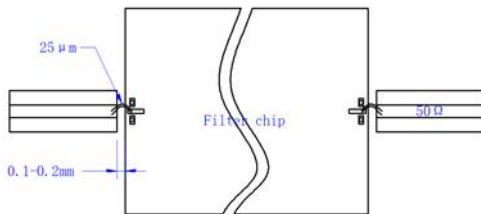
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9900	~	10300	MHz
中心损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	9.05&10.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.85&10.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	11.1-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

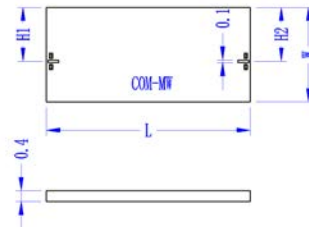
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

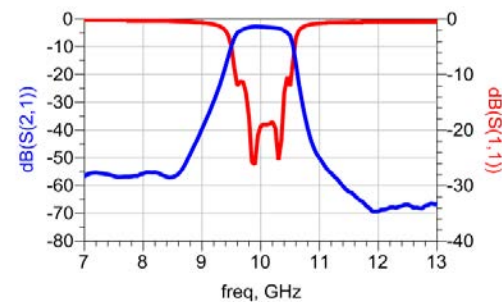
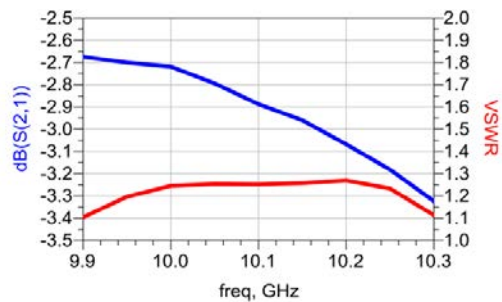


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	10.8	10.9	11.0
W	4.3	4.4	4.5
H1		2.2	
H2		2.2	

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

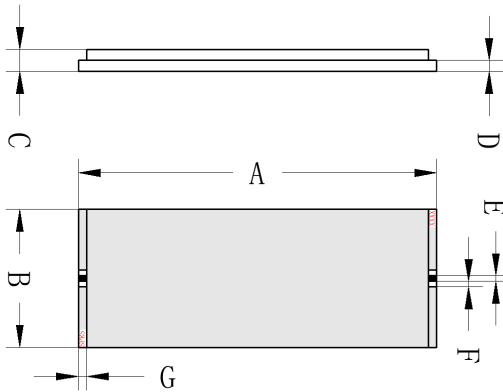
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.4	GHz
工作带宽	10.1-10.7	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	40@11.4-23.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.3, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.52

外形图：端口居中



推荐装配图

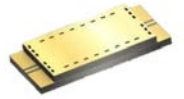


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

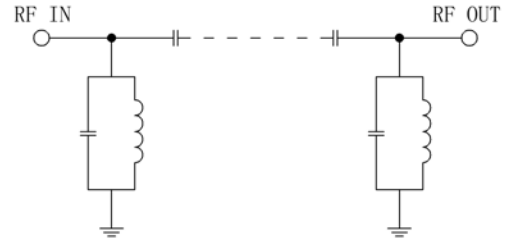
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

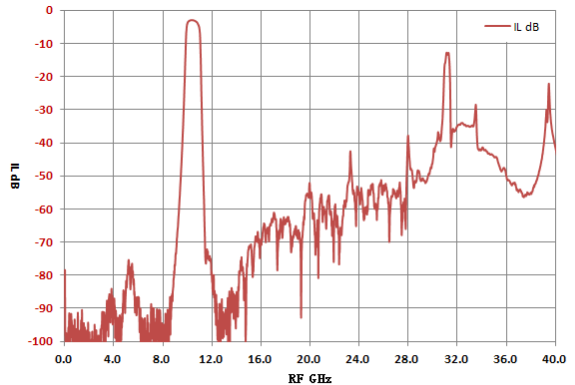
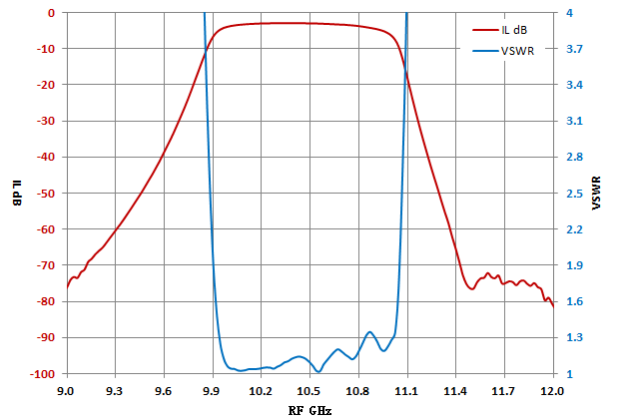
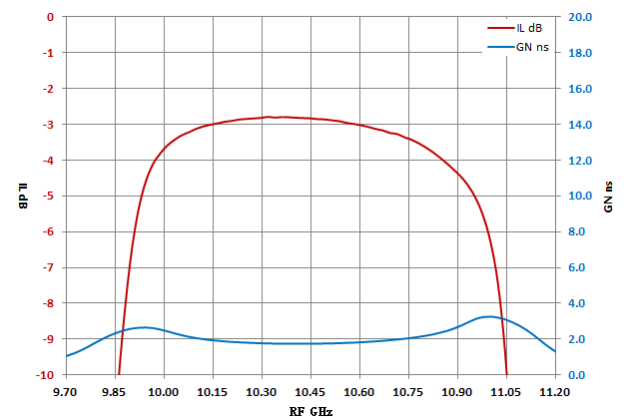
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

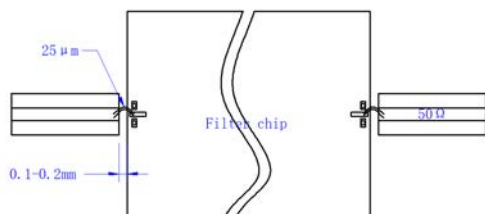
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	11000	MHz
中心损耗	/	/		3.5		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	9.25&12	GHz≥	30			dB
带外抑制	9.1&12.15	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-9	GHz≥	50			dB
带外抑制	12.3-23	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

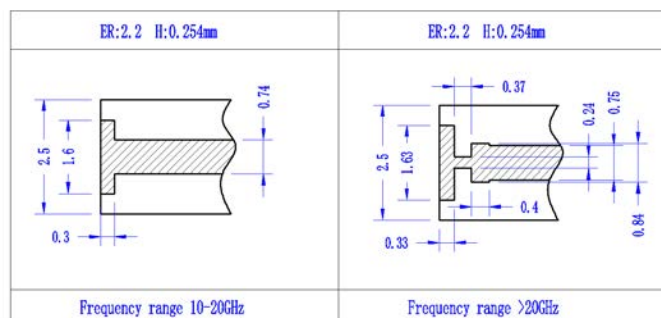
装配示意图



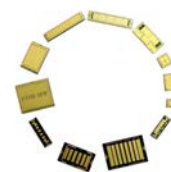
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

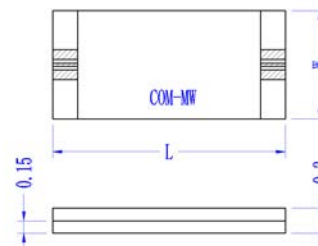
建议PCB布局图



参考实物图

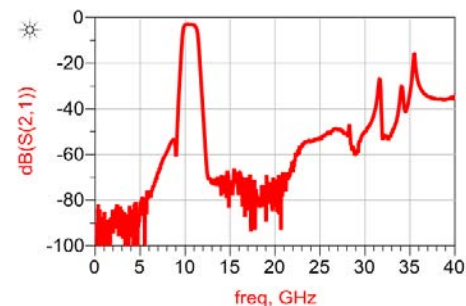
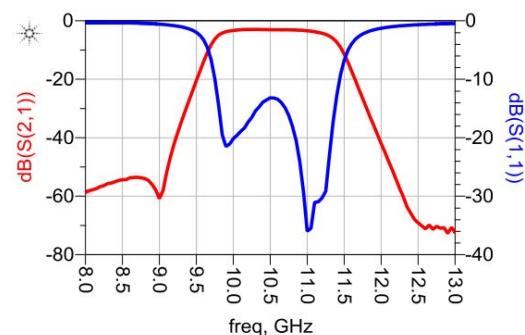
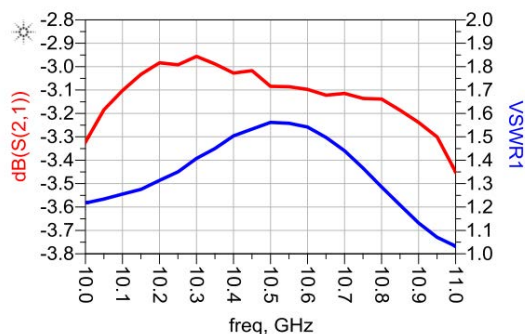


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

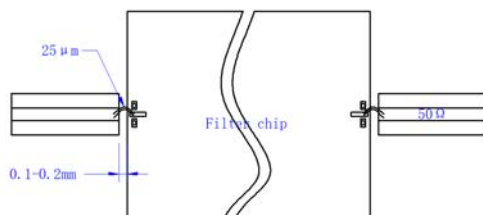
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	12500	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	8.65&13.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.15&14	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-7.2	GHz≥	50			dB
带外抑制	14.35-19.2	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



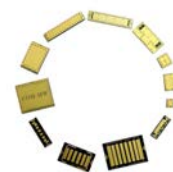
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

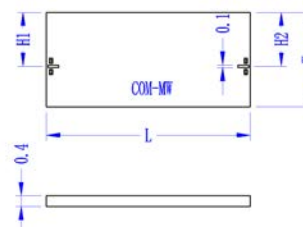
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

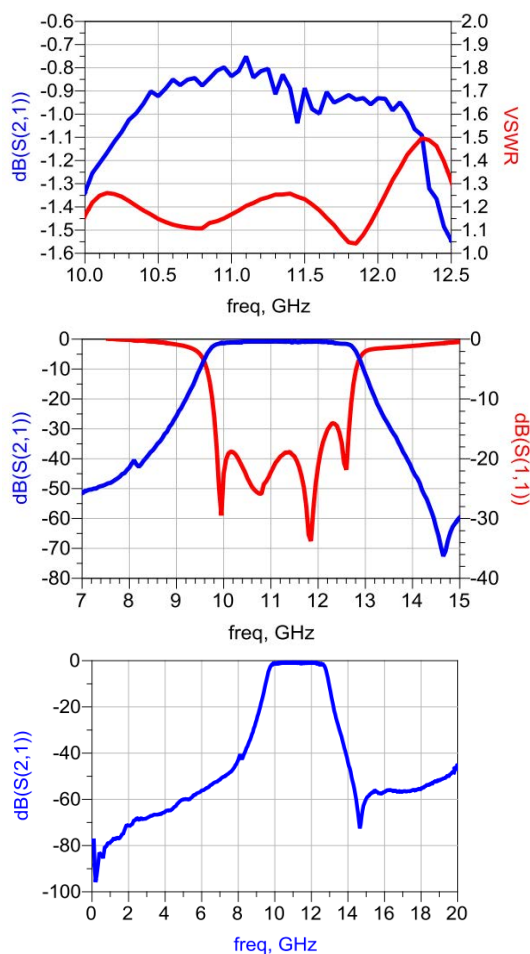


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.5	6.6	6.7
W	3.7	3.8	3.9
H1		2.0	
H2		2.0	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

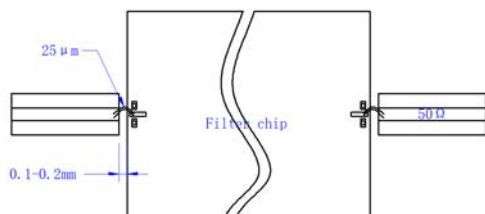
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	14000	MHz
中心损耗	/	/			2.7	dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	8.8&15.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.5&15.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	15.8-22.9	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



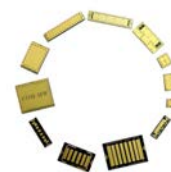
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

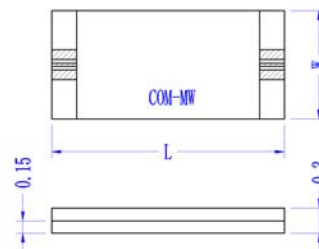
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

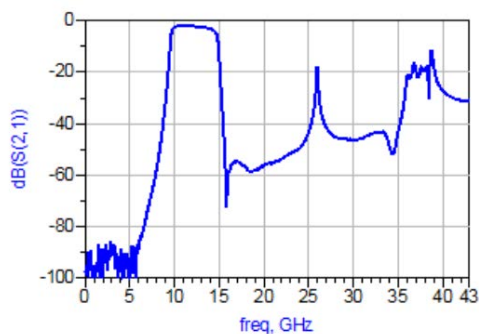
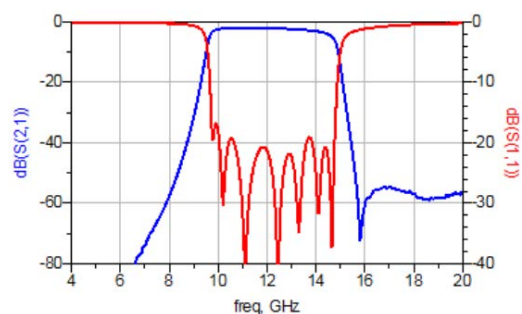
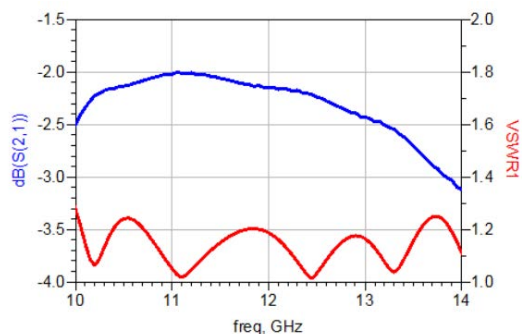


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

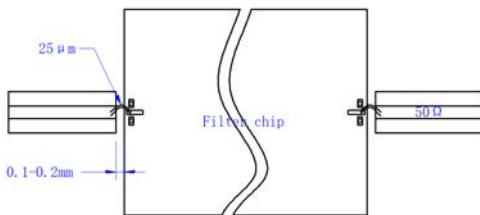
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10100	~	12000	MHz
中心损耗	/	/		3.5		dB
带内波动	/	/			1.8	dB
带外抑制	9.2&12.9	GHz≥	30			dB
带外抑制	9.15&13.0	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.8	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.35-30	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

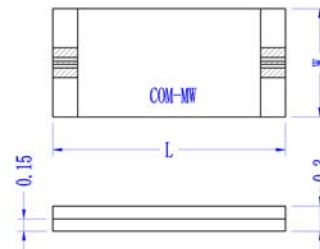
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

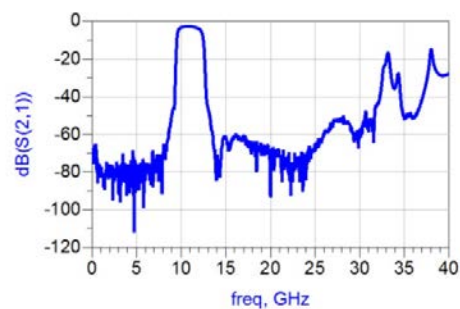
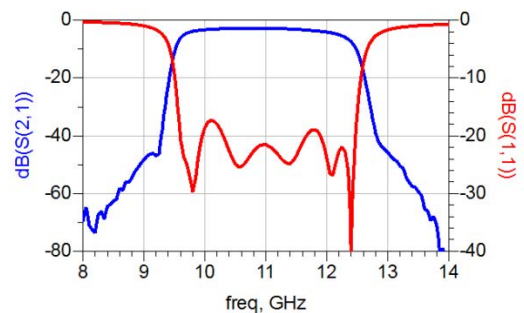
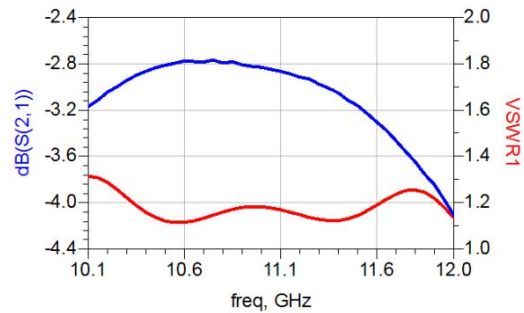


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.9	3.0	3.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

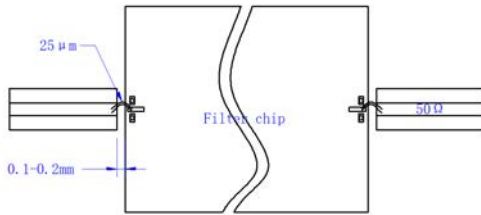
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10400	~	12000	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	9.4&12.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	9.1&12.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-8.8	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.2-19.7	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

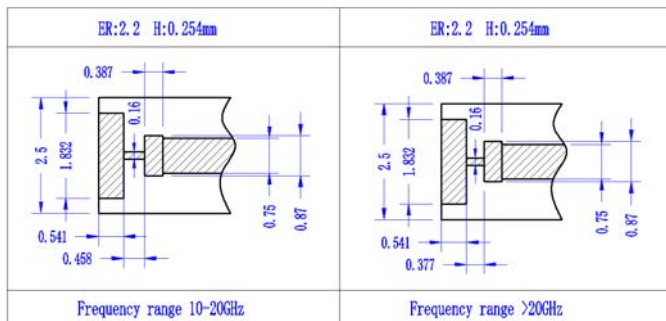
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

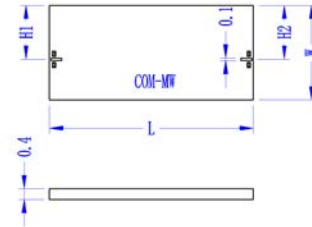
建议PCB布局图



参考实物图

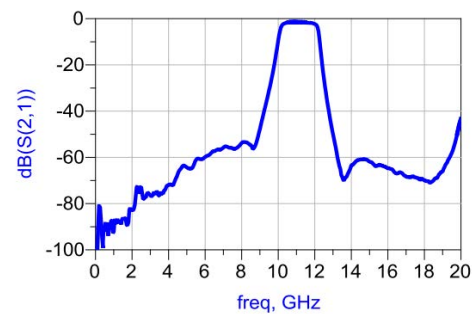
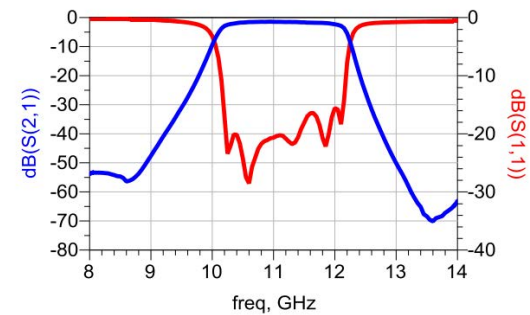
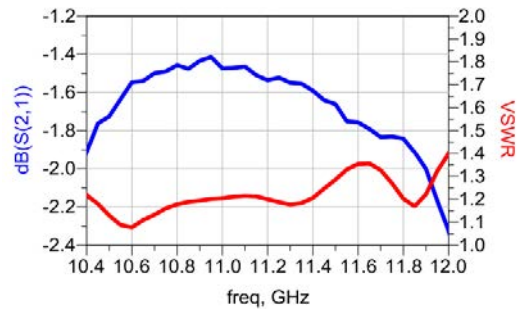


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.9	9.0	9.1
W	3.9	4.0	4.1
H1		2.0	
H2		2.0	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

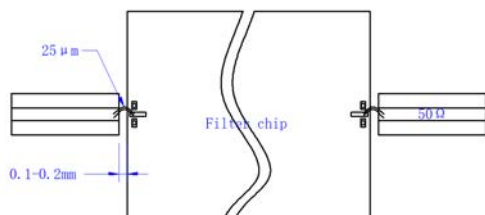
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10500	~	13000	MHz
中心损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	9.6&14	GHz≥	30			dB
带外抑制	9.3&14.05	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-9	GHz≥	50			dB
带外抑制	14.3-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



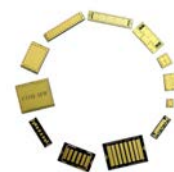
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

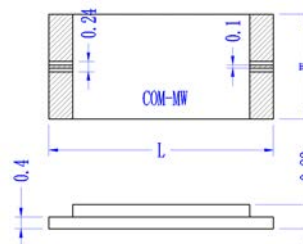
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

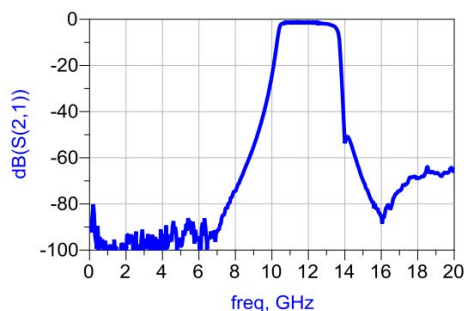
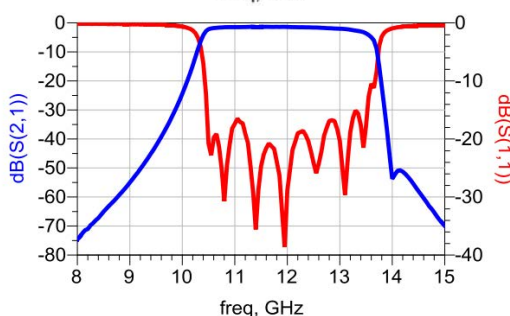
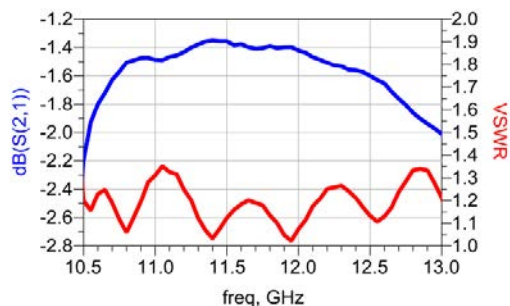


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.1	7.2	7.3
W	3.2	3.3	3.4

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

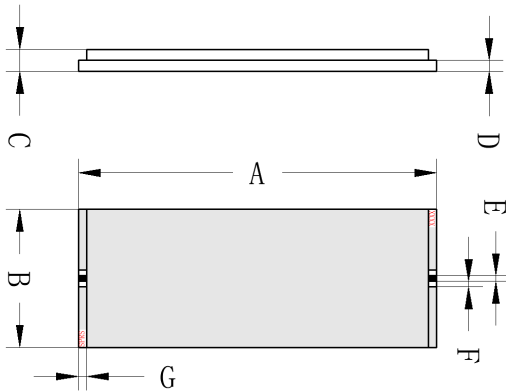
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.05	GHz
工作带宽	10.7-11.4	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	40@DC-10.1GHz	dBc
带外抑制	40@12.0-28.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.0, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.54

外形图：端口居中



推荐装配图

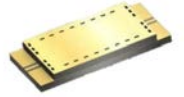


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

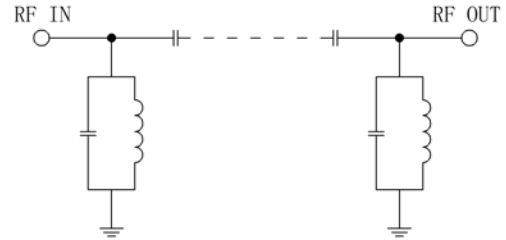
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

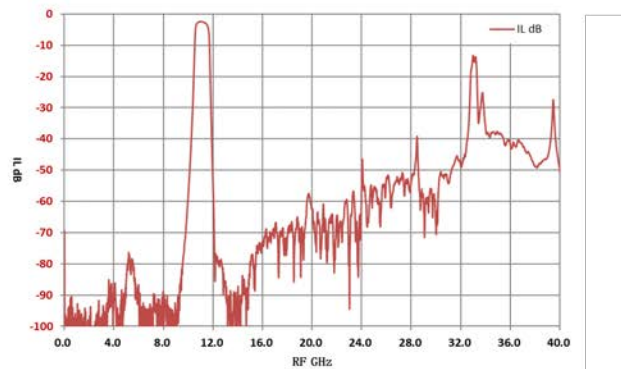
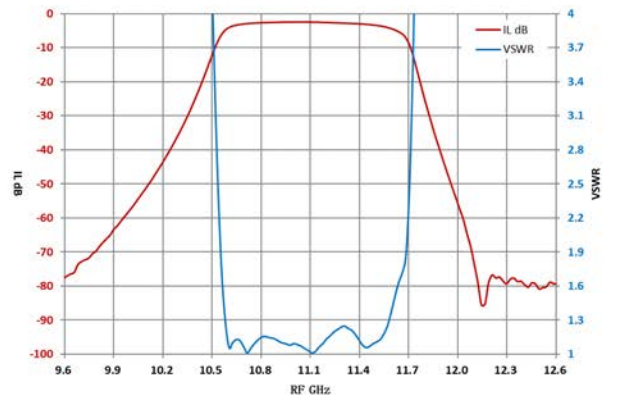
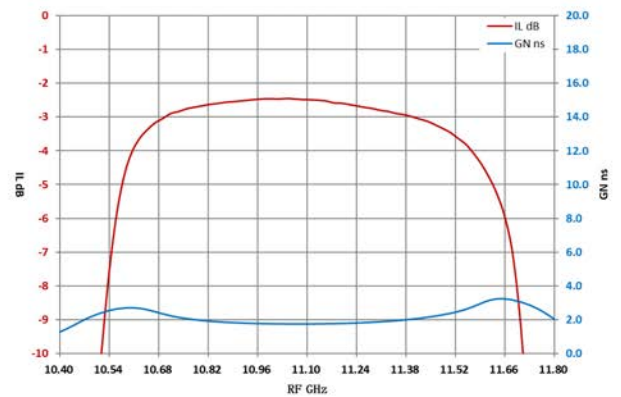
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

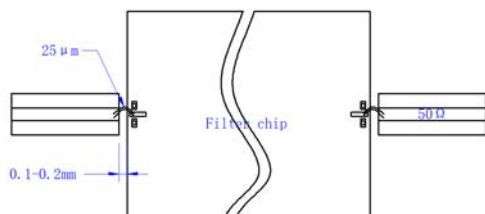
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10900	~	11100	MHz
中心损耗	/	/			6.8	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	10.2&11.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.15&11.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	12.2-26.65	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



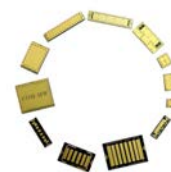
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

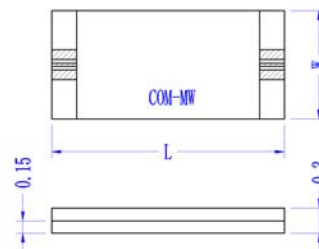
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

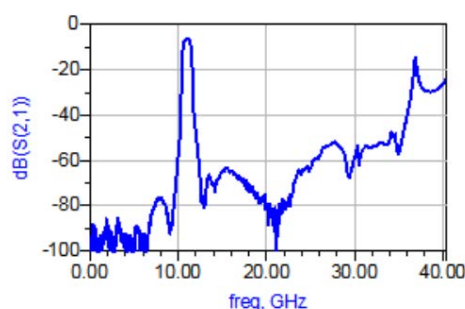
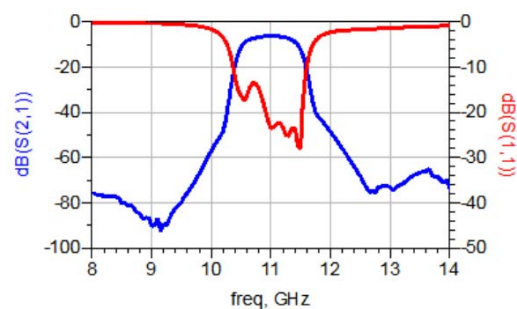
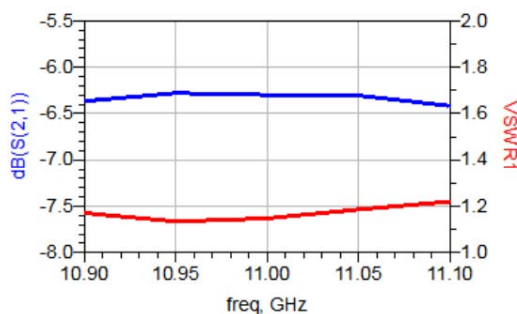


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.9	3.0	3.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

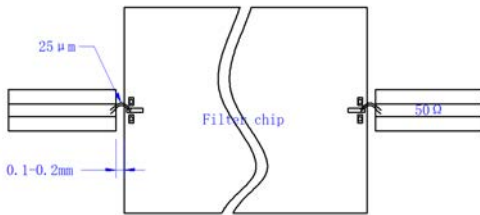
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	11000	~	12000	MHz
中心损耗	/	/		3.5		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	10.25&13.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.1&13.3	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10	GHz≥	50			dB
带外抑制	13.45-24	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

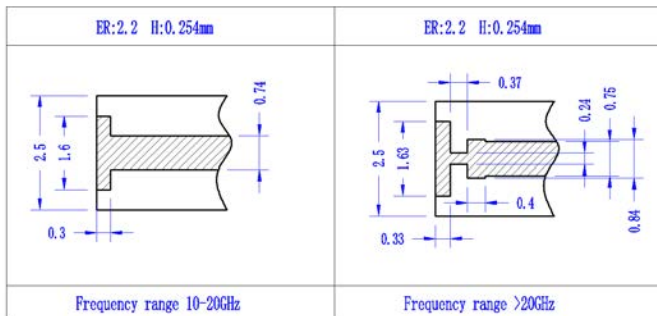
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

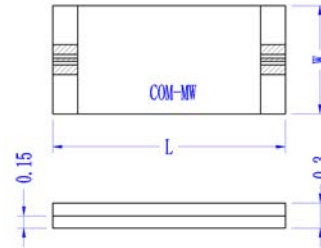
建议PCB布局图



参考实物图

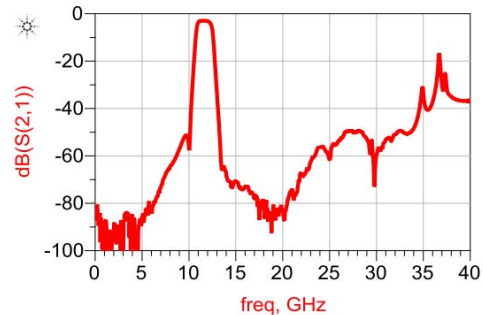
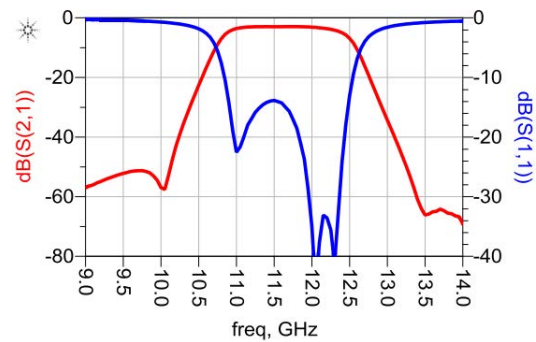
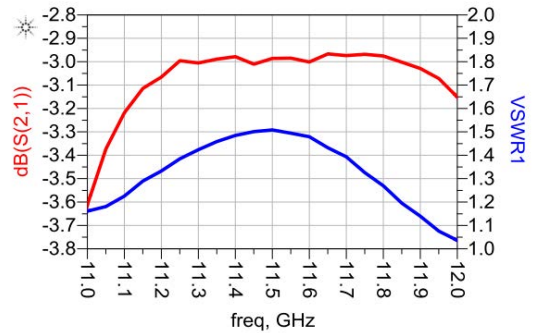


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

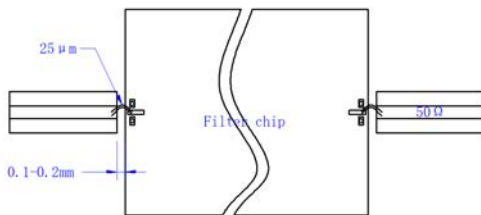
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	11200	~	15200	MHz
中心损耗	/	/		1.8		dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	9.9&16.45	GHz≥	20			dB
带外抑制	9.35&16.65	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-8.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	16.8-27.4	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

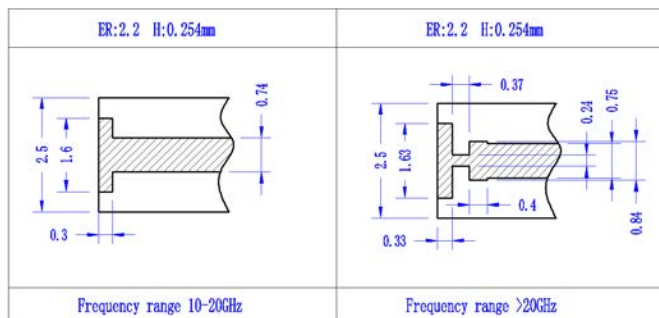
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

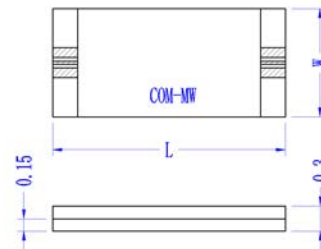
建议PCB布局图



参考实物图

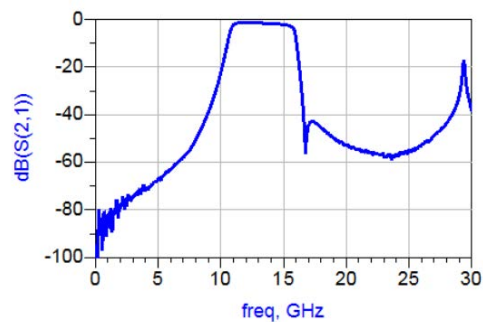
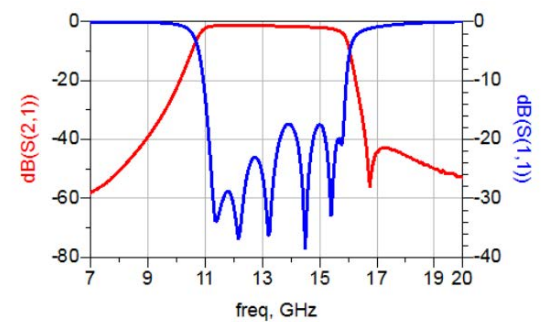
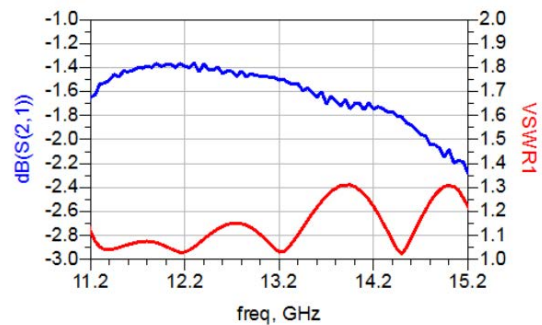


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.4	2.5	2.6
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

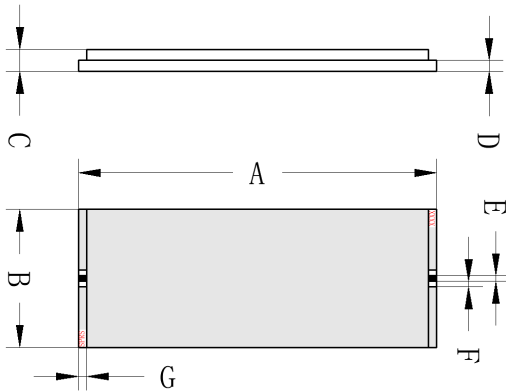
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.8	GHz
工作带宽	11.4-12.2	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.6:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-10.7GHz	dBc
带外抑制	40@12.9-24.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.0, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.59

外形图：端口居中



推荐装配图

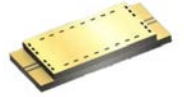


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

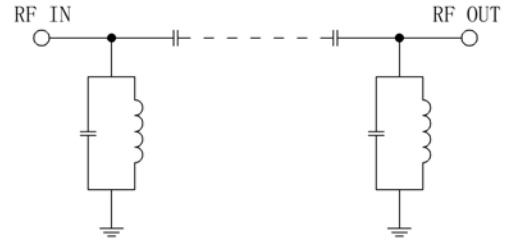
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

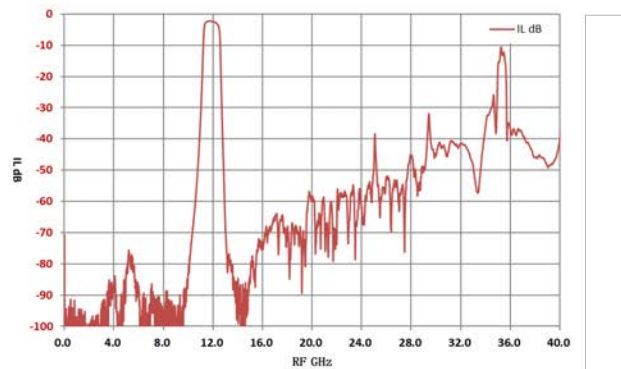
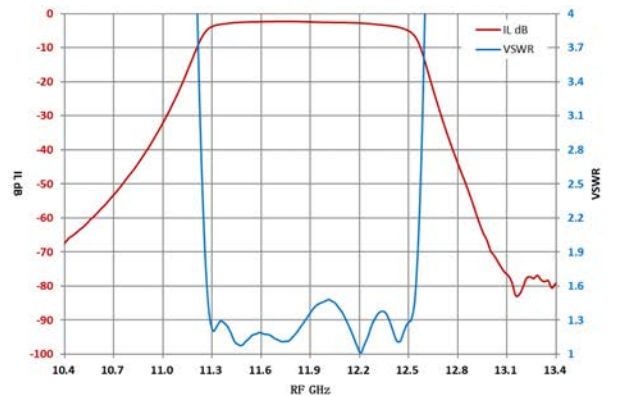
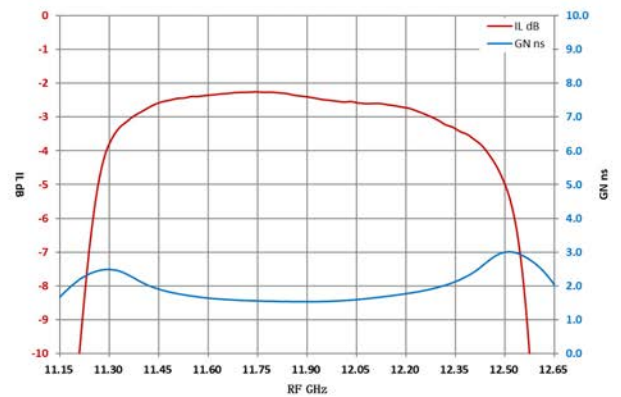
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

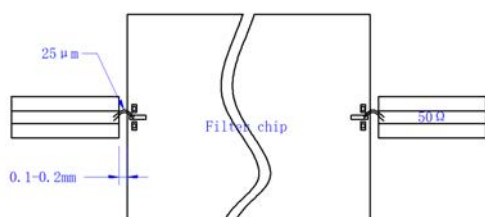
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	11500	~	15000	MHz
中心损耗	/	/		3.2		dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	10.8&16.15	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.7&16.3	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.35	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.9-32	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

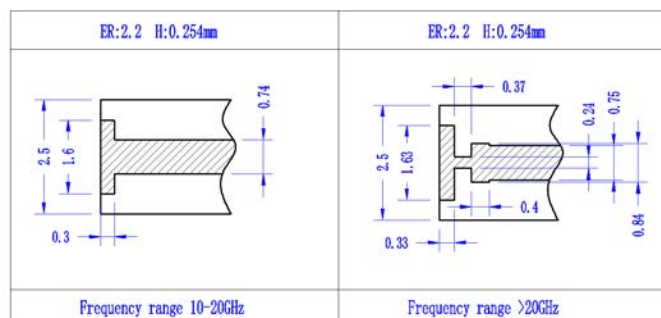
装配示意图



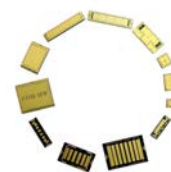
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

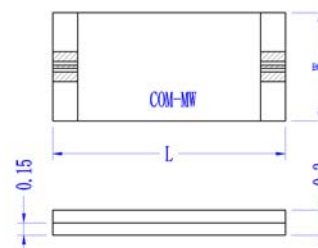
建议PCB布局图



参考实物图

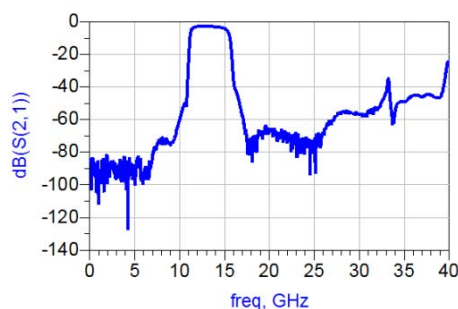
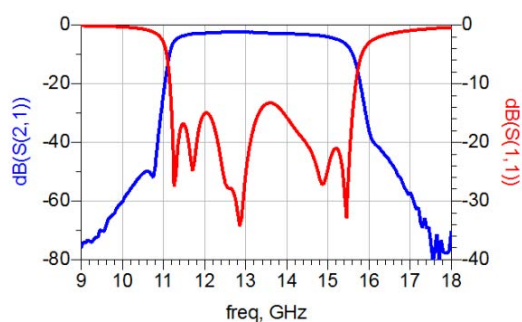
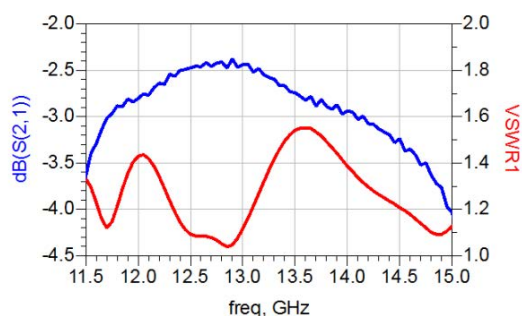


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.6	2.7	2.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

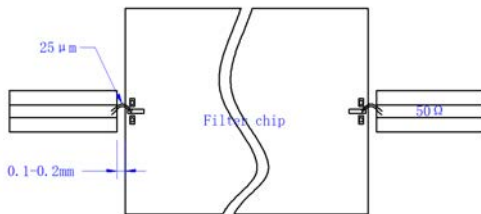
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12000	~	13500	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	11.05&14.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.8&14.55	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	14.7-29	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

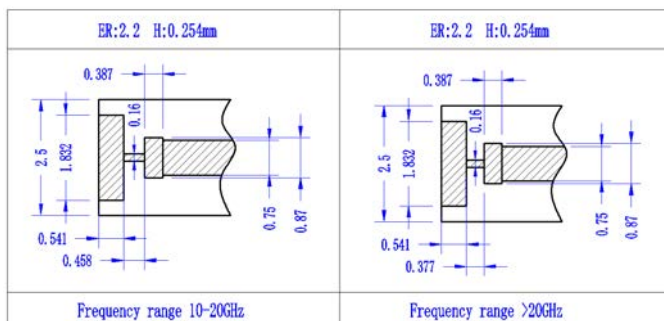
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

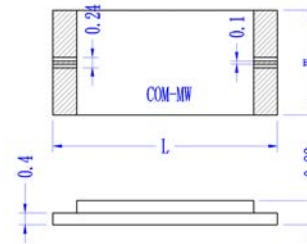
建议PCB布局图



参考实物图

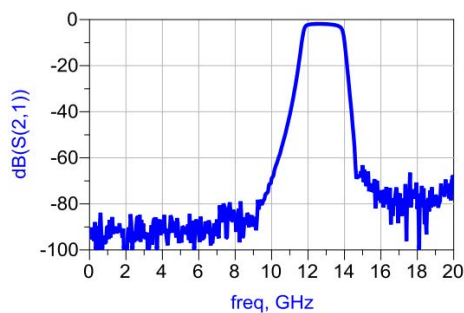
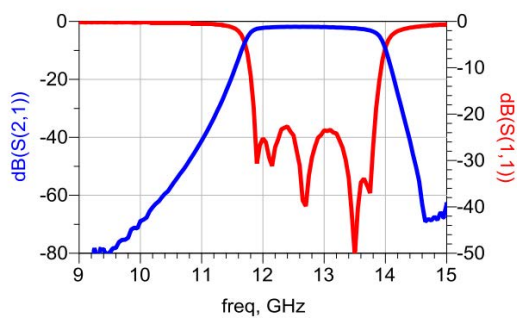
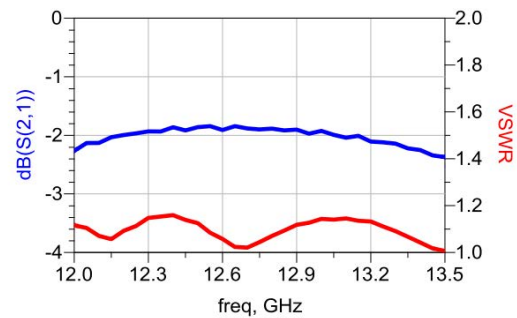


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.9	8	8.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

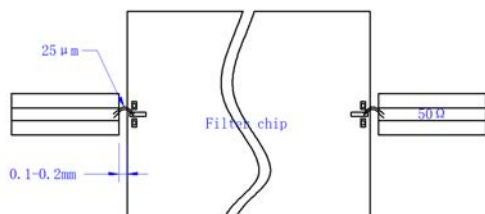
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12000	~	14500	MHz
中心损耗	/	/		3.3		dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	11.17&15.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	11.1&15.85	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-11.0	GHz≥	50			dB
带外抑制	15.95-31.9	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.7ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

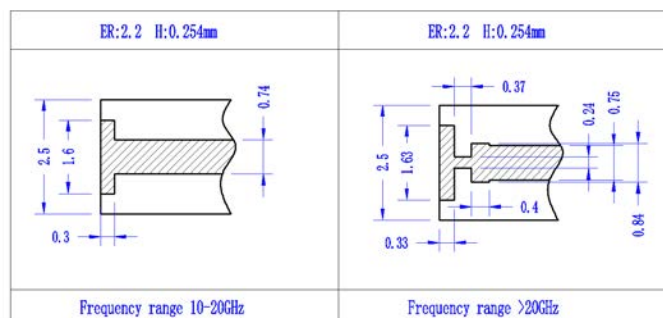
装配示意图



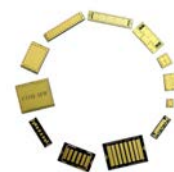
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

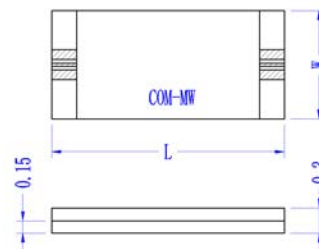
建议PCB布局图



参考实物图

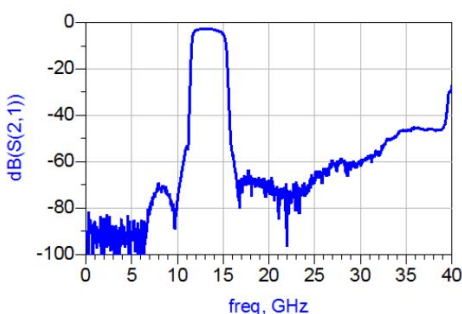
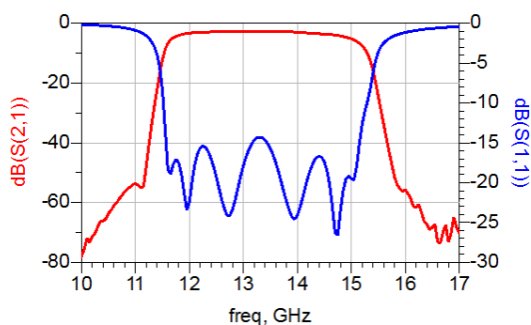
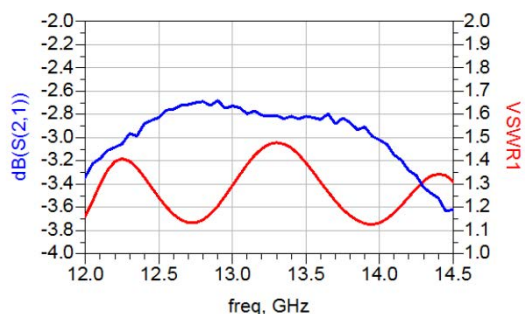


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.5	2.6	2.7

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

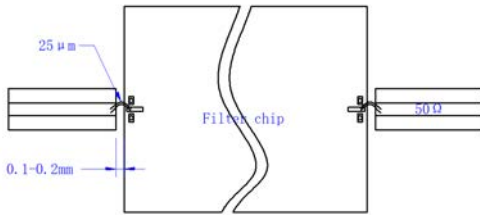
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12100	~	14900	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	10.9&16.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.6&16.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.1	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.5-31.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

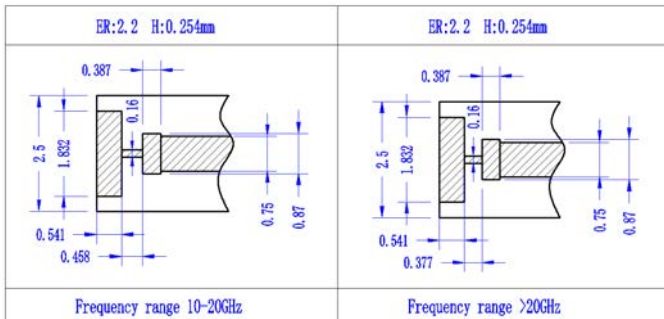
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

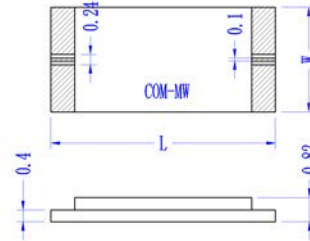
建议PCB布局图



参考实物图

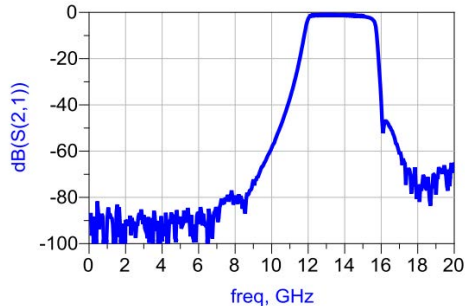
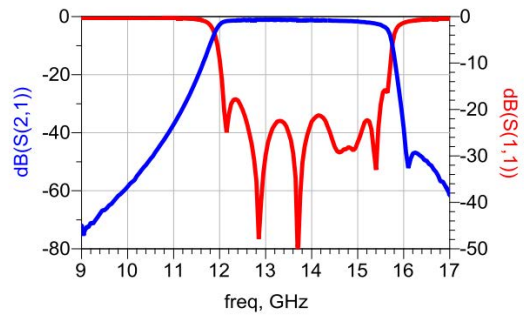
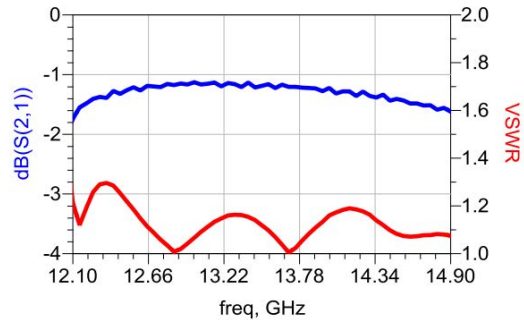


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.2	7.3	7.4
W	2.6	2.7	2.8

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

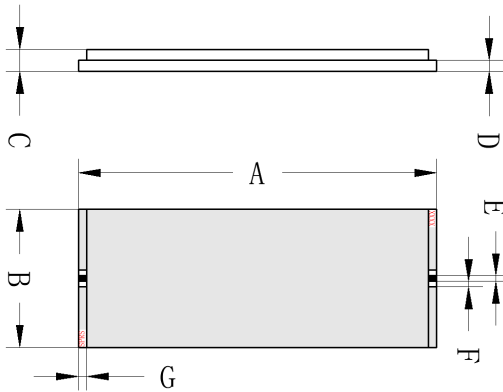
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.7	GHz
工作带宽	12.4-13.0	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.6:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.7GHz	dBc
带外抑制	40@13.6-23.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.0, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.65

外形图：端口居中



推荐装配图

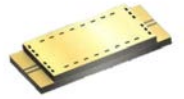


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

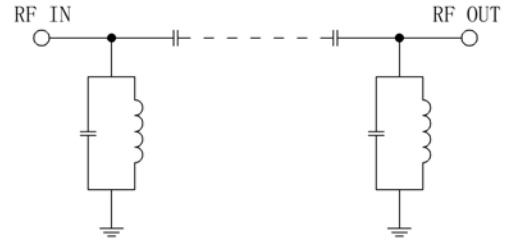
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

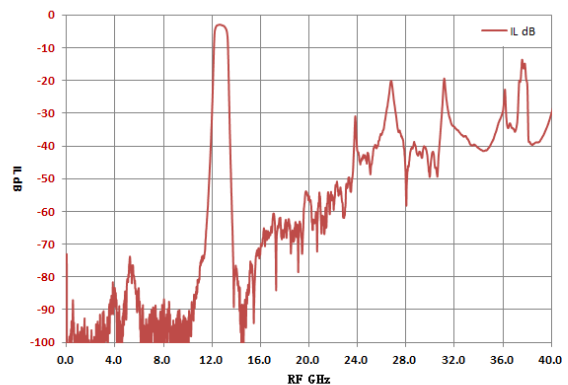
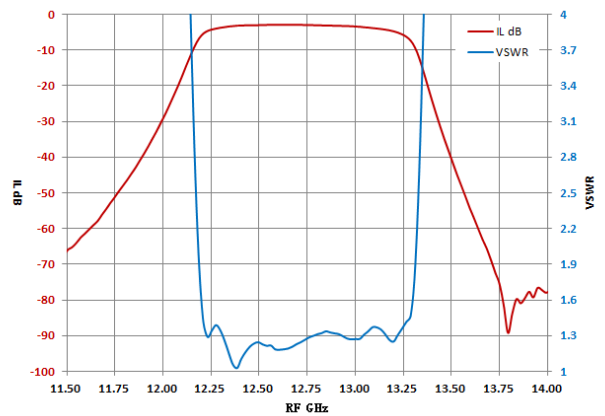
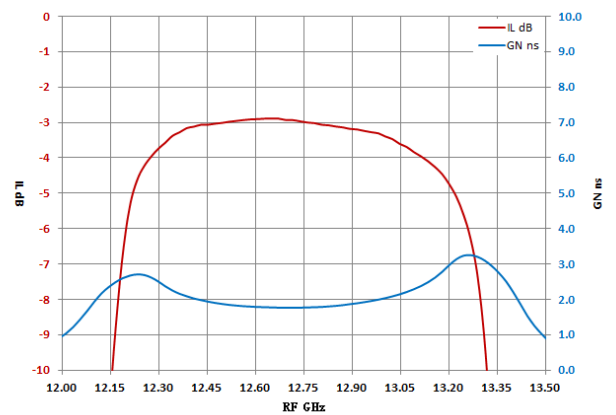
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

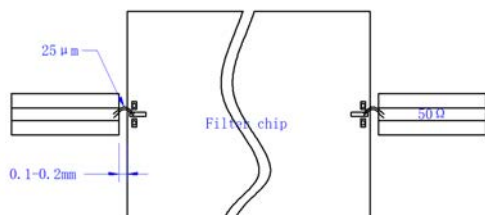
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12500	~	15500	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	11.25&16.6	GHz≥	30			dB
带外抑制	10.9&16.7	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.4	GHz≥	50			dB
带外抑制	17.2-25.6	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

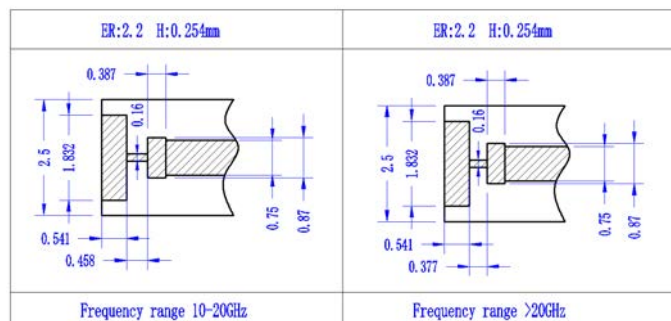
装配示意图



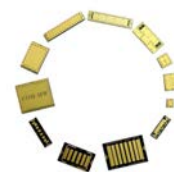
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

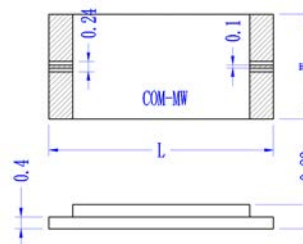
建议PCB布局图



参考实物图

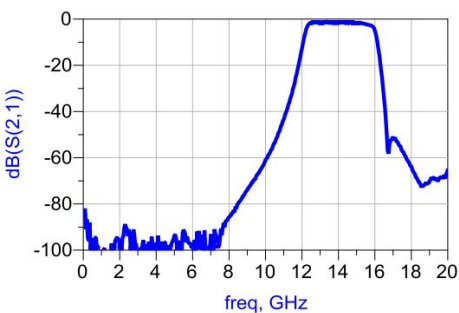
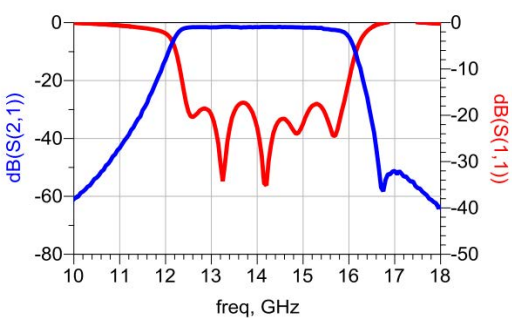
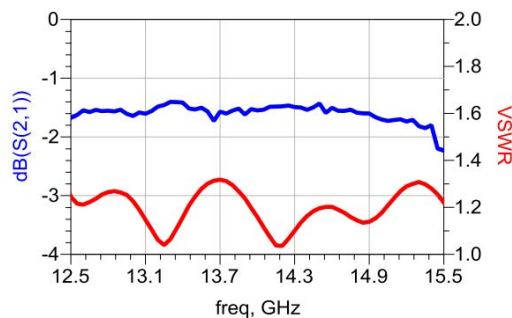


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.2	7.3	7.4
W	2.6	2.7	2.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

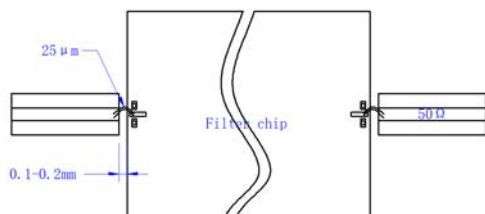
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13000	~	17000	MHz
中心损耗	/	/		2.8		dB
带内波动	/	/			1.9	dB
带外抑制	11.8&18.15	GHz≥	30			dB
带外抑制	11.1&19.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.45	GHz≥	50			dB
带外抑制	20.1-27	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

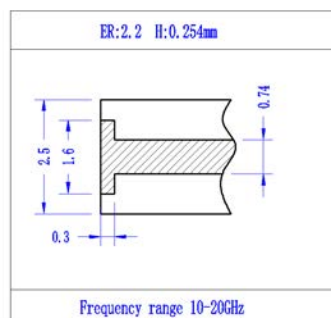
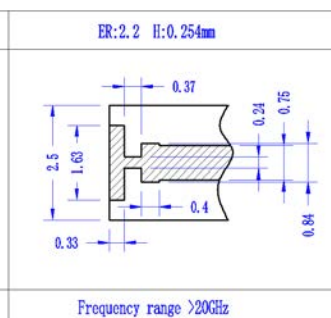
装配示意图



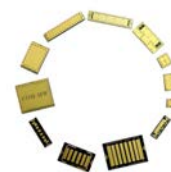
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

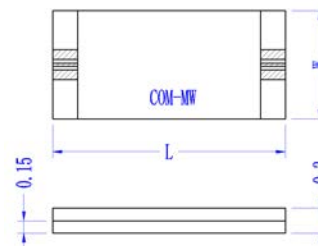
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
	
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

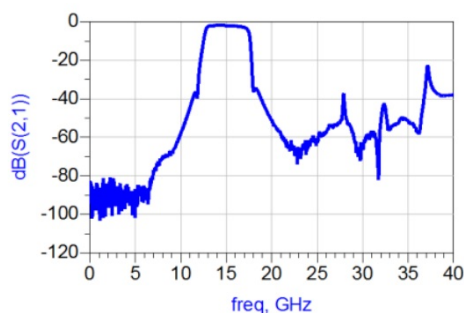
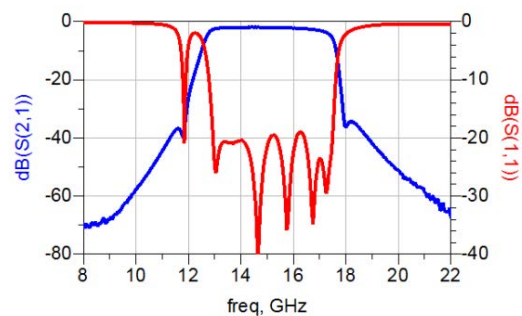
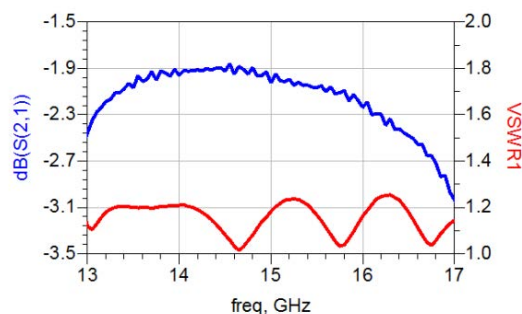


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

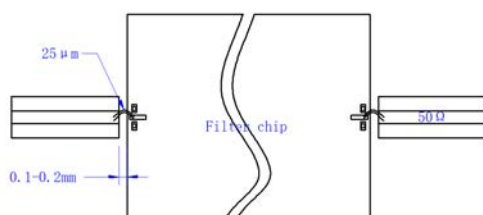
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13200	~	14100	MHz
中心损耗	/	/		3.9		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	12.25&15.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	12.15&15.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-11.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	15.95-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

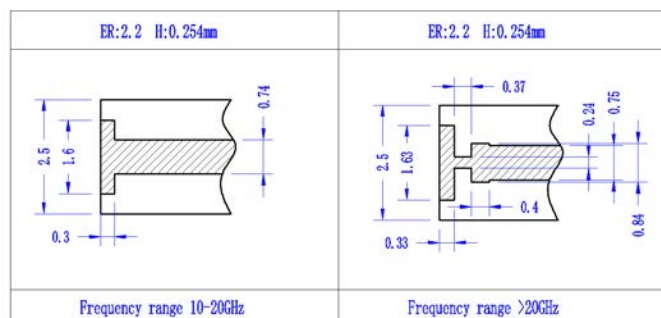
装配示意图



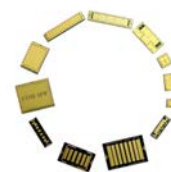
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

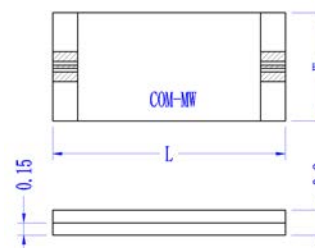
建议PCB布局图



参考实物图

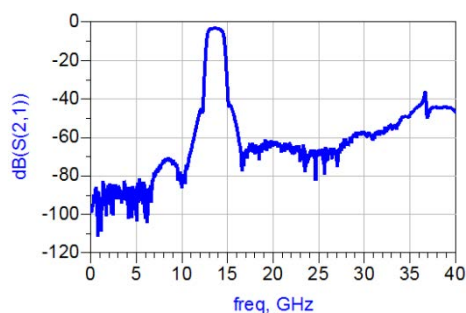
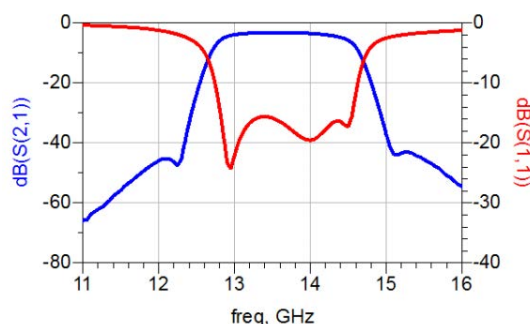
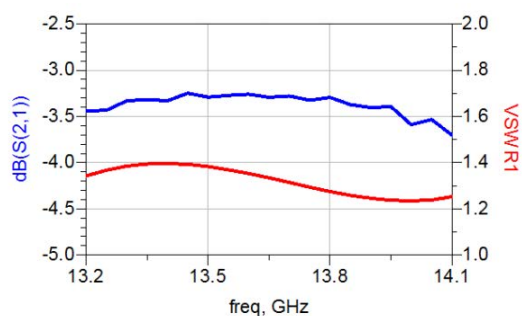


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.5	2.6	2.7

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

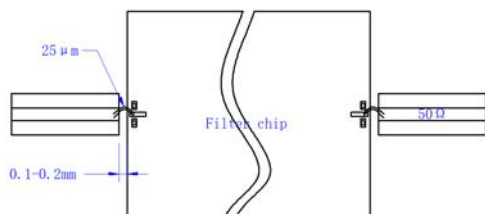
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13500	~	14800	MHz
中心损耗	/	/		3.6		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	12.45&15.9	GHz≥	30			dB
带外抑制	12.35&16.0	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-11.95	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.8-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

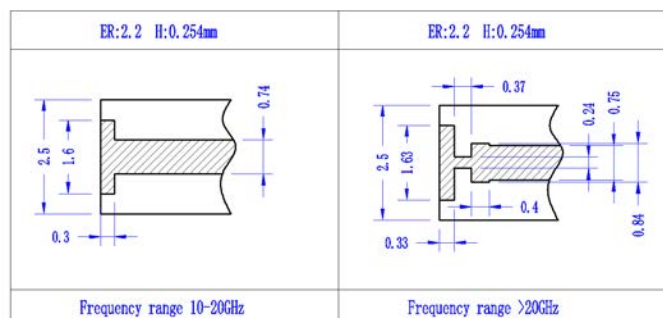
装配示意图



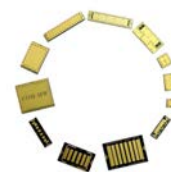
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

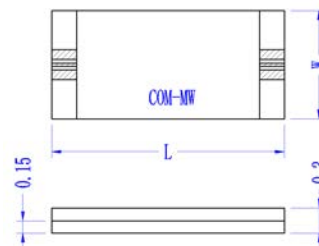
建议PCB布局图



参考实物图

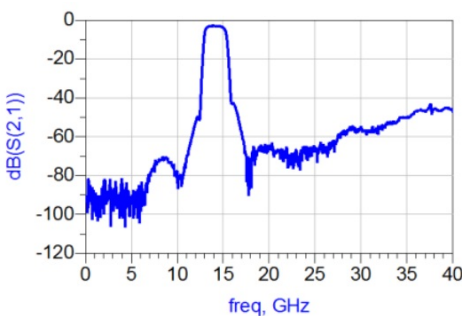
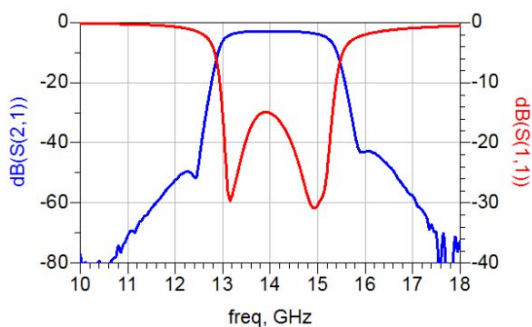
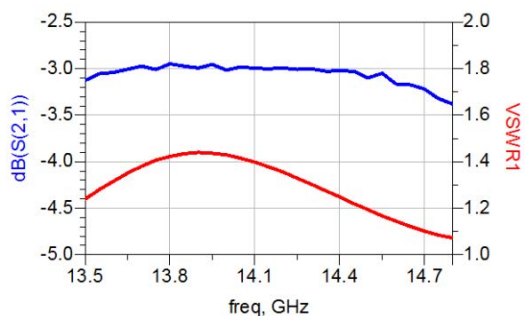


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.4	2.5	2.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

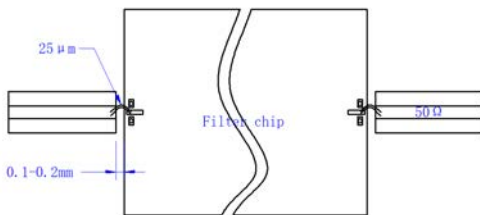
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13700	~	14600	MHz
中心损耗	/	/		3.6		dB
带内波动	/	/			1.4	dB
带外抑制	12.75&15.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	12.2&15.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-11.35	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.6-31	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

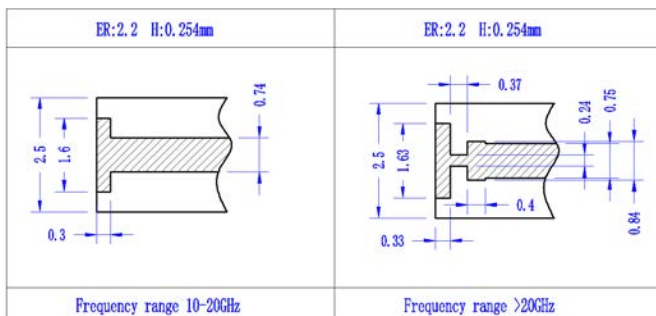
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

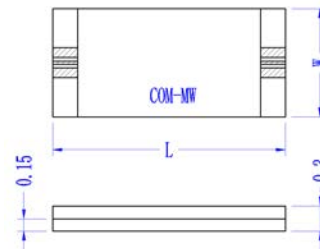
建议PCB布局图



参考实物图

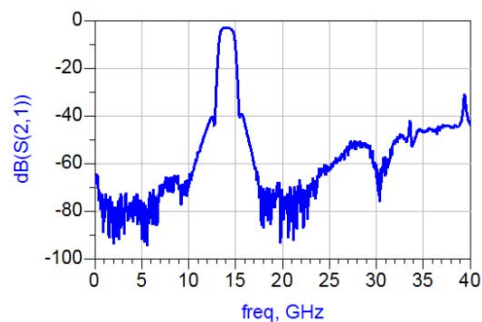
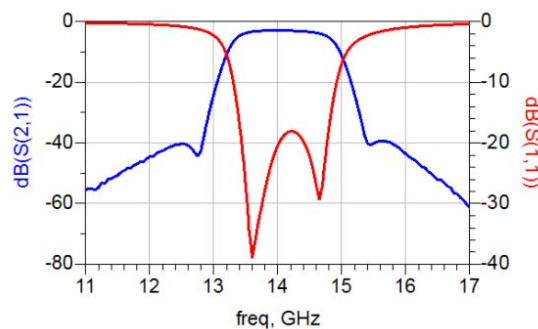
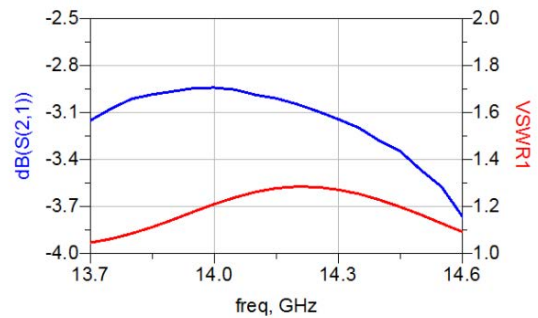


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.9	4.0	4.1
W	2.0	2.1	2.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

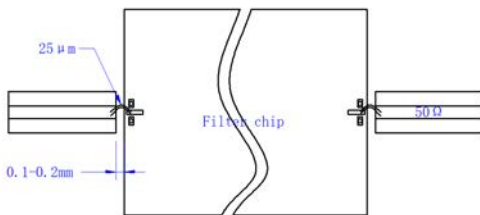
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14500	~	15000	MHz
中心损耗	/	/		3.8		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	13.25&15.75	GHz≥	30			dB
带外抑制	13.15&15.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-12.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	16.55-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

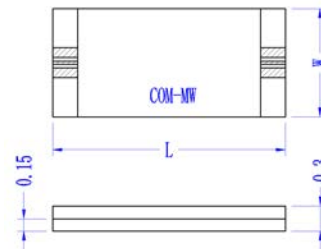
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

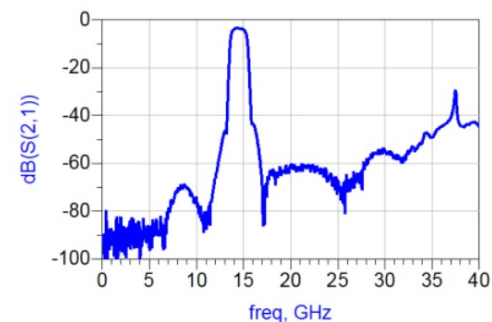
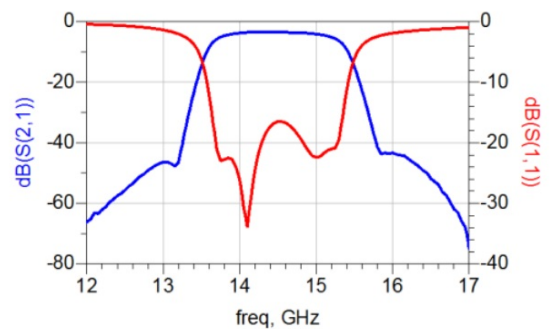
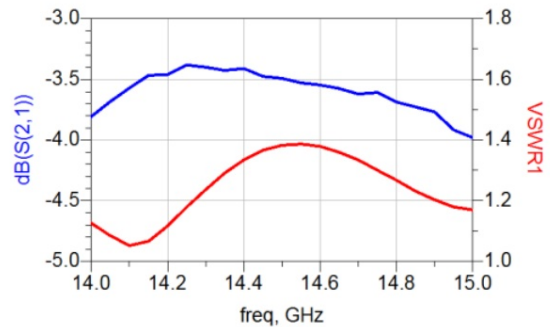


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.4	2.5	2.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

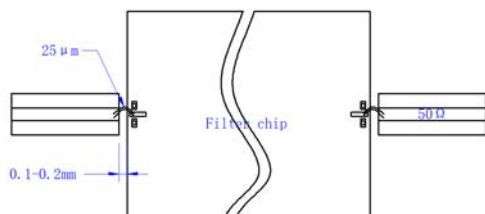
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14000	~	18000	MHz
中心损耗	/	/			2.3	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	12.6&19.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	12.35&20.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-10.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	22.55-33.2	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



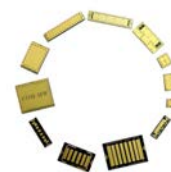
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

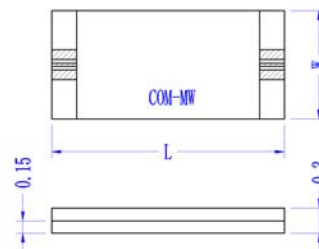
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

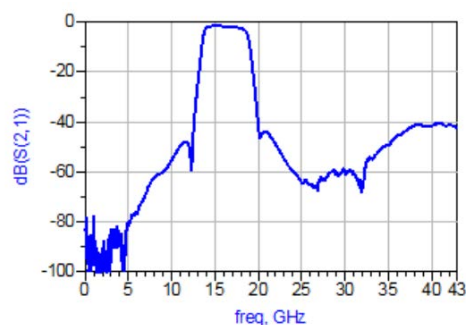
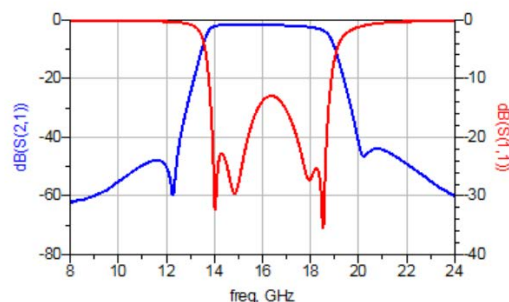
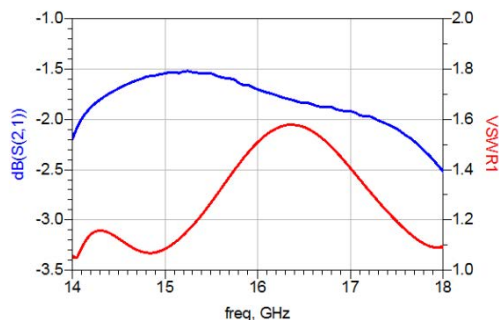


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

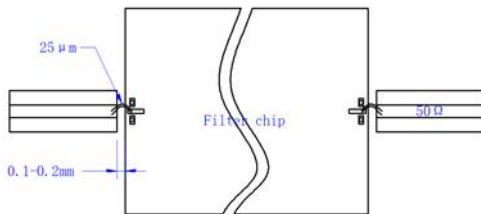
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14500	~	16800	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	13.3&17.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	12.9&17.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-12.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.0-27.4	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

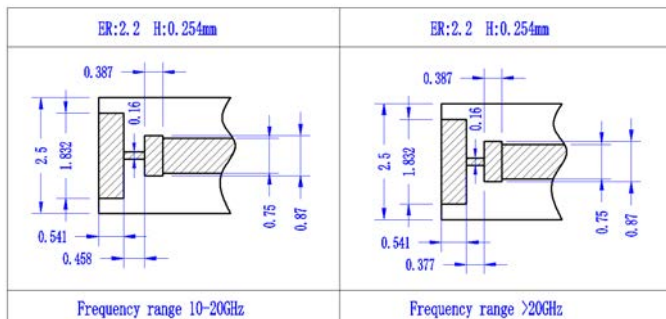
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

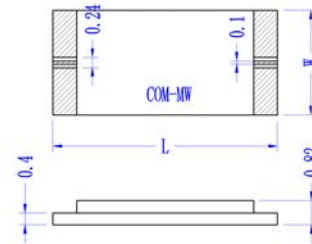
建议PCB布局图



参考实物图

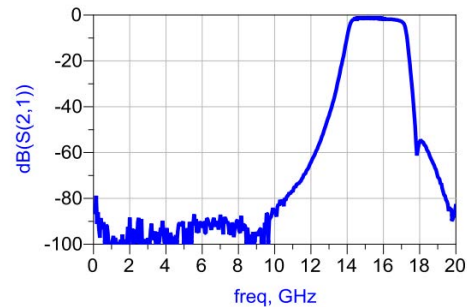
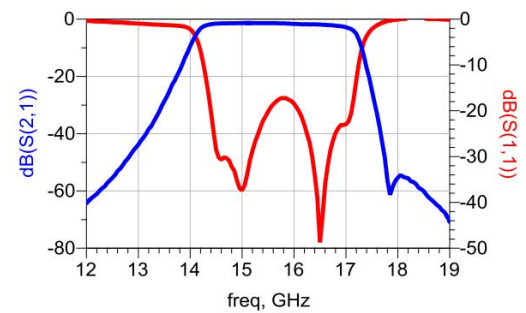
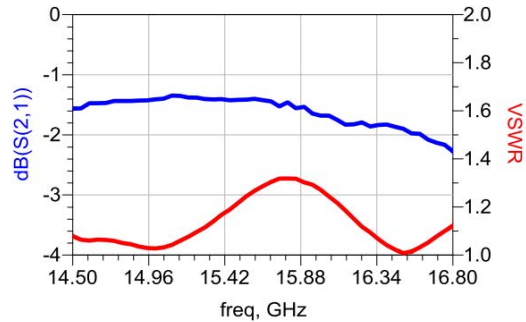


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.4	7.5	7.6
W	2.4	2.5	2.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

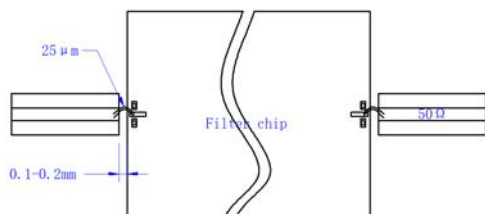
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14700	~	16000	MHz
中心损耗	/	/		3.8		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	13.65&17.0	GHz≥	30			dB
带外抑制	13.55&17.15	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-13.1	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.0-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



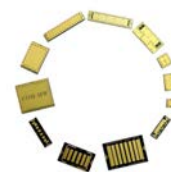
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

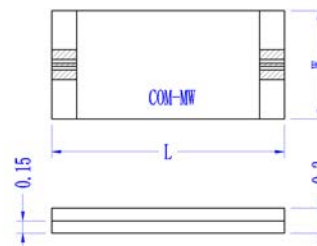
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

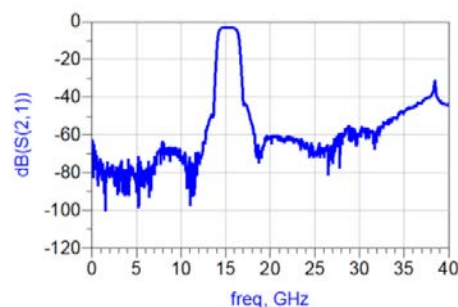
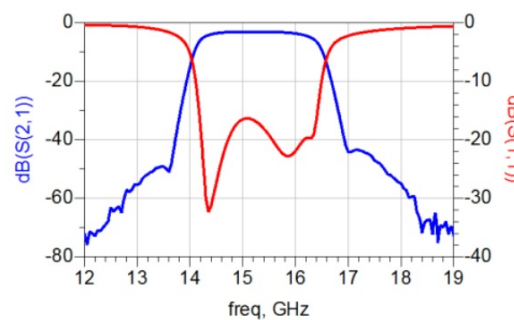
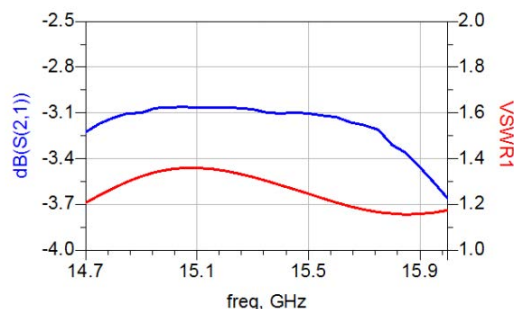


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

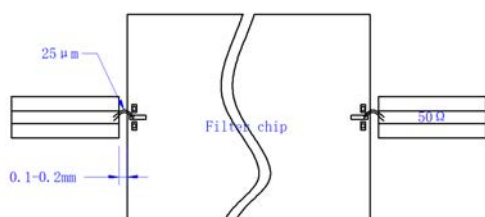
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15600	~	16000	MHz
中心损耗	/	/		4.0		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	14.3&16.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	14.2&16.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-13.75	GHz≥	50			dB
带外抑制	17.6-34	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

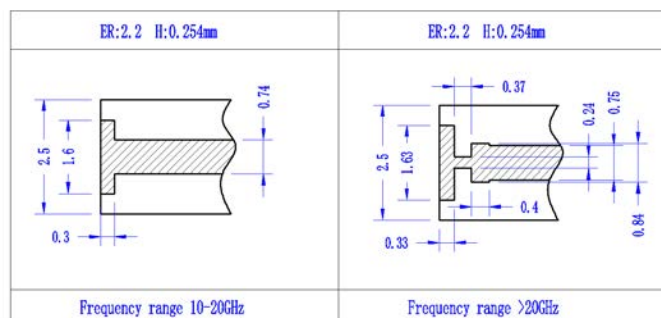
装配示意图



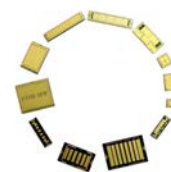
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

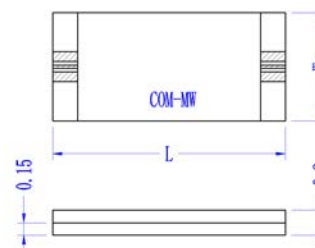
建议PCB布局图



参考实物图

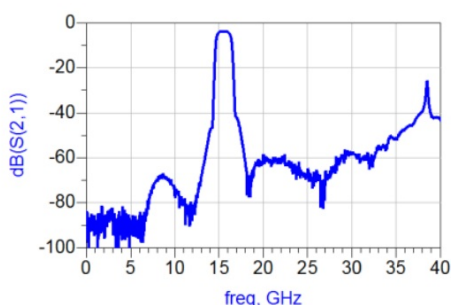
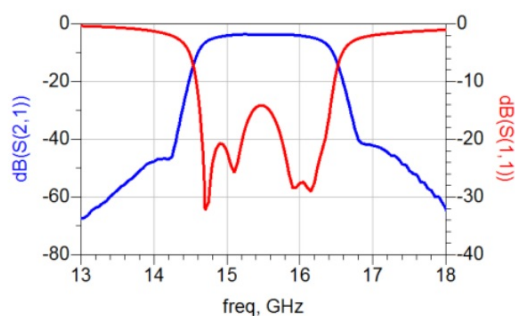
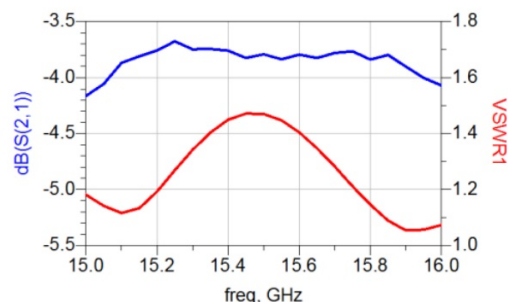


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

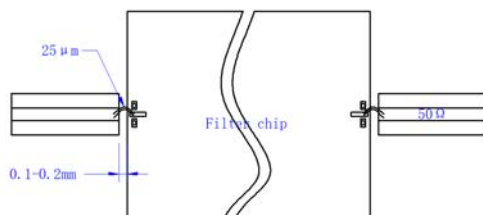
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15000	~	17000	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	13.8&18.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	13.35&18.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-12.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.3-28	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



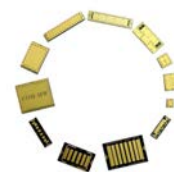
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

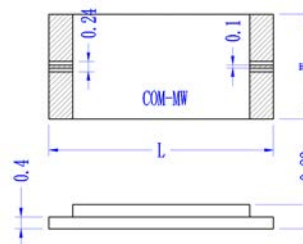
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

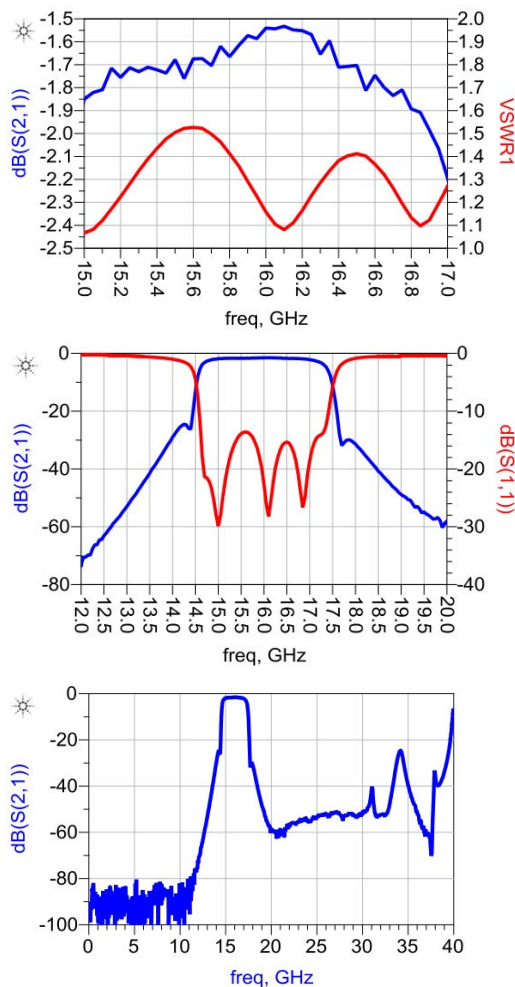


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.9	7.0	7.1
W	2.7	2.8	2.9

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

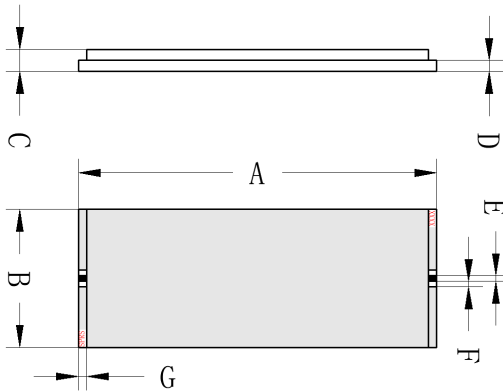
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.55	GHz
工作带宽	15.1-16.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.0GHz	dBc
带外抑制	40@17.0-27.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.3, B:2.5, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.69

外形图：端口居中



推荐装配图

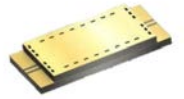


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

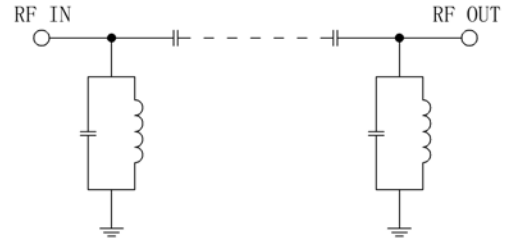
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

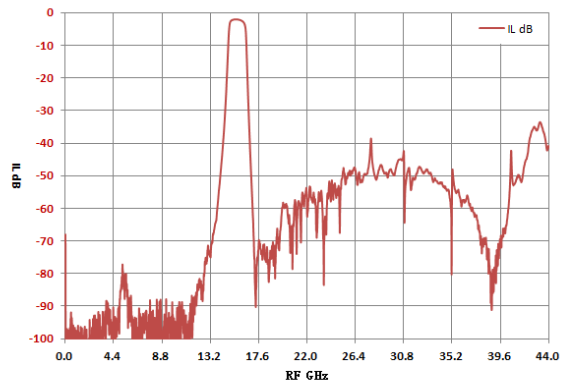
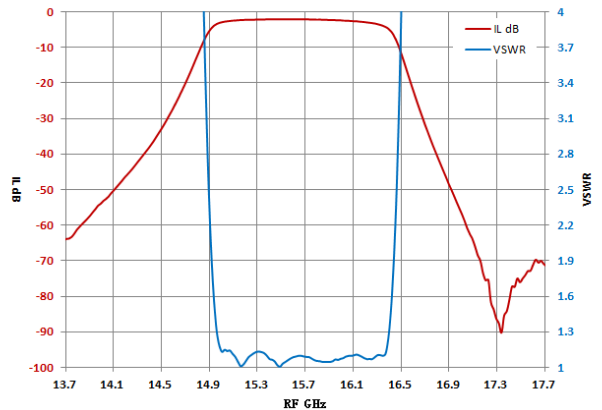
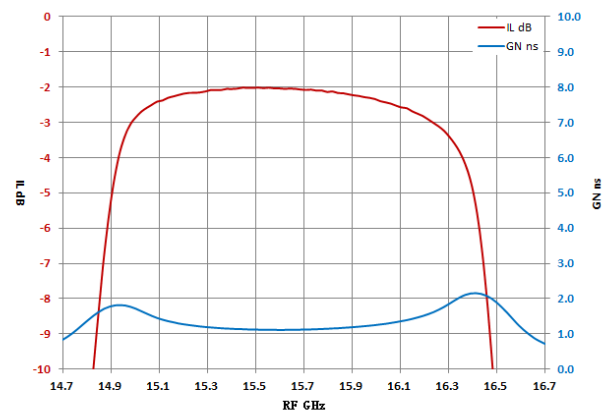
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

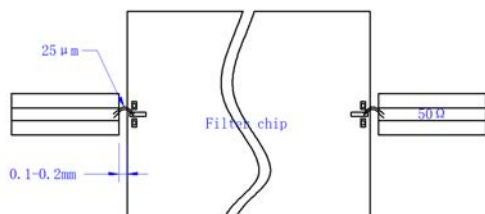
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15500	~	16800	MHz
中心损耗	/	/		4.0		dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	14.65&17.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	14.55&17.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.4-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

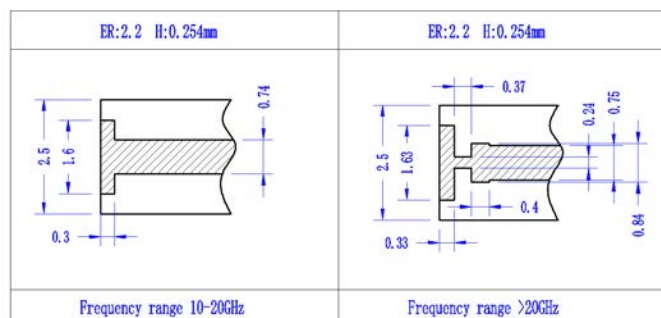
装配示意图



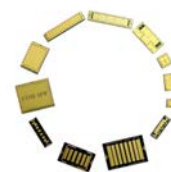
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

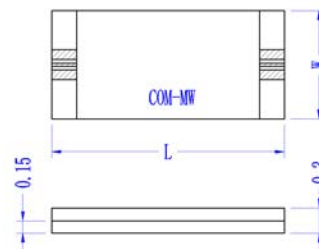
建议PCB布局图



参考实物图

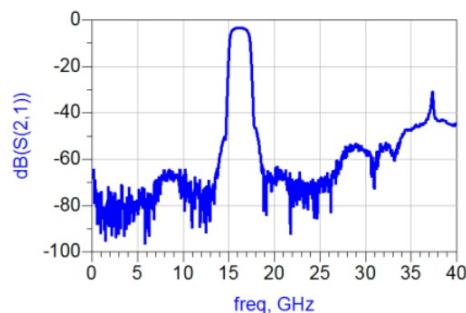
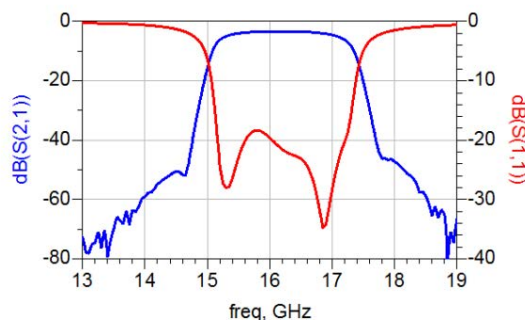
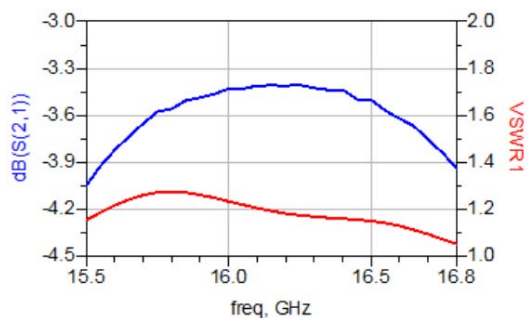


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

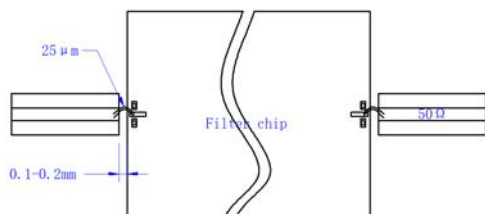
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15500	~	18000	MHz
中心损耗	/	/		3.0		dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	14.6&18.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	14.5&19.05	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.0	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.65-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

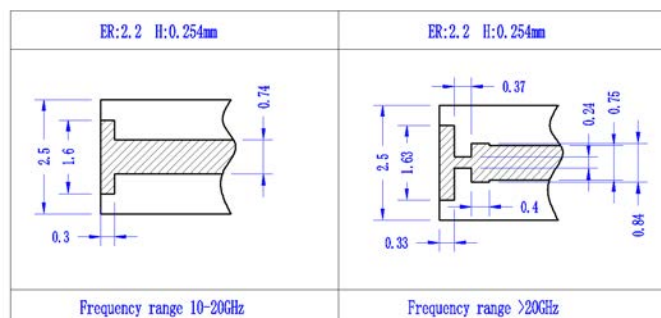
装配示意图



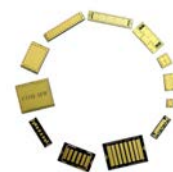
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

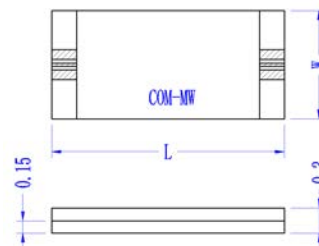
建议PCB布局图



参考实物图

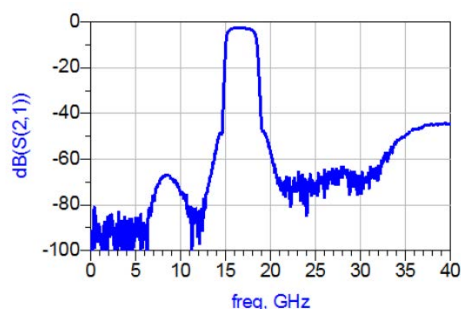
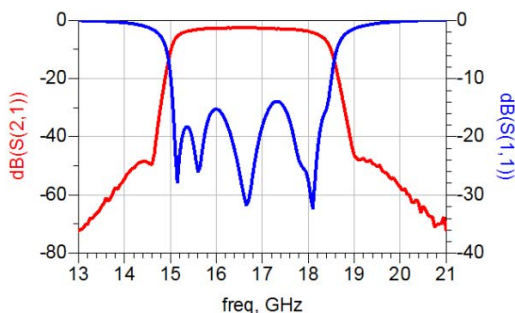
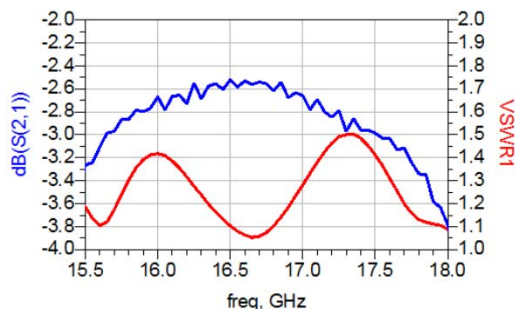


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.0	2.1	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

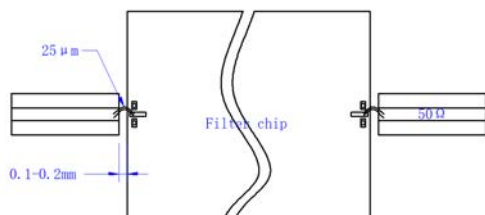
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15800	~	17600	MHz
中心损耗	/	/			1.8	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	15&18.55	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	14.75&18.7	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-14.4	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	18.8-20	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	$\leq$ 0.5ns
相位一致性	$\leq$ $\pm$ 5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



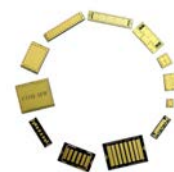
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 $\geq$ 3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 $\geq$ 0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

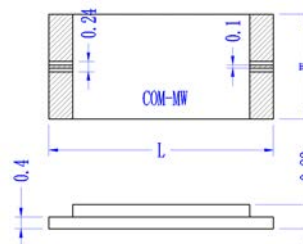
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

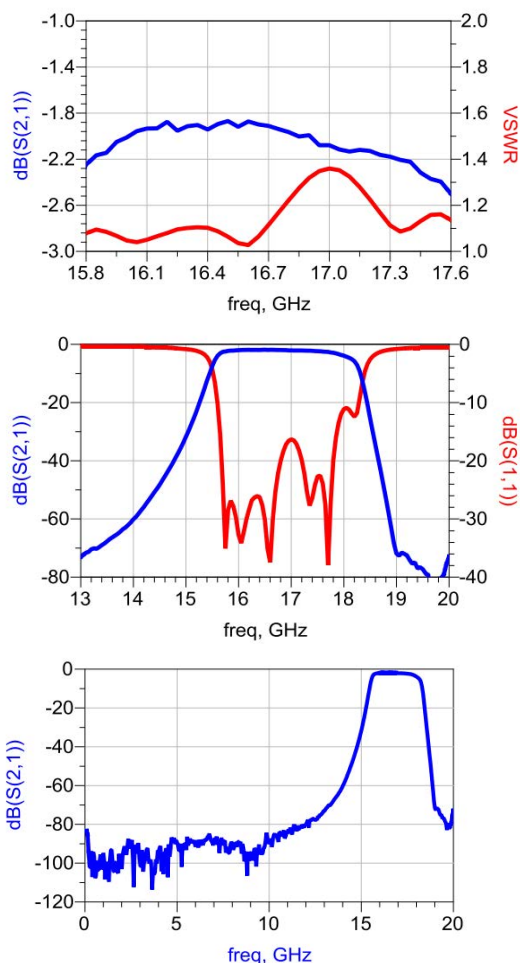


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.1	8.2	8.3
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

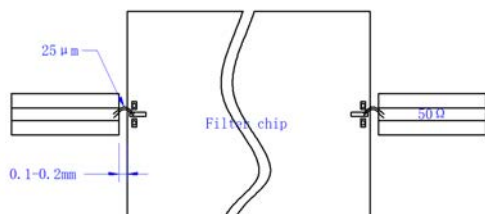
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15900	~	17200	MHz
中心损耗	/	/		3.9		dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	14.85&18.25	GHz≥	30			dB
带外抑制	14.75&18.4	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.9-35.0	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

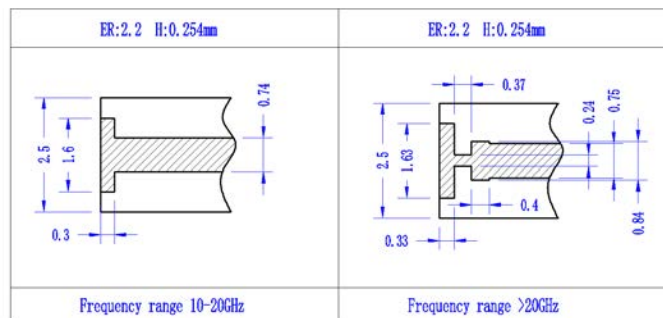
装配示意图



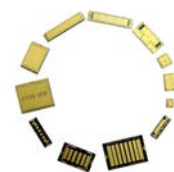
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

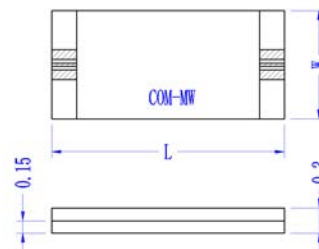
建议PCB布局图



参考实物图

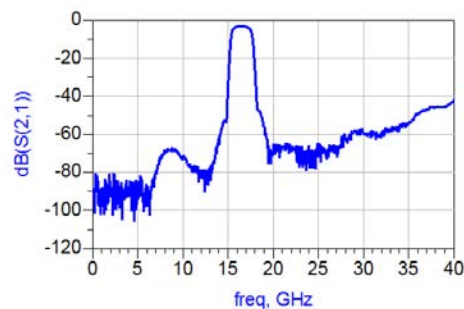
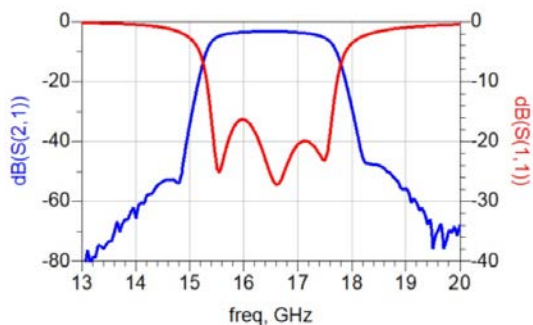
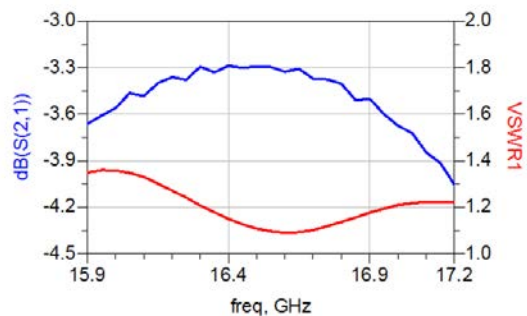


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.1	2.2	2.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

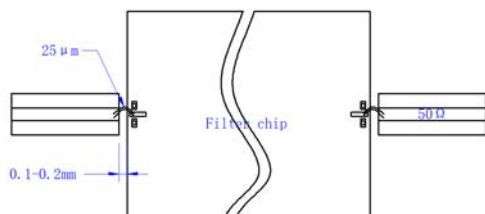
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16000	~	17000	MHz
中心损耗	/	/		4.2		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	15.3&17.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	15.25&17.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.4-33.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



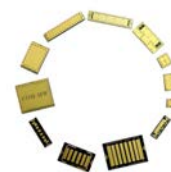
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

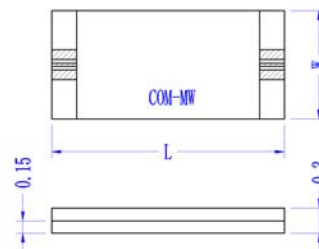
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

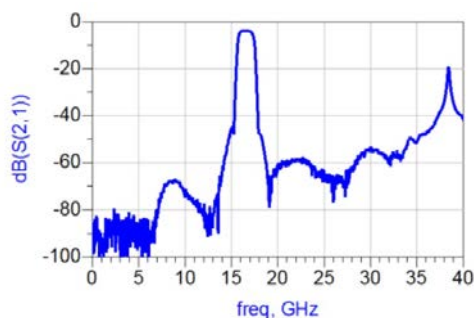
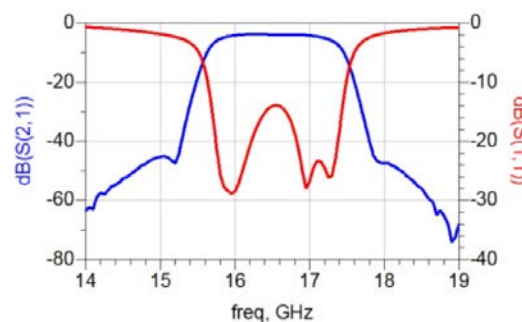
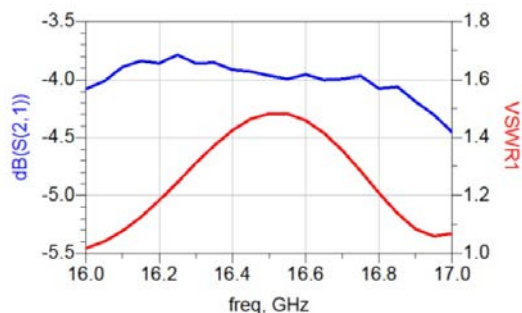


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

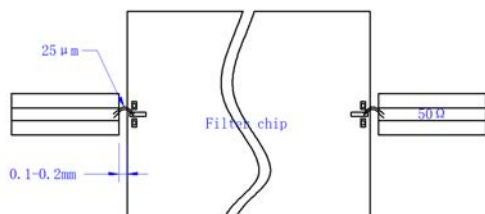
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16000	~	17300	MHz
中心损耗	/	/		3.5		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	14.85&18.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	14.6&18.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.3	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.95-30.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

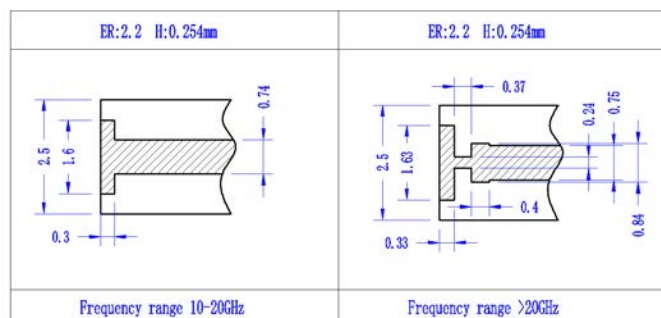
装配示意图



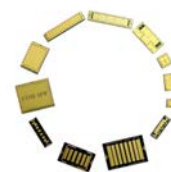
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

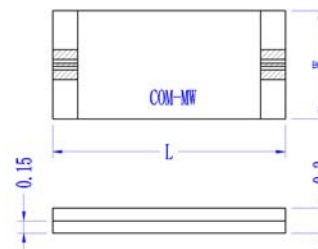
建议PCB布局图



参考实物图

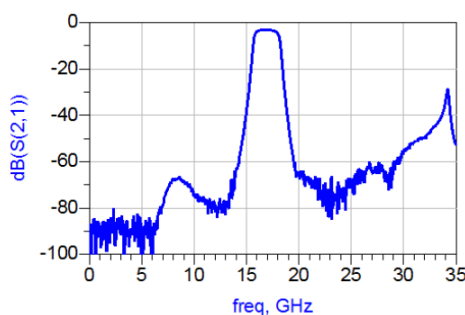
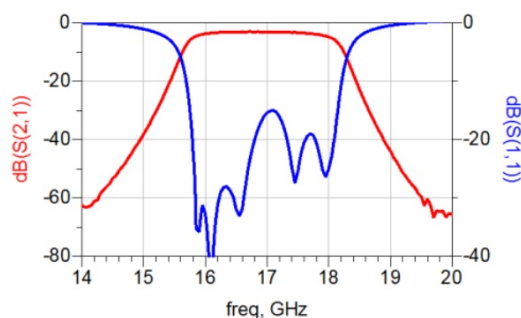
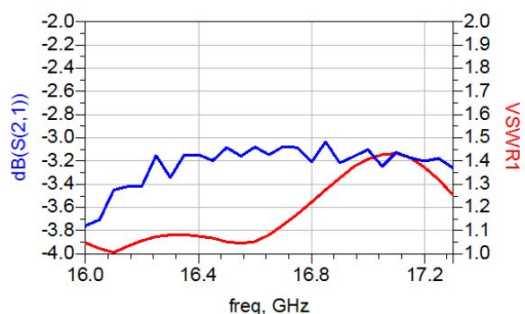


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	2.1	2.2	2.3

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

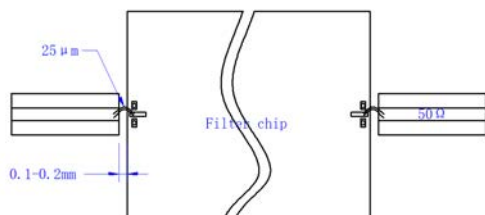
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16100	~	17300	MHz
中心损耗	/	/			2.7	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	15.35&18.05	GHz≥	30			dB
带外抑制	15.05&18.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-14.7	GHz≥	50			dB
带外抑制	18.6-29	GHz≥	48			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

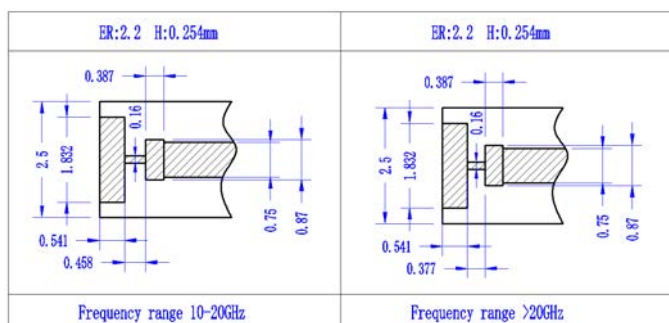
装配示意图



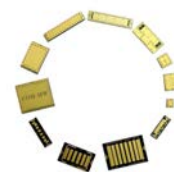
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

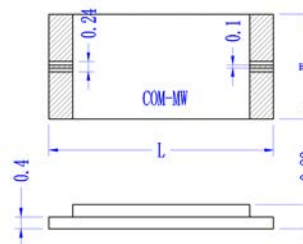
建议PCB布局图



参考实物图

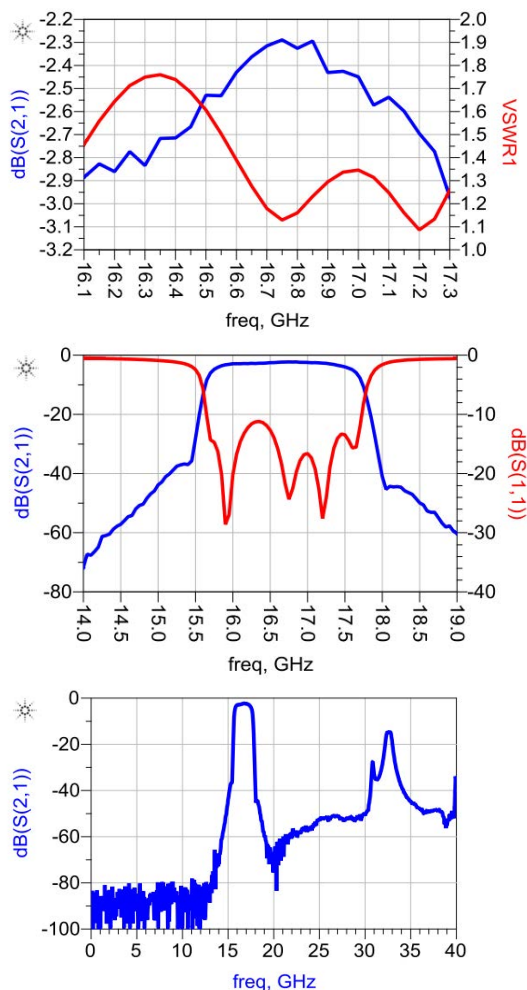


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.4	7.5	7.6
W	2.8	2.9	3.0

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

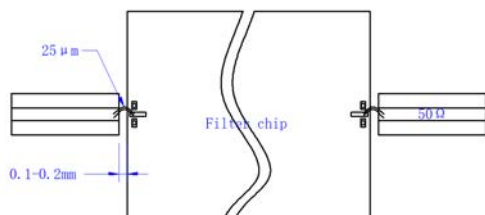
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16500	~	18000	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	15.65&18.8	GHz≥	30			dB
带外抑制	15.4&19.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.7-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



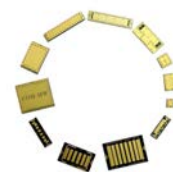
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

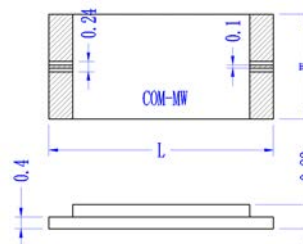
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

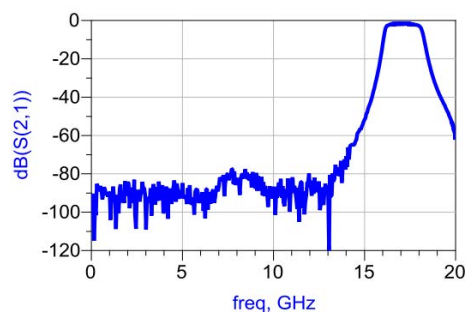
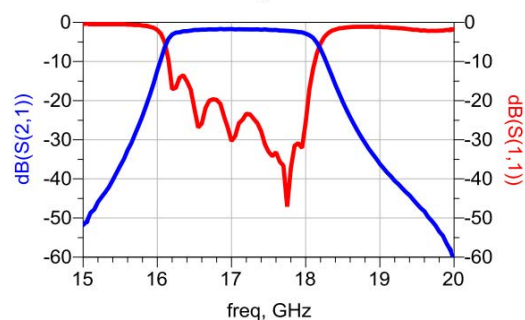
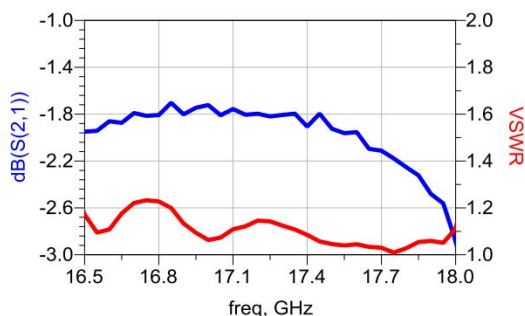


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8	8.1	8.2
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

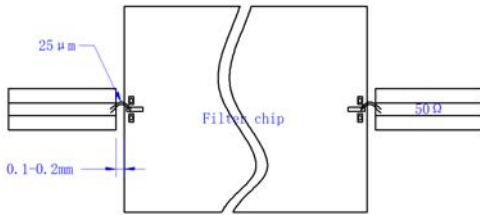
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16600	~	18200	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	15.8&19.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	15.55&19.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.2	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.3-20	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.4ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

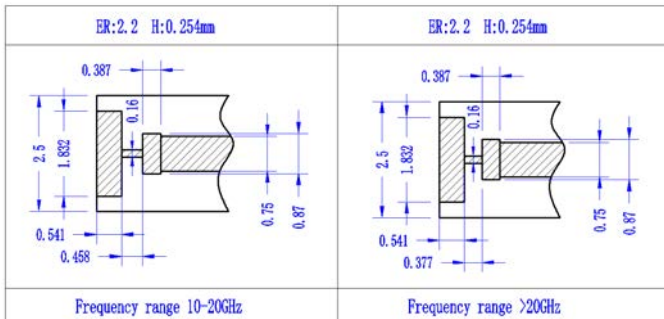
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

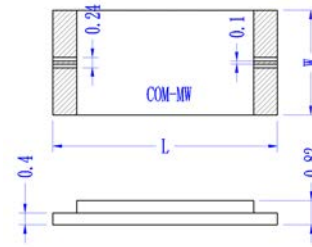
建议PCB布局图



参考实物图

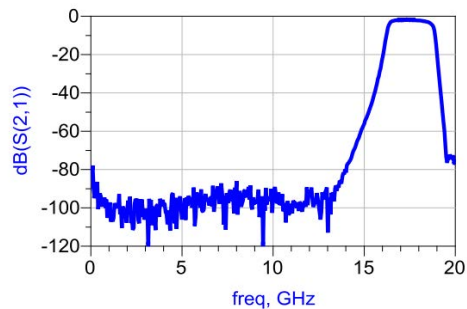
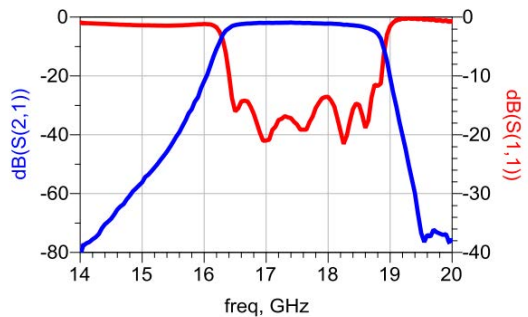
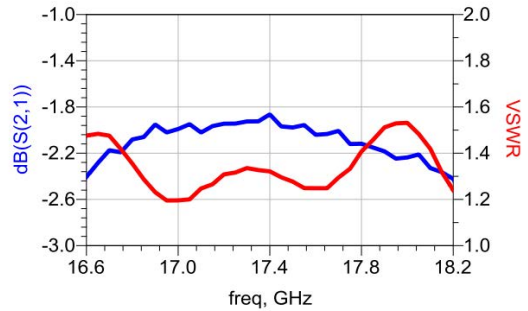


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.2	8.3	8.4
W	2.2	2.3	2.4

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

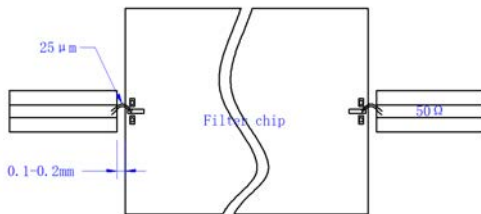
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	16700	~	23000	MHz
中心损耗	/	/			1.4	dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	15.15&24.5	GHz≥	20			dB
带外抑制	14.8&25.05	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-14.55	GHz≥	40			dB
带外抑制	25.7-34.8	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

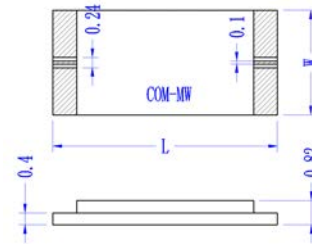
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

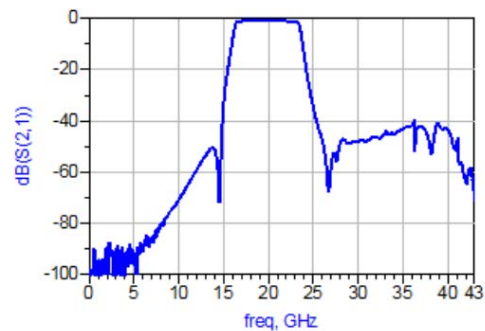
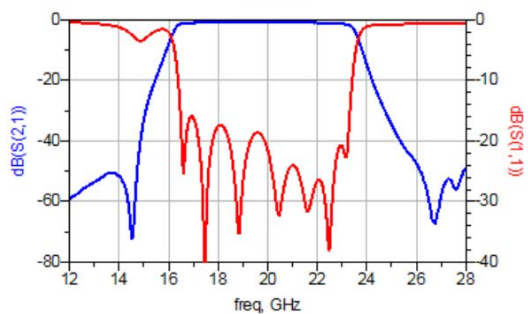
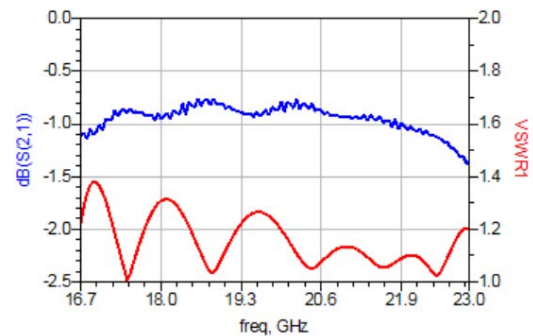


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.4	6.5	6.6
W	2.3	2.4	2.5

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

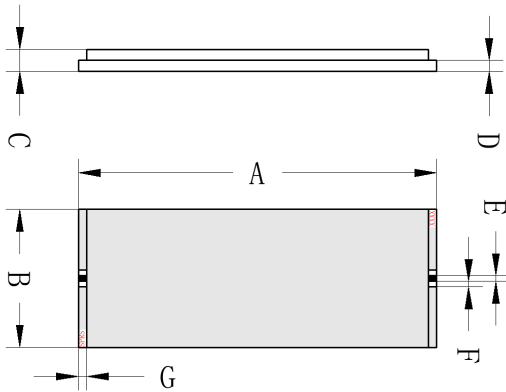
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.7	GHz
工作带宽	16.9-18.5	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	40@19.8-27.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:6.8, B:2.4, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.64

外形图：端口居中



推荐装配图

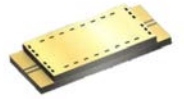


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

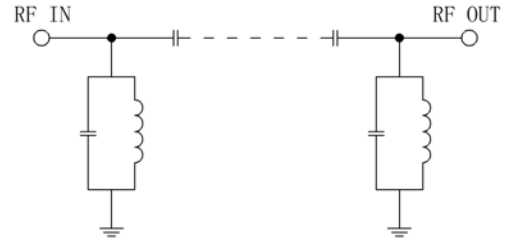
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

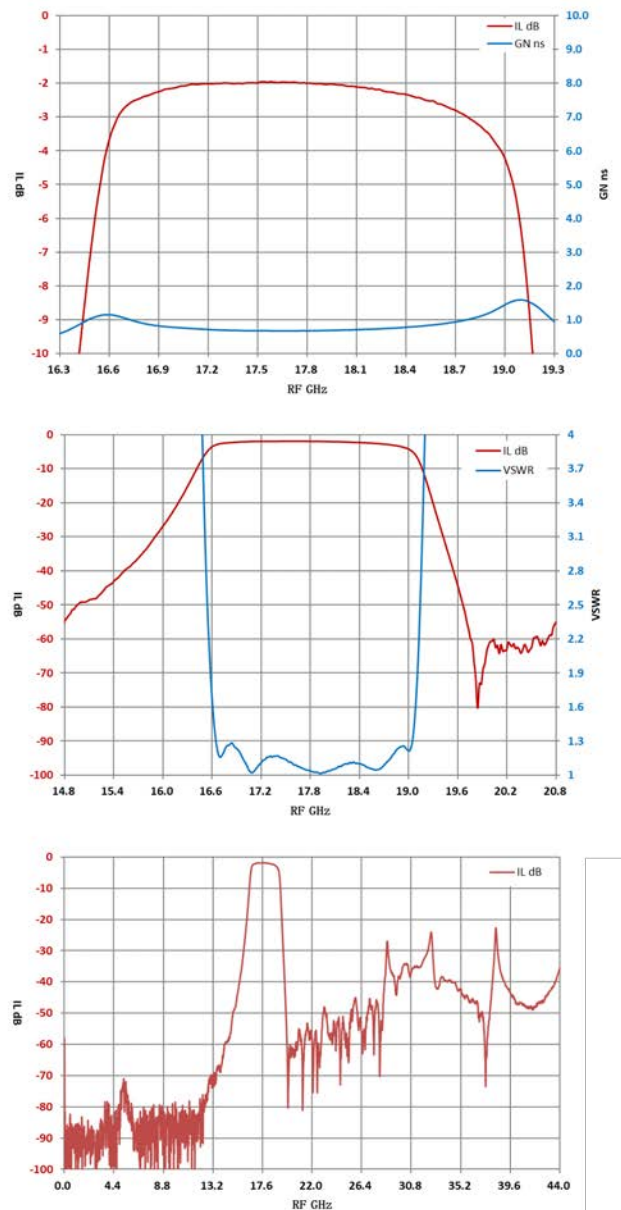
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

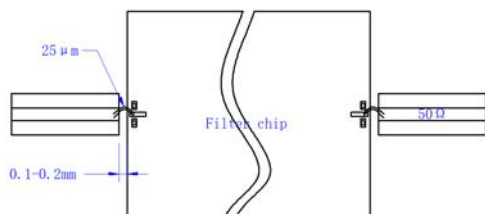
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17000	~	18000	MHz
中心损耗	/	/		4.3		dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	16.25&18.85	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.05&19.0	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.7	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.45-36	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



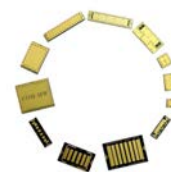
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

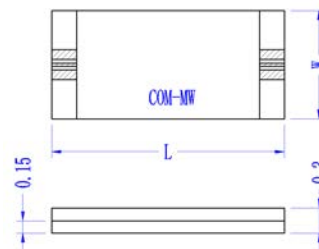
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

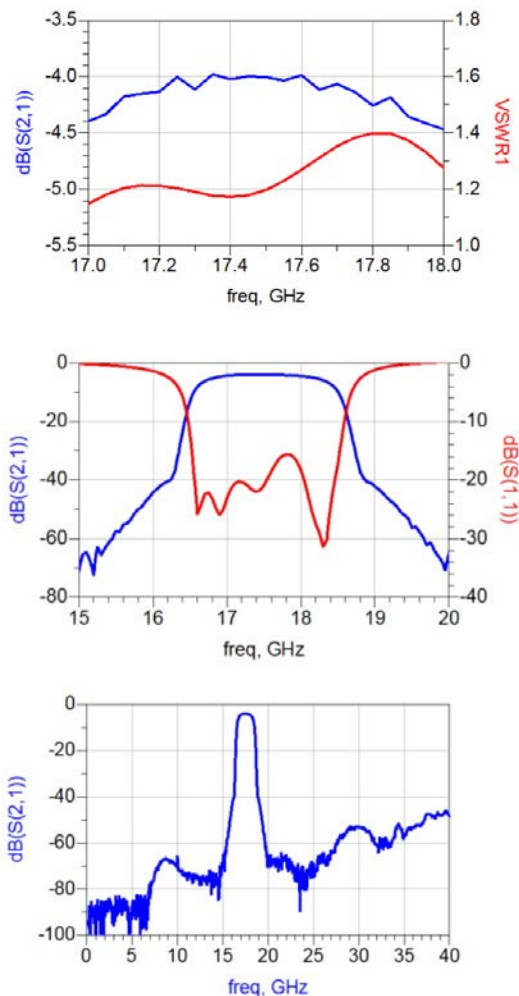


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	2.0	2.1	2.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

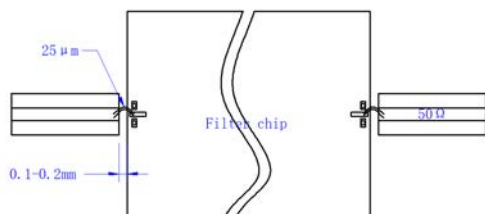
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17200	~	18500	MHz
中心损耗	/	/		3.9		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	16.1&19.75	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.0&19.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	20.0-37.0	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



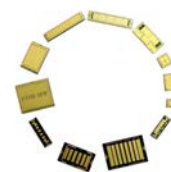
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

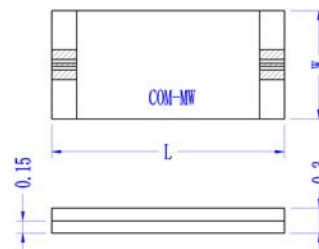
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

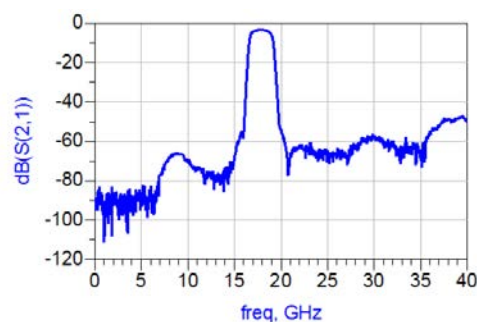
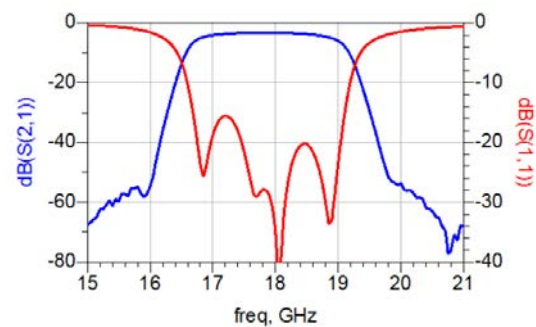
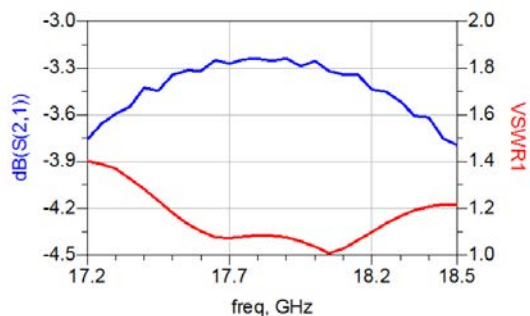


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.9	2.0	2.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

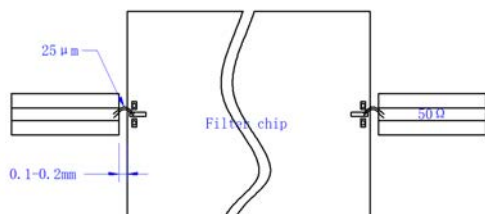
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17300	~	19300	MHz
中心损耗	/	/		3.3		dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	16.2&20.55	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.1&20.7	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.5	GHz≥	50			dB
带外抑制	21.45-36.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

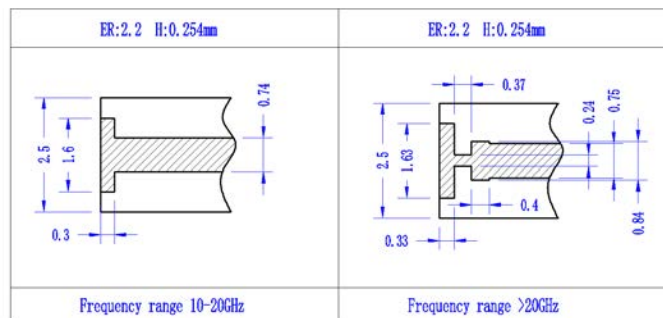
装配示意图



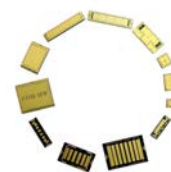
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

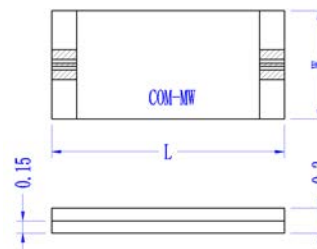
建议PCB布局图



参考实物图

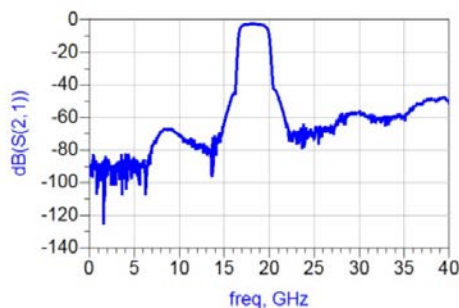
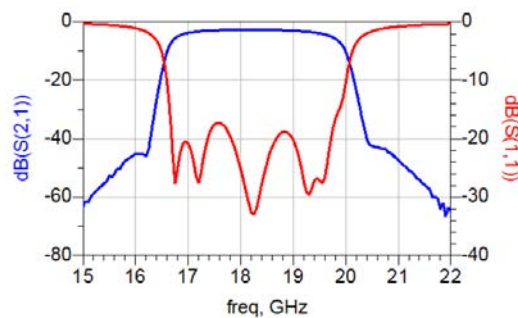
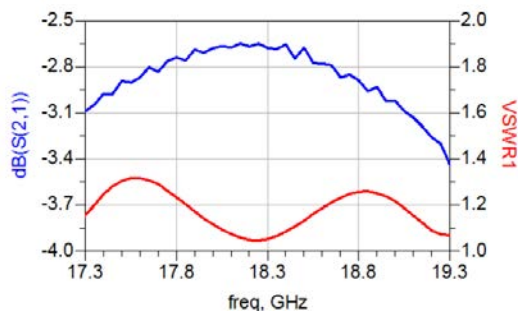


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.9	2.0	2.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

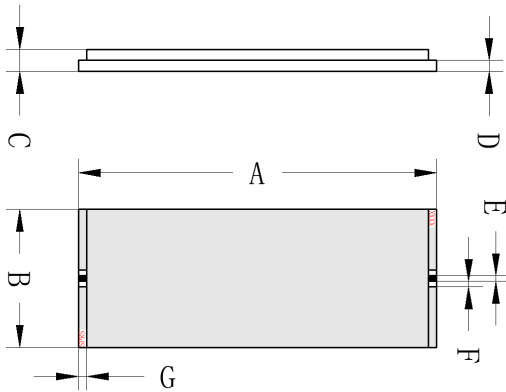
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.8	GHz
工作带宽	17.7-19.9	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-16.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.2-31.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:7.1, B:2.1, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.54

外形图：端口居中



推荐装配图

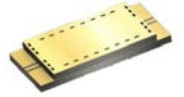


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

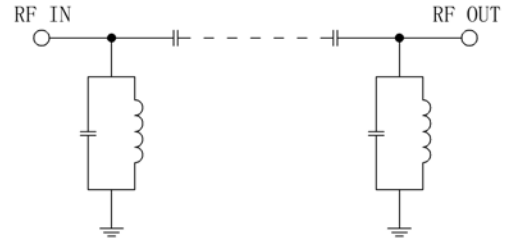
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

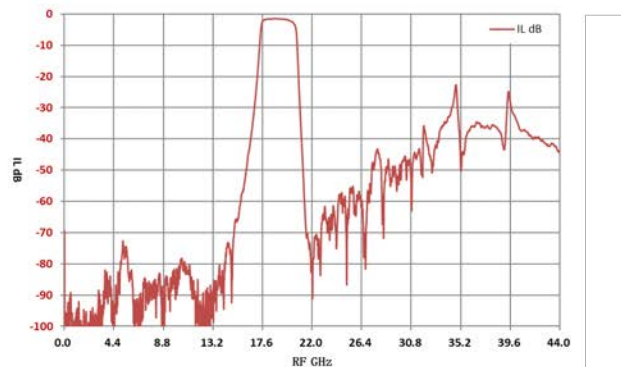
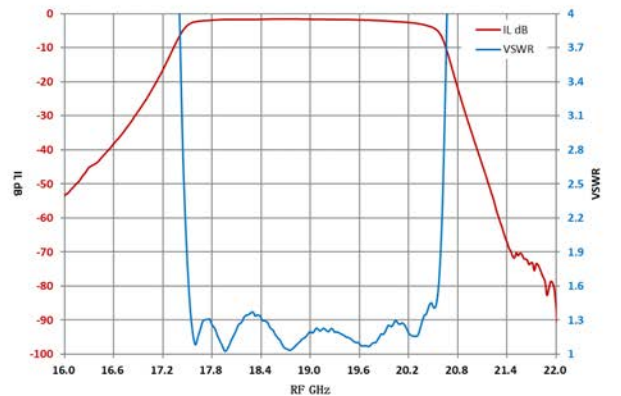
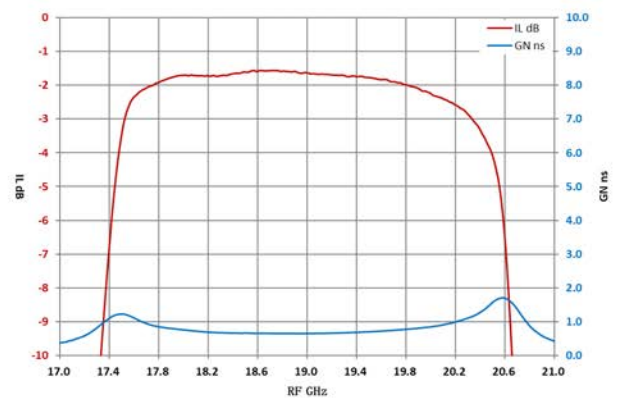
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

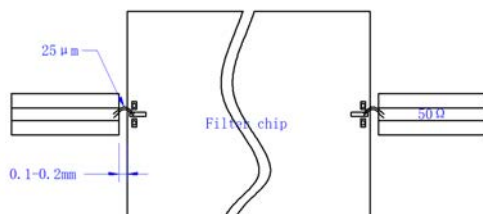
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17900	~	18100	MHz
中心损耗	/	/			7.6	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	16.9&19	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.8&19.05	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-16.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	19.3-35.35	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

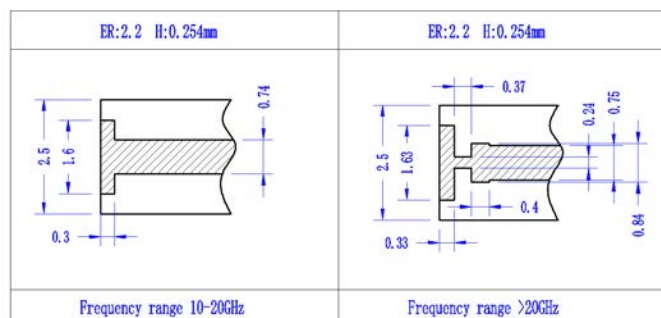
装配示意图



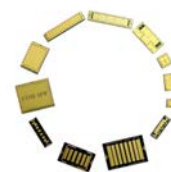
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

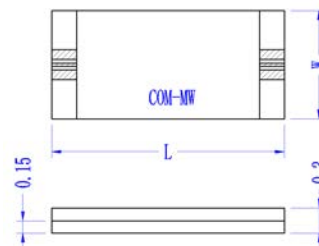
建议PCB布局图



参考实物图

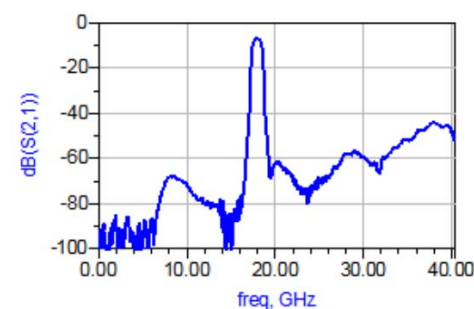
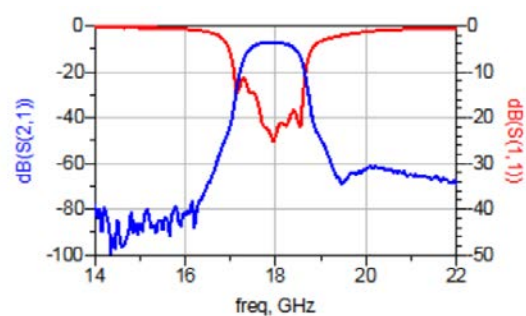
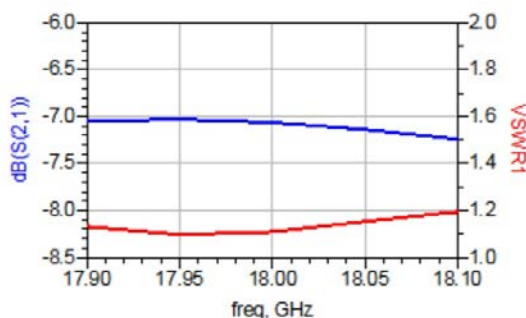


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.4	4.4	4.6
W	1.9	2.0	2.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

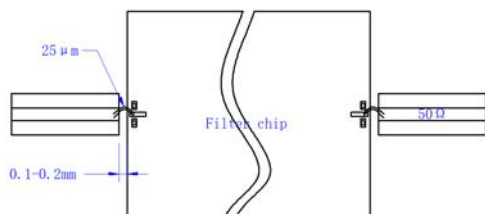
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	17900	~	18900	MHz
中心损耗	/	/		3.8		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	16.65&20.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.5&20.35	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.65	GHz≥	50			dB
带外抑制	20.5-36	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

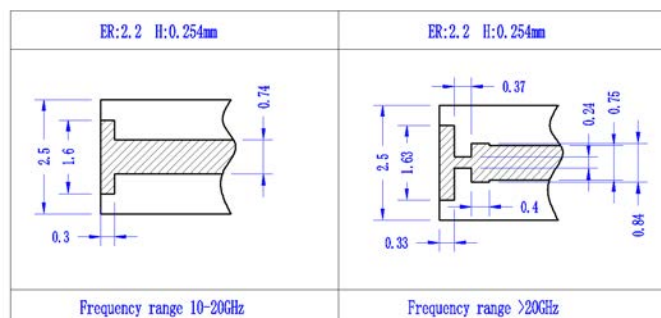
装配示意图



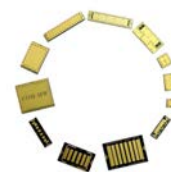
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

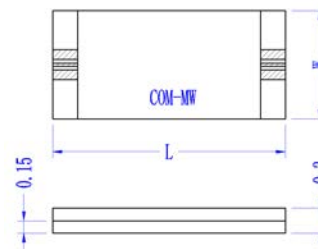
建议PCB布局图



参考实物图

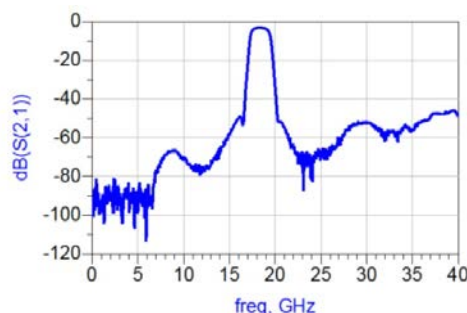
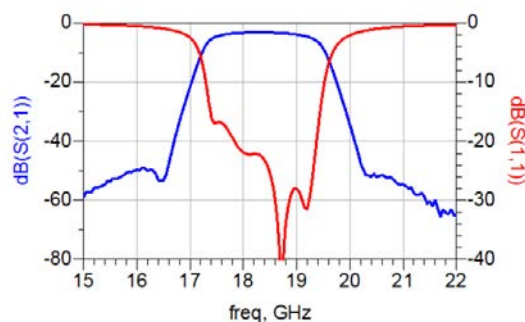
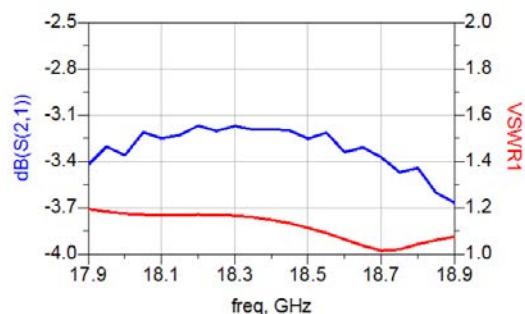


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.9	2.0	2.1

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

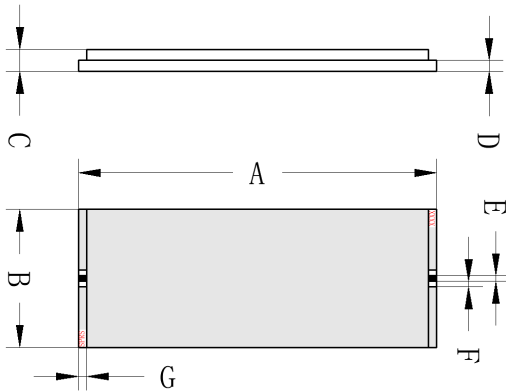
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.95	GHz
工作带宽	18.2-19.7	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@20.8-32.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:10.5, B:2.4, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.56

外形图：端口居中



推荐装配图

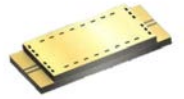


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

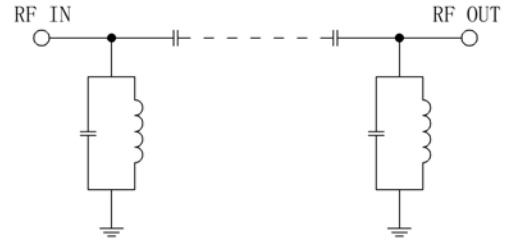
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

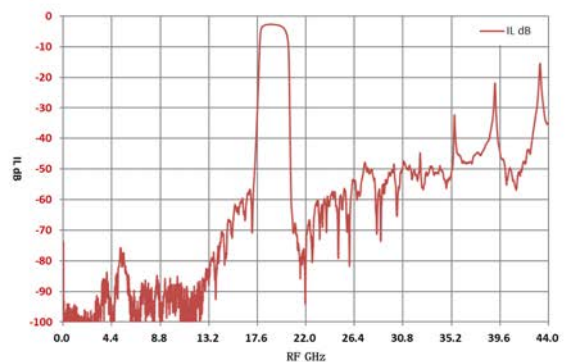
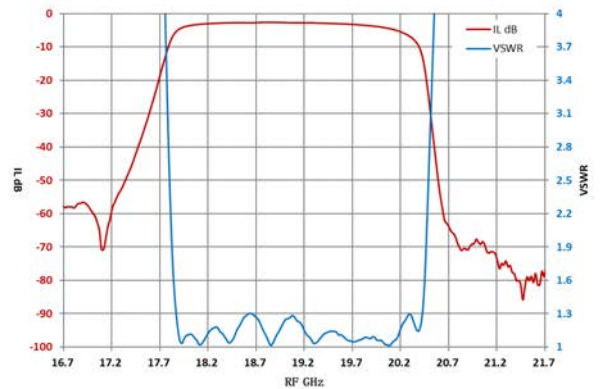
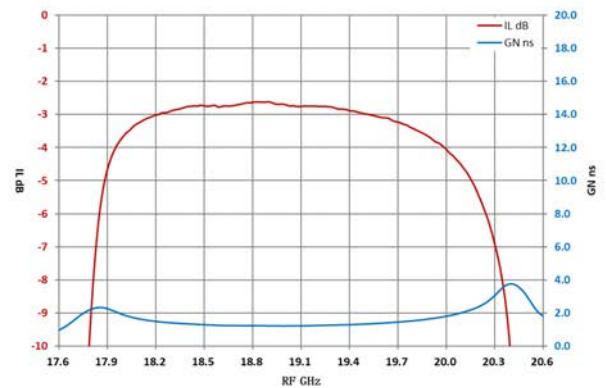
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

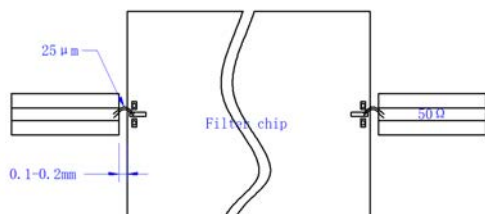
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	18700	~	19700	MHz
中心损耗	/	/		4.0		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	17.4&20.95	GHz≥	30			dB
带外抑制	17.2&21.15	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-16.6	GHz≥	50			dB
带外抑制	21.35-36.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



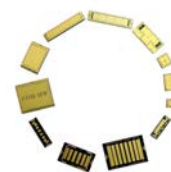
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

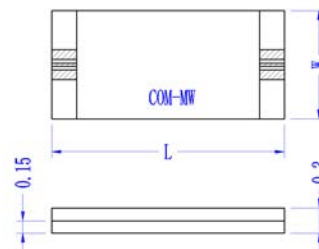
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

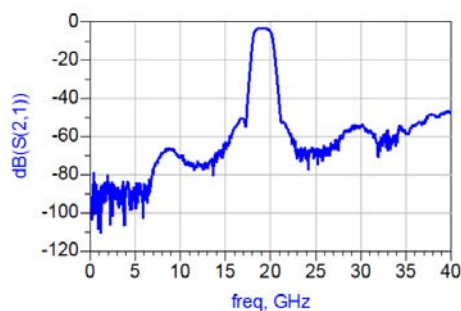
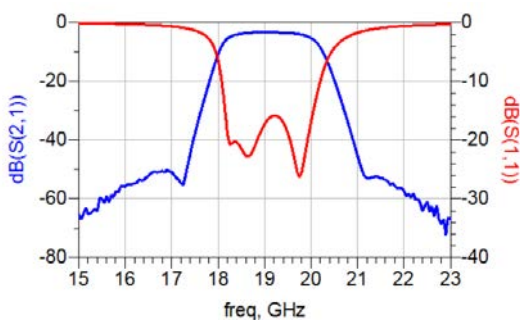
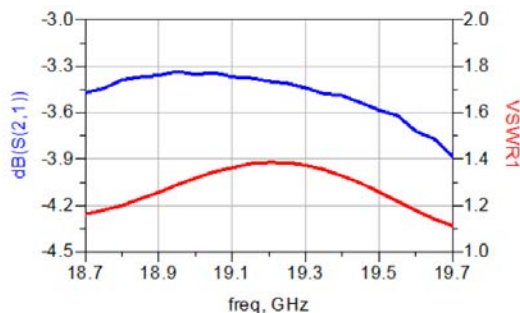


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.8	1.9	2.0

典型测试曲线图





产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

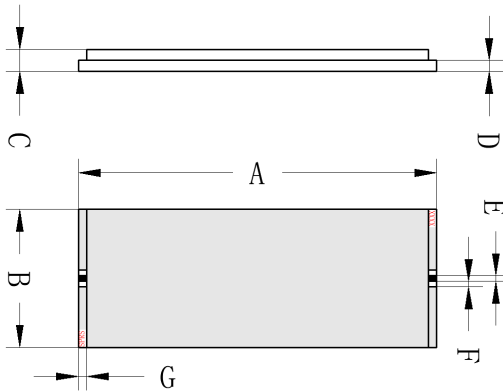
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.5	GHz
工作带宽	19.0-20.0	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-17.9GHz	dBc
带外抑制	40@21.1-30.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.8, B:2.1, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.57

外形图：端口居中



推荐装配图

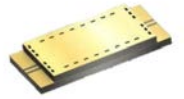


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10~40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10~70GHz

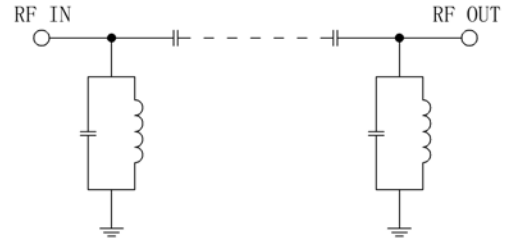
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

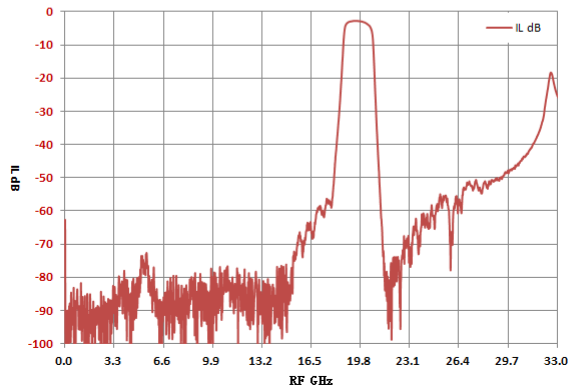
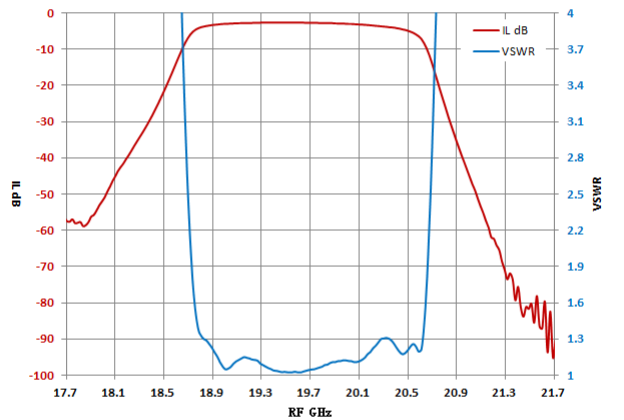
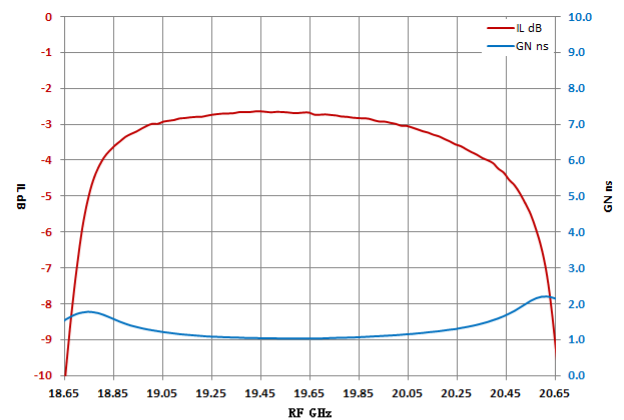
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

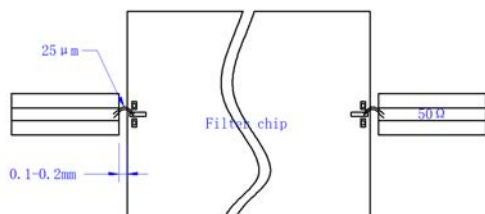
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	19000	~	20900	MHz
中心损耗	/	/		3.4		dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	17.75&22.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	17.7&22.35	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-17.05	GHz≥	50			dB
带外抑制	24.3-37.0	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



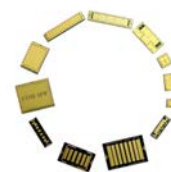
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

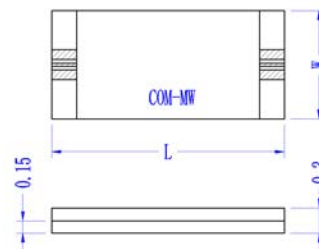
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

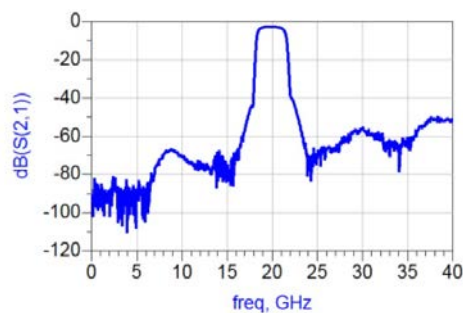
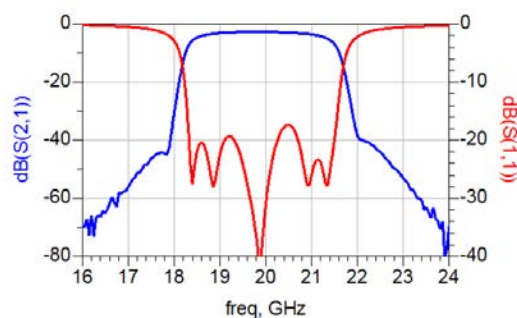
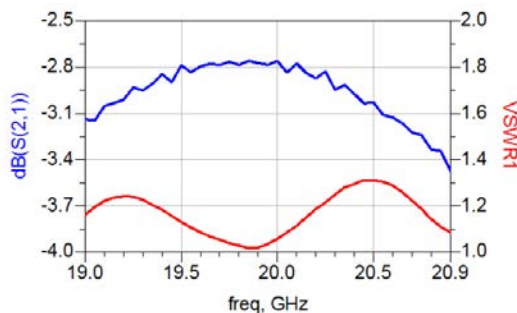


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.9	2.0	2.1

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

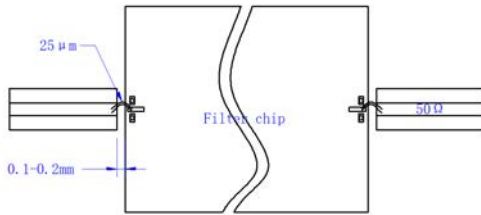
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	19000	~	23500	MHz
中心损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	17.35&24.35	GHz≥	30			dB
带外抑制	16.7&25.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-15.95	GHz≥	50			dB
带外抑制	25.6-30	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

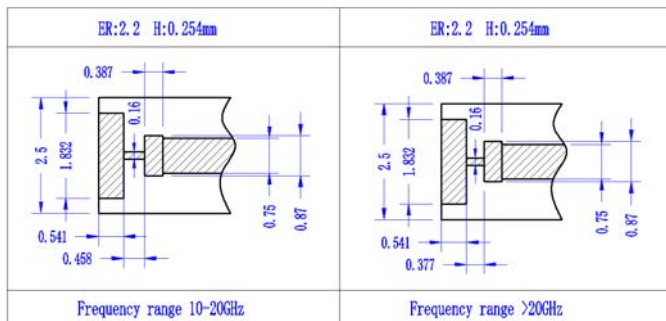
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

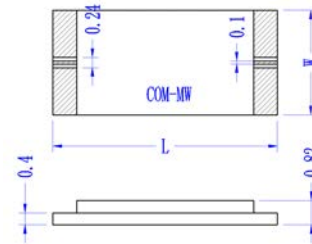
建议PCB布局图



参考实物图

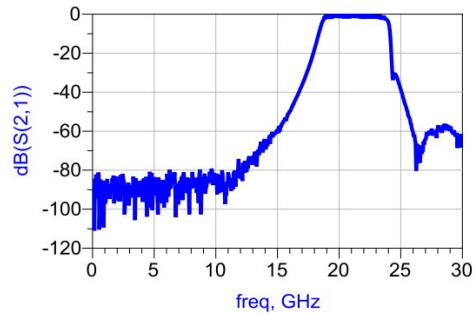
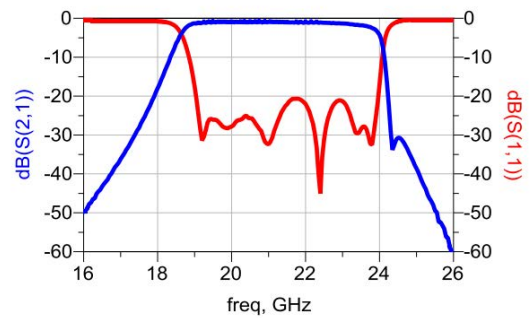
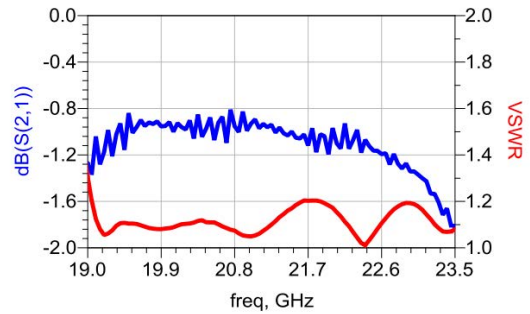


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.8	6.9	7.0
W	2.0	2.1	2.2

典型测试曲线图



产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

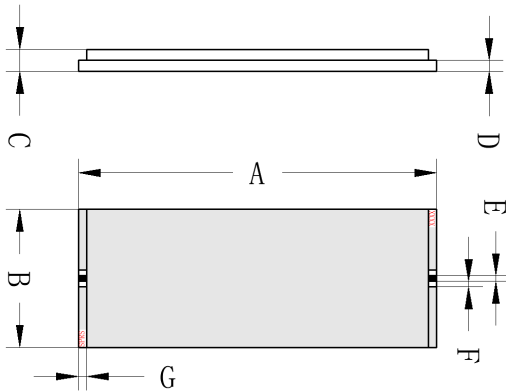
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.7	GHz
工作带宽	19.7-21.7	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-18.2GHz	dBc
带外抑制	40@23.0-32.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:7.1, B:2.1, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.42

外形图：端口居中



推荐装配图

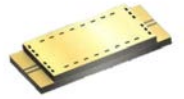


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

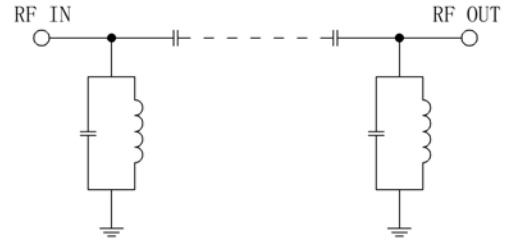
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

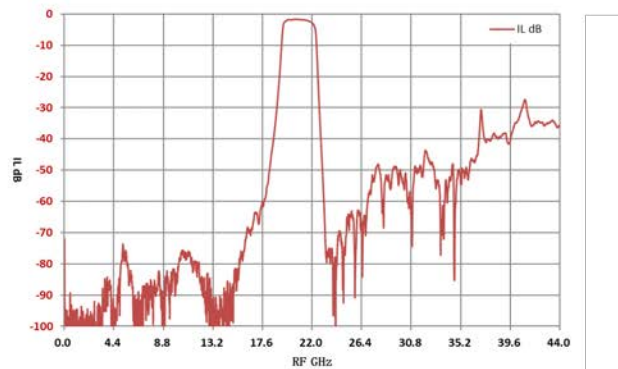
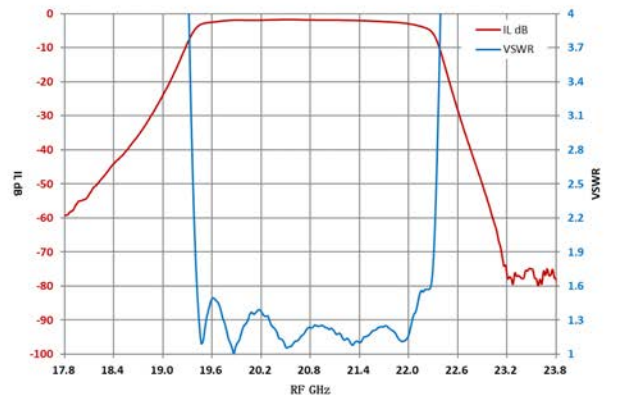
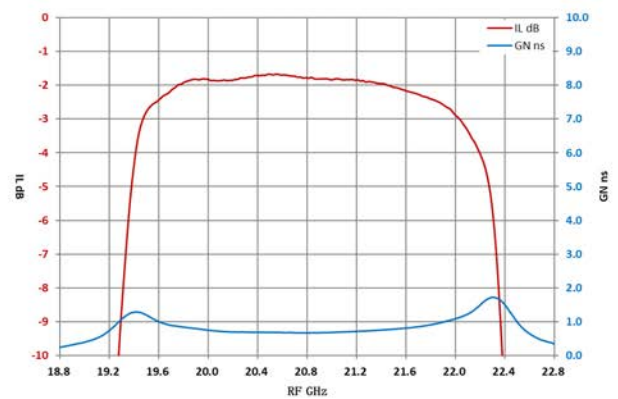
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

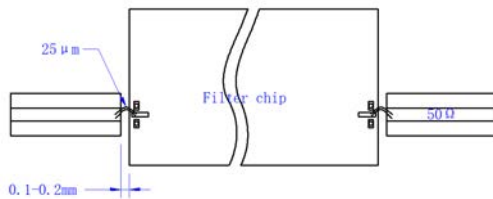
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	20000	~	22500	MHz
中心损耗	/	/			1.3	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	18.7&23.95	GHz≥	20			dB
带外抑制	18.5&24.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-18.3	GHz≥	40			dB
带外抑制	24.95-26.7	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

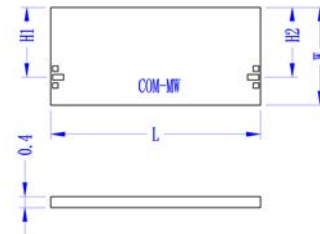
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

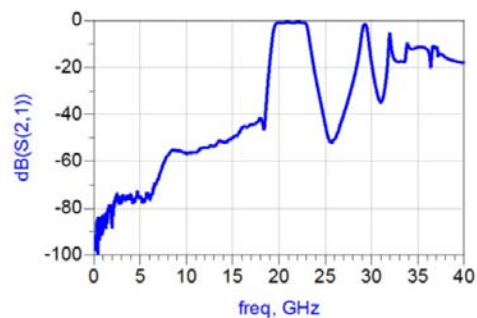
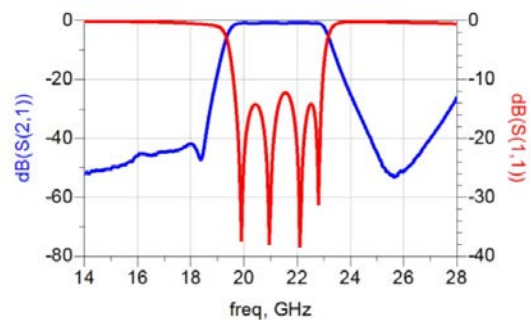
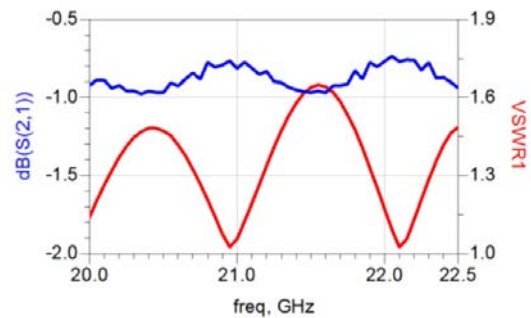


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.0	6.1	6.2
W	8.5	8.6	8.7
H1		6.89	
H2		6.89	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

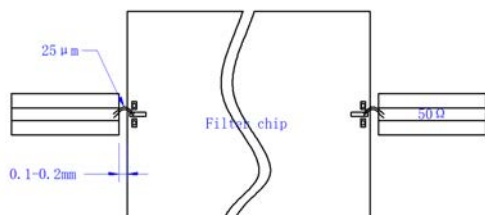
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	21400	~	22600	MHz
中心损耗	/	/			2.2	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	19.7&23.6	GHz≥	20			dB
带外抑制	18.9&24.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-17.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	24.8-27.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

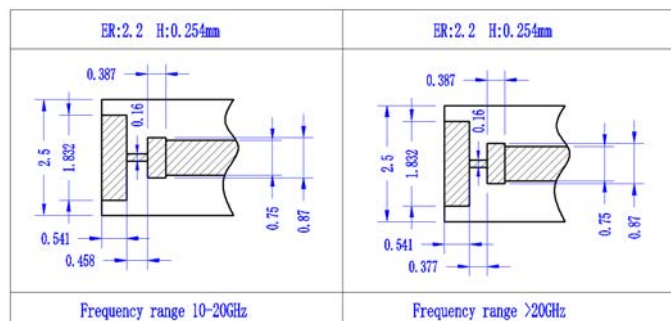
装配示意图



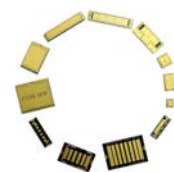
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

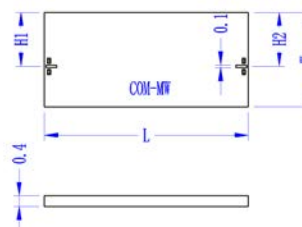
建议PCB布局图



参考实物图

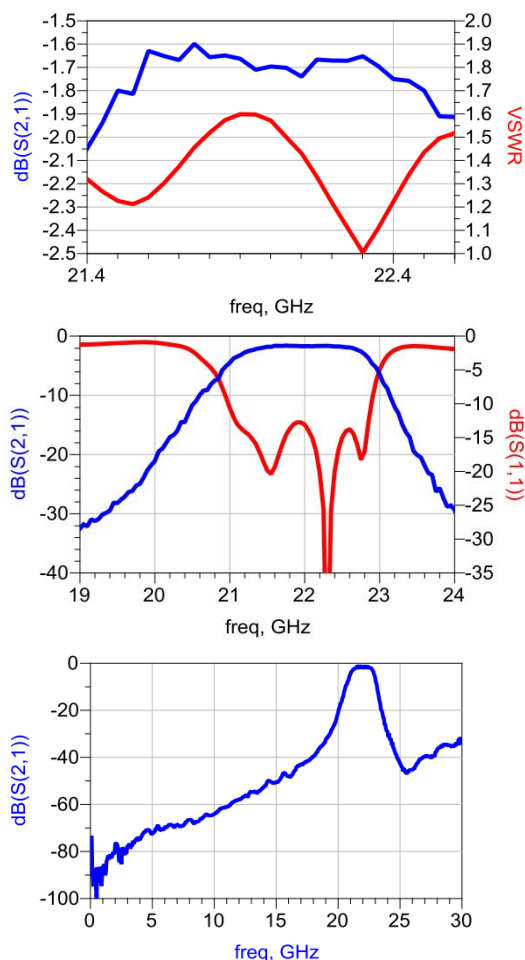


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.95	9.05	9.15
W	2.4	2.5	2.6
H1		1.16	
H2		1.34	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

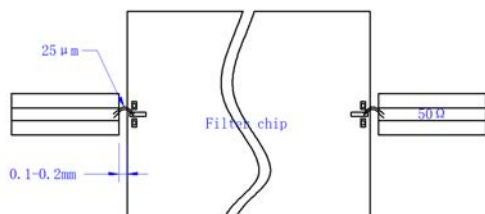
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	21500	~	22500	MHz
中心损耗	/	/		4.0		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	20.5&23.55	GHz≥	30			dB
带外抑制	19.45&24.35	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-18.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	25.15-35	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

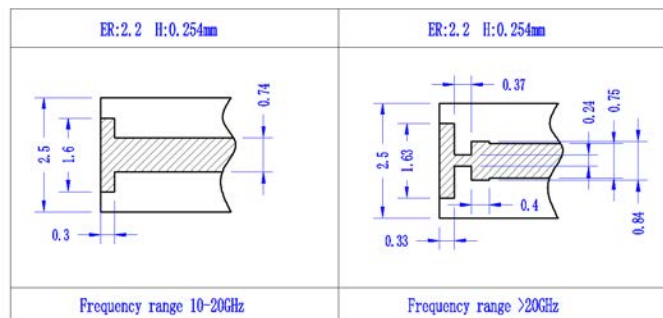
装配示意图



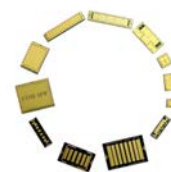
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

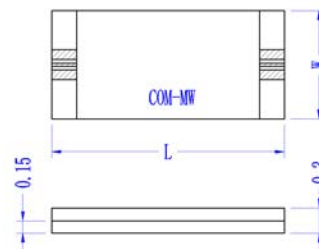
建议PCB布局图



参考实物图

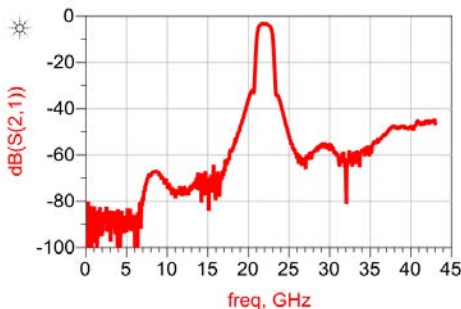
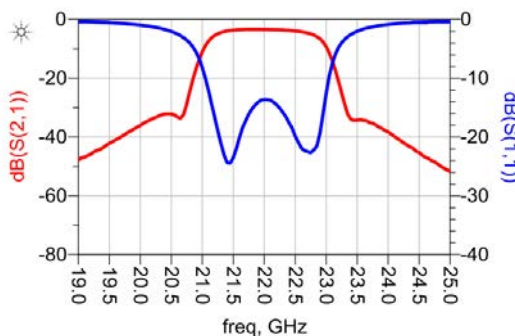
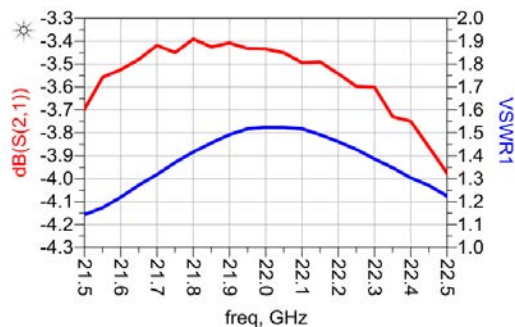


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.7	1.8	1.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

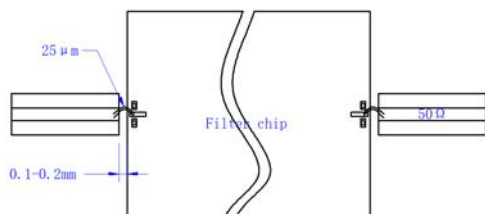
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	21500	~	22500	MHz
中心损耗	/	/		5.4		dB
带内波动	/	/			1.1	dB
带外抑制	20.7&23.25	GHz≥	30			dB
带外抑制	20.65&23.35	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-20.55	GHz≥	50			dB
带外抑制	23.55-38	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



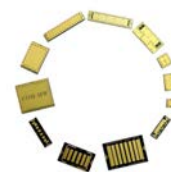
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C) 相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

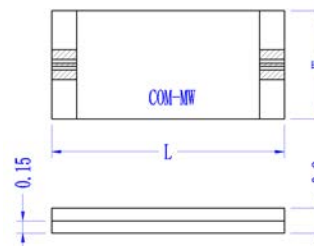
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

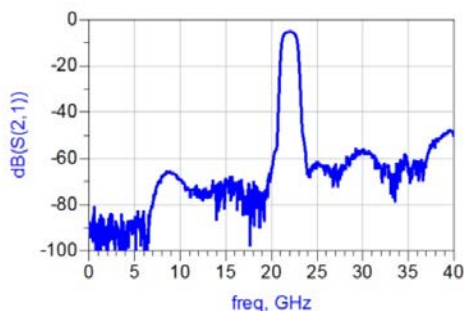
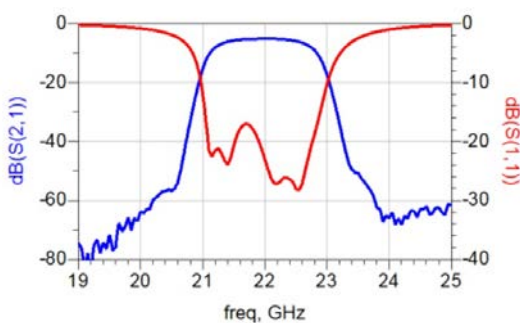


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.7	1.8	1.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

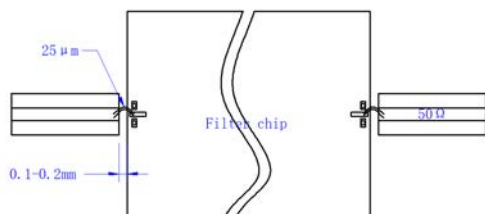
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	21500	~	22500	MHz
中心损耗	/	/		4.8		dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	20.45&23.75	GHz≥	30			dB
带外抑制	20.3&23.9	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-20.2	GHz≥	50			dB
带外抑制	24-36	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.7	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

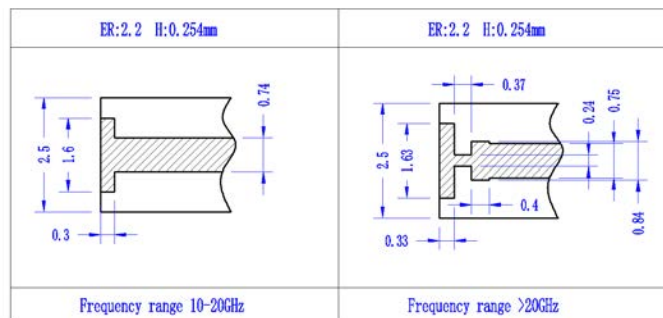
装配示意图



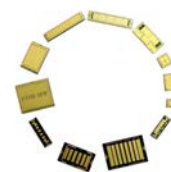
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

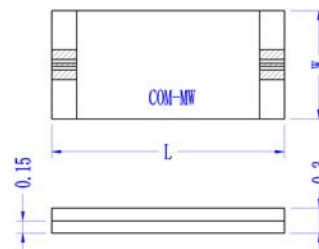
建议PCB布局图



参考实物图

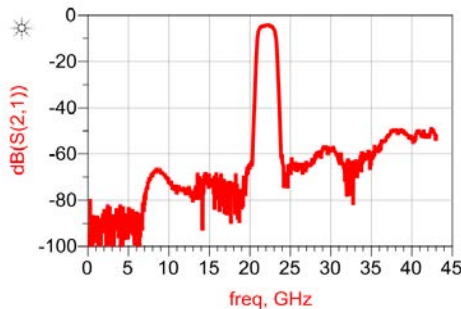
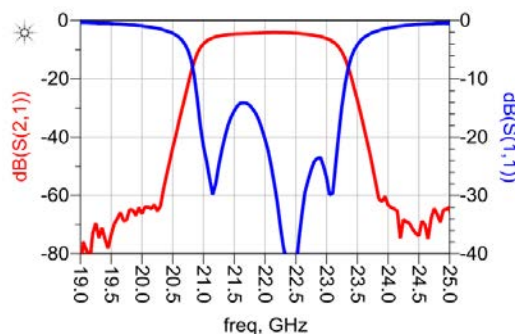
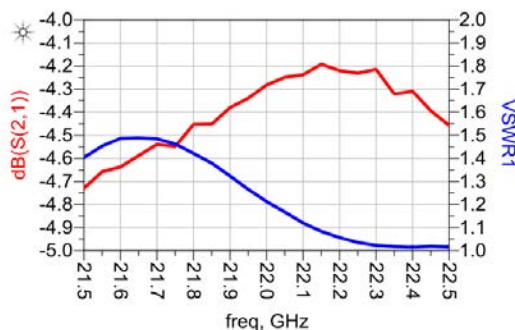


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.7	1.8	1.9

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

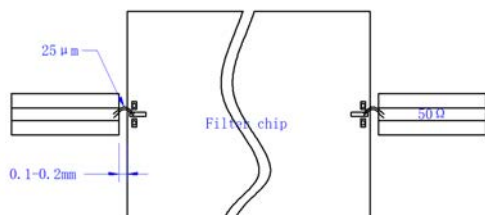
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	21700	~	22300	
中心损耗	/	/			3.5	dB
带内波动	/	/			1.8	dB
带外抑制	21.1&23.0	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	21&23.25	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-20.8	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	23.65-29.6	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤ 0.4 ns
相位一致性	$\leq \pm 5^\circ$
工作温度	-55~+85 $^\circ$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^\circ$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



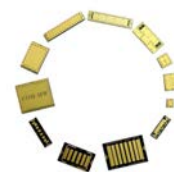
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥ 3 mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/ $^\circ$ C)相当的载体上, 载体厚度 ≥ 0.2 mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

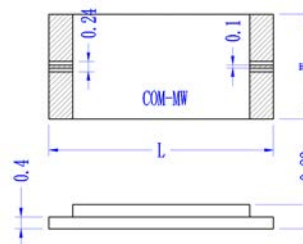
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

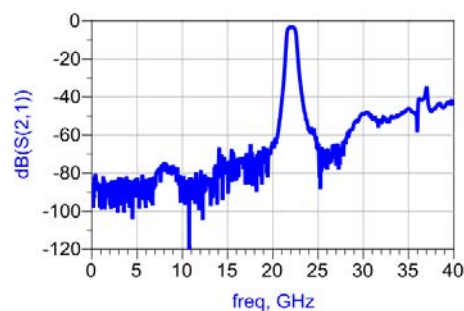
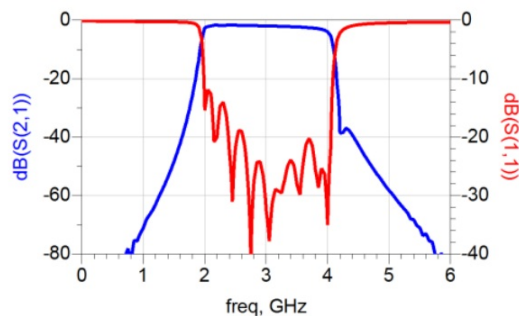
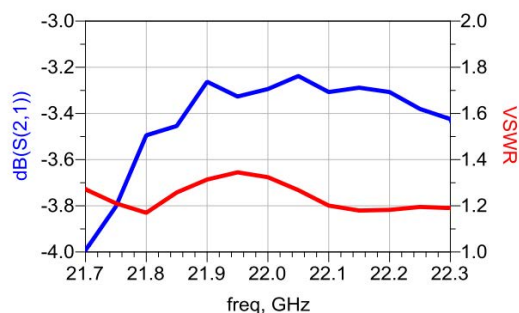


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.14	8.24	8.34
W	2.04	2.14	2.24

典型测试曲线图



产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

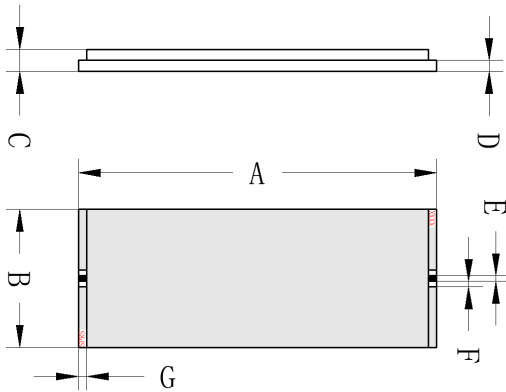
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.7	GHz
工作带宽	23.7-25.7	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-21.6GHz	dBc
带外抑制	40@27.0-31.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:1.9, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.28

外形图：端口居中



推荐装配图

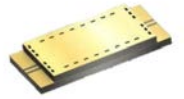


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10-40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10-70GHz

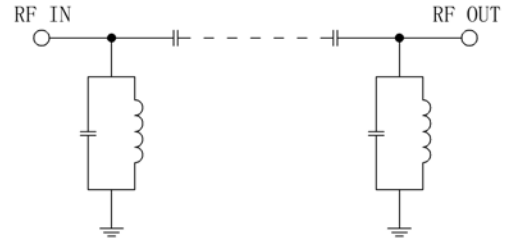
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

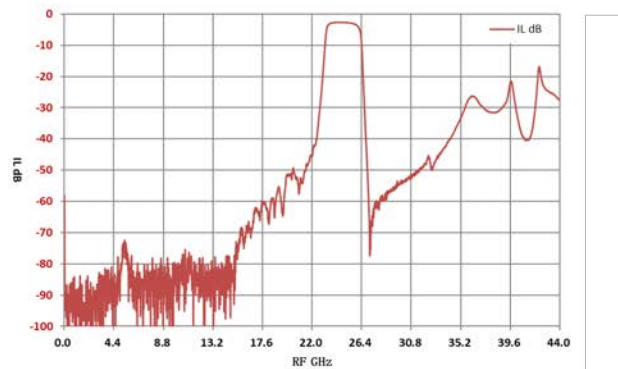
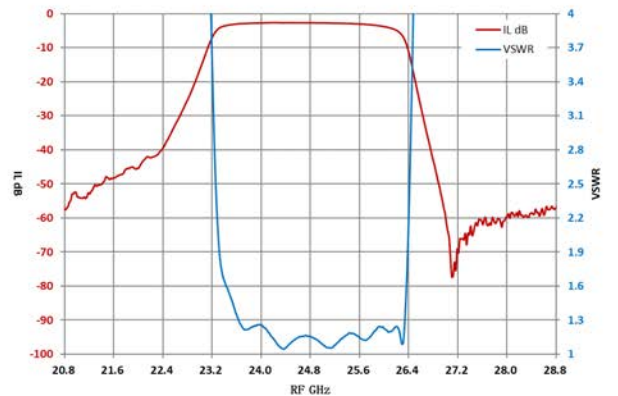
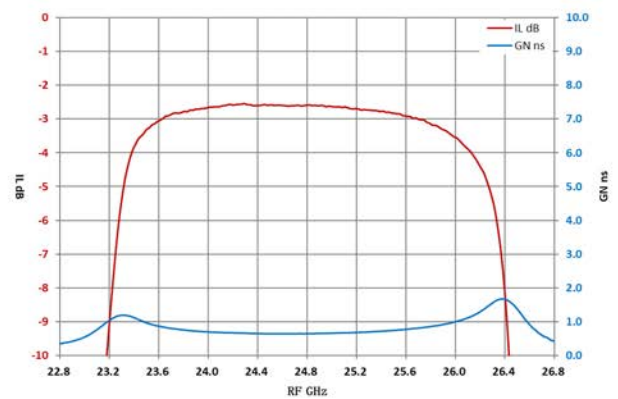
参考实物图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

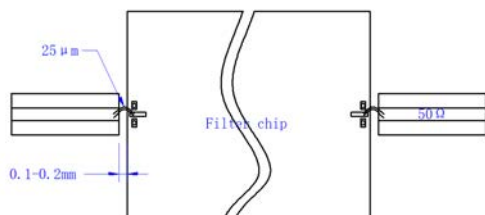
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24000	~	30000	MHz
中心损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	21.0&32.1		30			dB
带外抑制	20.0&32.25	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-18.9	GHz≥	50			dB
带外抑制	33.5-39.2	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.4ns
相位一致性	±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



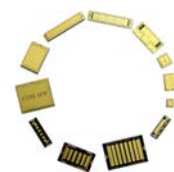
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

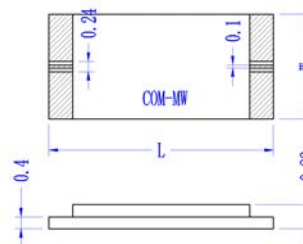
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

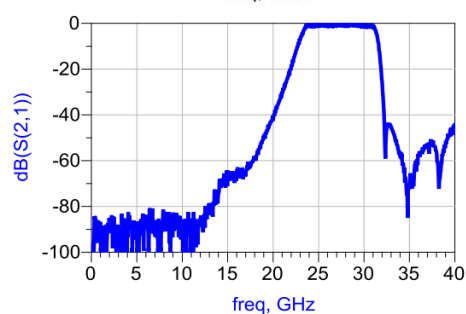
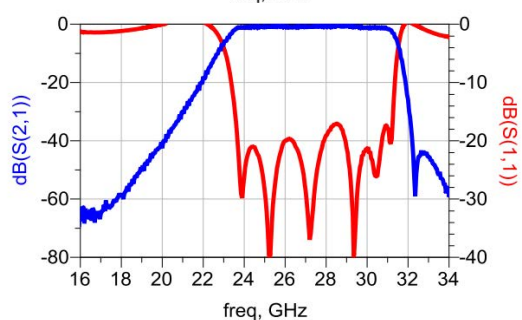
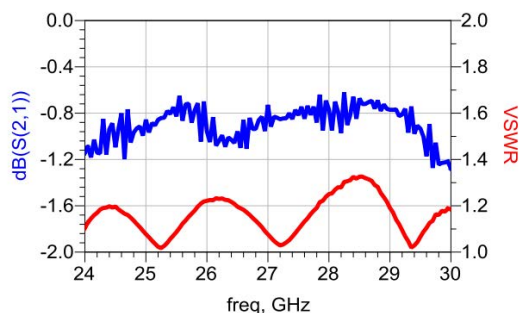


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.1	6.2	6.3
W	1.8	1.9	2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

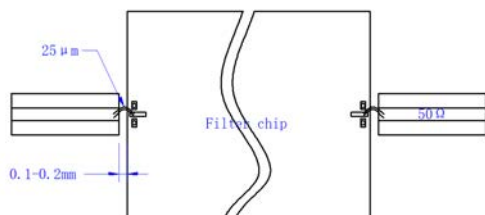
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24700	~	25300	MHz
中心损耗	/	/			3.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	23.8&26.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	23.55&26.45	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-23.2	GHz≥	50			dB
带外抑制	26.55-29.75	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.4ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



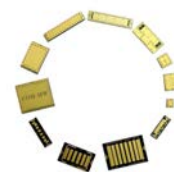
装配及使用说明

1. 芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
2. 芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
3. 芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
4. 微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
5. 硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

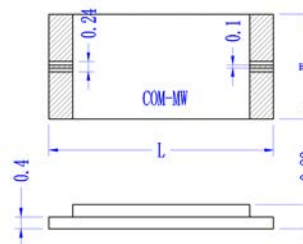
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

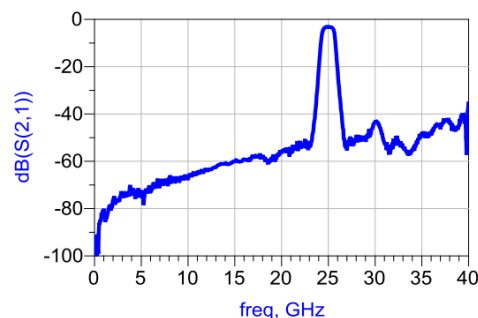
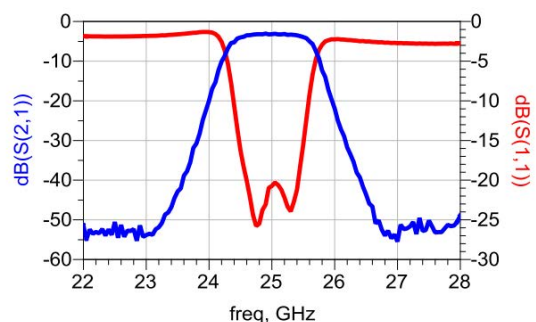
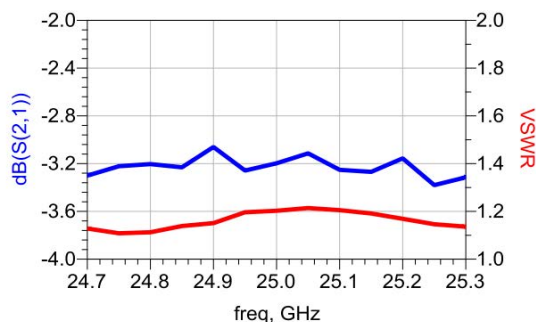


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.6	7.7	7.8
W	1.8	1.9	2

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

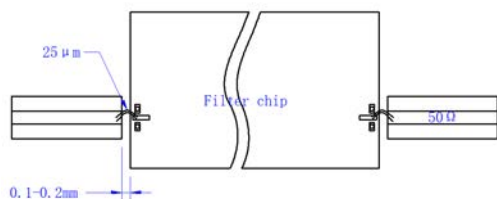
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	25000	~	27000	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	24.1&27.9	GHz≥	20			dB
带外抑制	23.75&28.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-23.25	GHz≥	40			dB
带外抑制	28.3-36.0	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.8ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



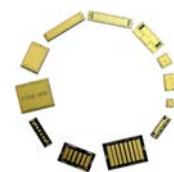
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;

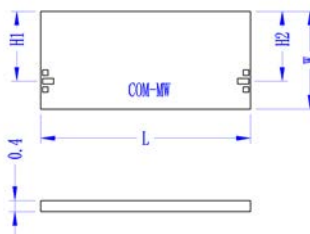
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

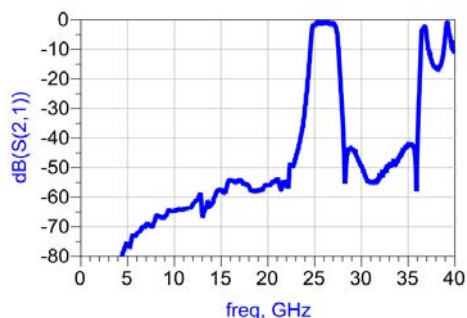
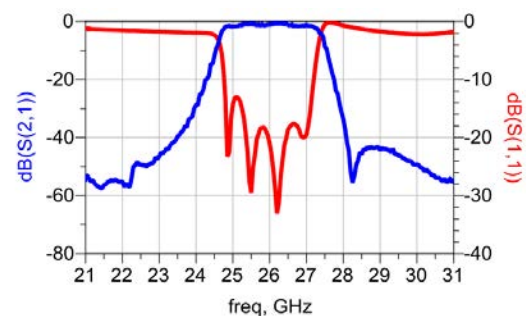
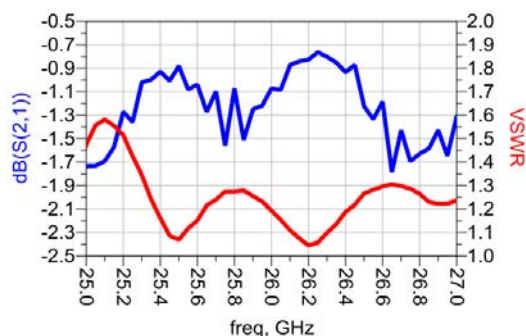


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	10.0	10.1	10.2
W	4.9	5.0	5.1
H1		3.39	
H2		3.39	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

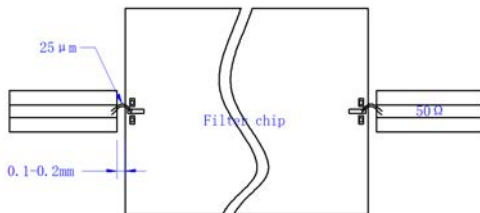
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	26000	~	40000	MHz
中心损耗	/	/		2.0		dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	24.2&43.05	GHz≥	20			dB
带外抑制	24.05&43.5	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-22.0	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

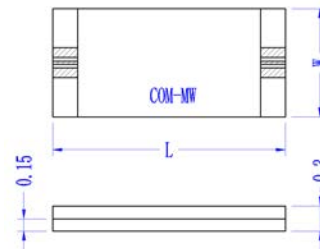
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

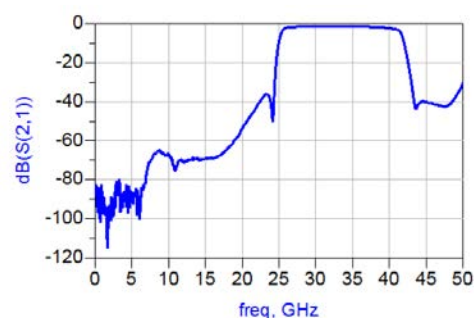
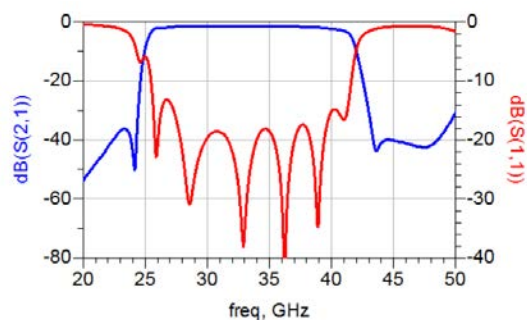
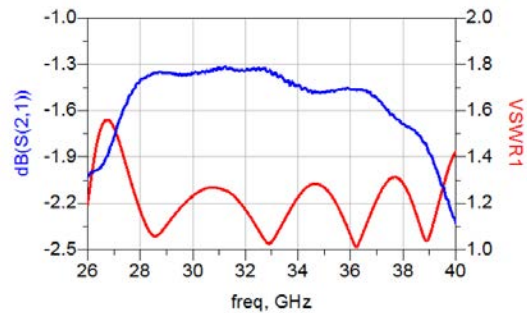


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.4	1.5	1.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50 Ω 共面波导输出, 金丝键合。

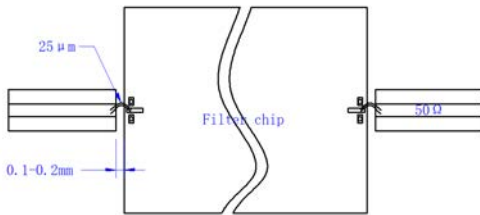
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	27000	~	28000	MHz
中心损耗	/	/		5.4		dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	25.95&28.8	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	25.85&28.95	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	DC-25.6	GHz $\geq$	50			dB
带外抑制	25.9-39	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	$\leq$ 0.6ns
相位一致性	$\leq$ 5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 $\geq$ 3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 $\geq$ 0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50 μ m $\times$ 10 μ m 的金带或 2 根 25 μ m 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

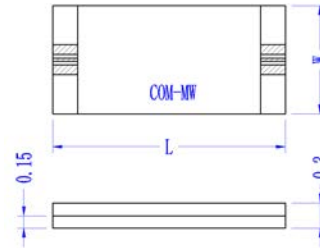
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

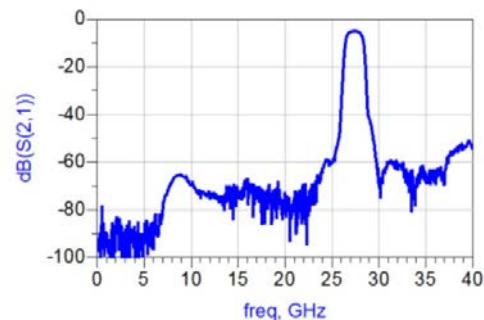
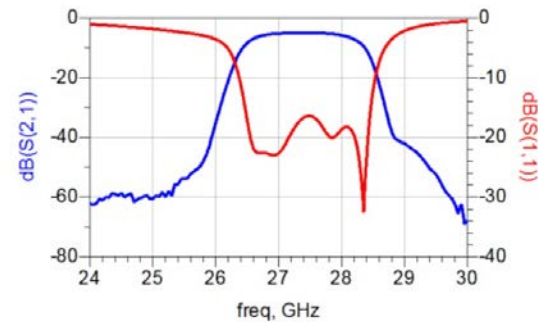
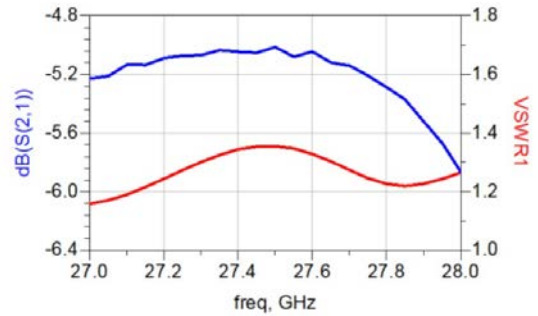


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.6	1.7	1.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

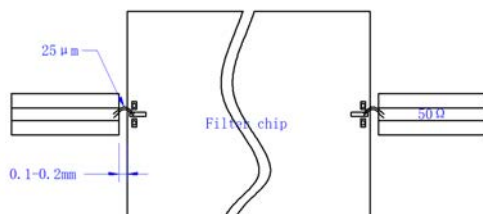
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	27500	~	30000	MHz
中心损耗	/	/			3.3	dB
带内波动	/	/			1.9	dB
带外抑制	25.65&31.5	GHz≥	30			dB
带外抑制	25.45&31.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-24.7	GHz≥	50			dB
带外抑制	31.8-43.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

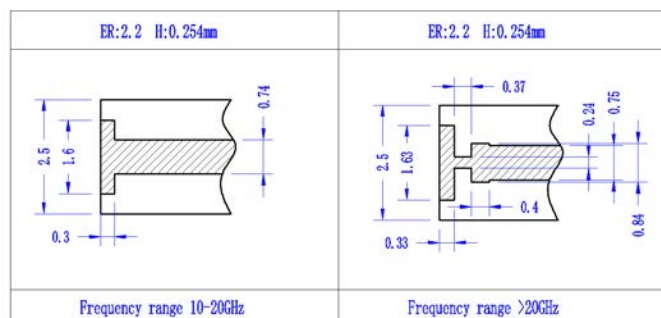
装配示意图



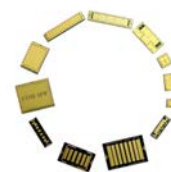
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

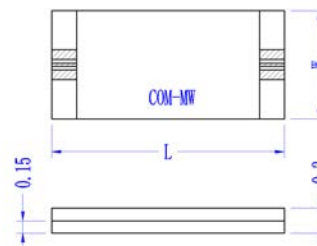
建议PCB布局图



参考实物图

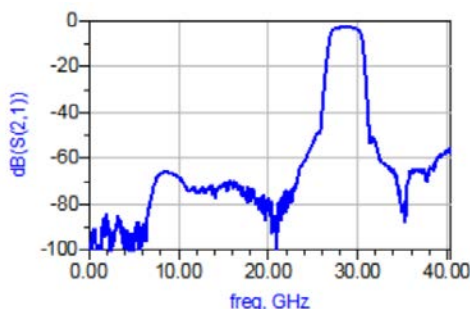
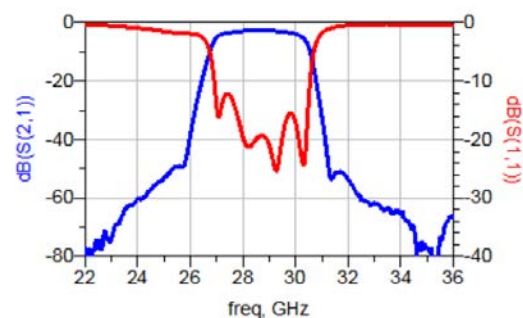
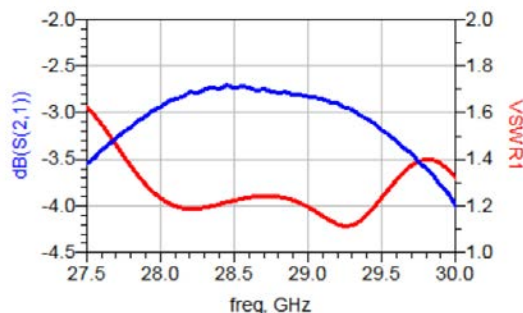


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.8	3.9	4.0
W	1.6	1.7	1.8

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

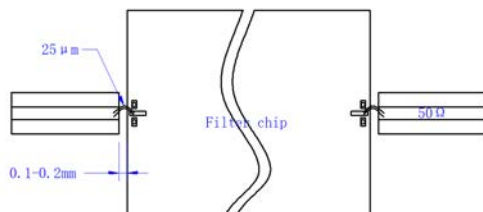
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	32000	~	40000	MHz
中心损耗	/	/		1.8		dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	30.2&42.8	GHz≥	20			dB
带外抑制	30.0	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-27.9	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



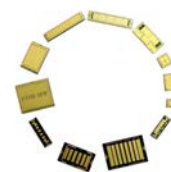
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

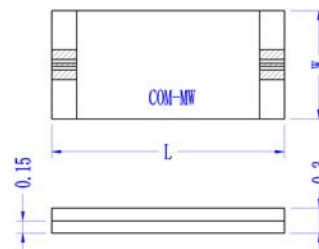
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

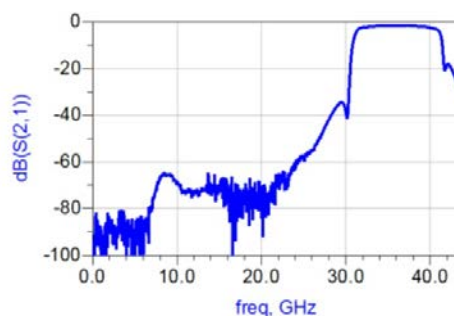
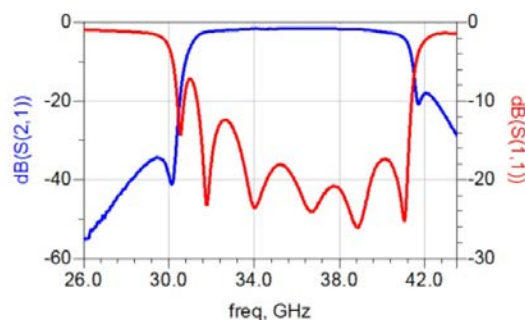
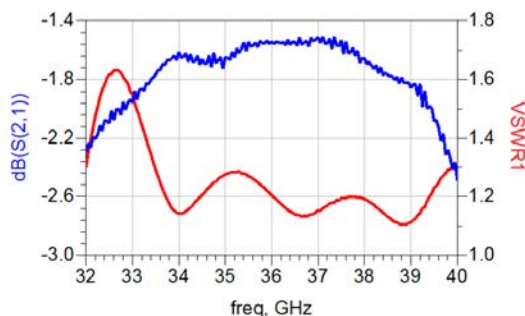


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	2.9	3.0	3.1
W	1.5	1.6	1.7

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

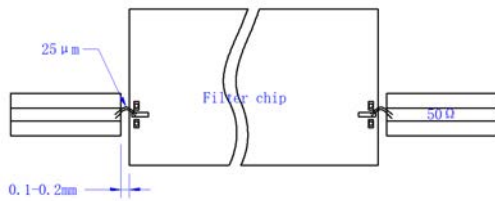
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	32500	~	32900	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	31.25&33.85	GHz≥	20			dB
带外抑制	31.05&34	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-30.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	34.1-43.0	GHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C) 相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

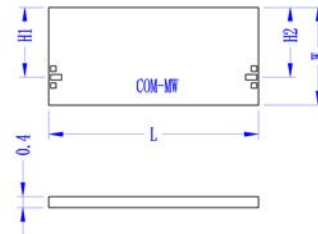
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

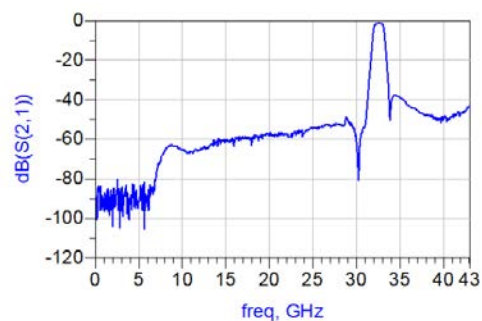
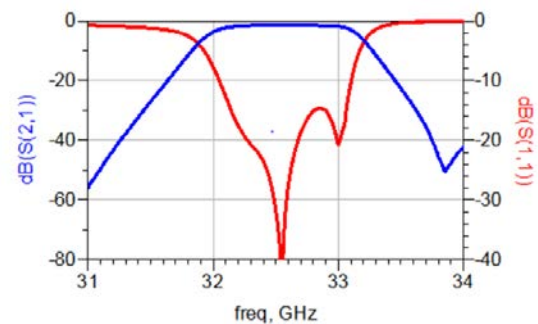
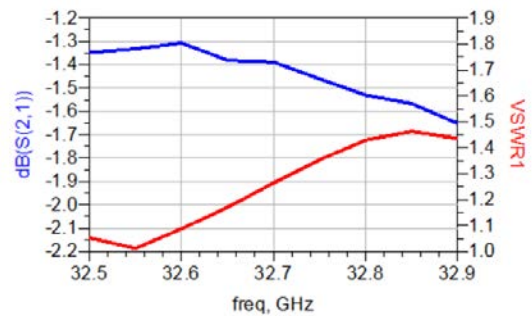


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	4.4	4.5	4.6
W	4.4	4.5	4.6
H1		3.19	
H2		3.19	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

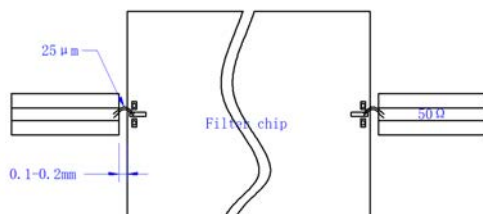
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	33100	~	33700	MHz
中心损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	31.2&36.5	GHz≥	30			dB
带外抑制	30.95&36.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-26.95	GHz≥	50			dB
带外抑制	37.45-43.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.9	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.6ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



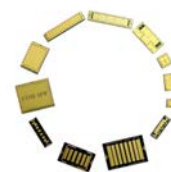
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带)尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

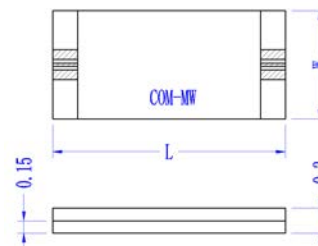
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

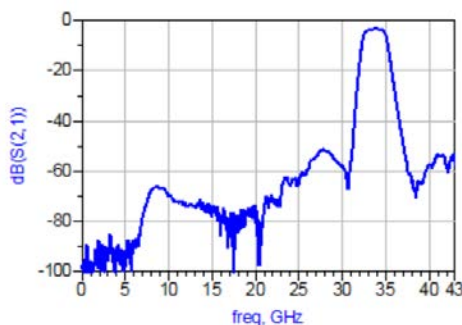
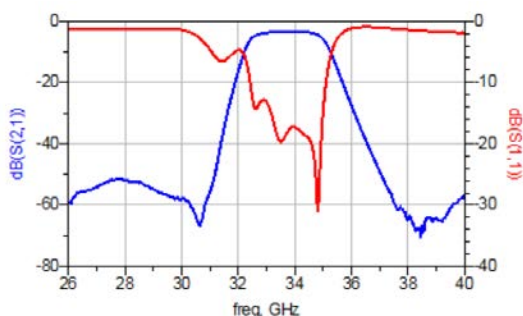
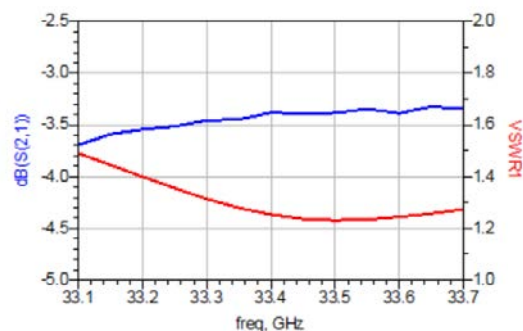


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	3.4	3.5	3.6
W	1.4	1.5	1.6

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

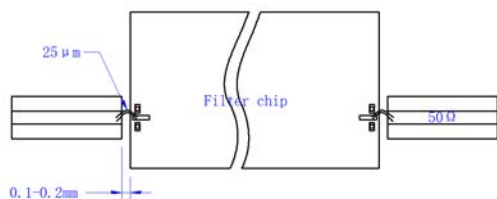
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	35200	~	37800	MHz
中心损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	33.8&38.9	GHz≥	20			dB
带外抑制	33.2&39.1	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-32.4	GHz≥	40			dB
带外抑制	39.2-43.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.4ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



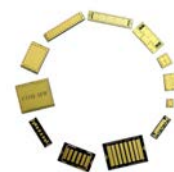
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C) 相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

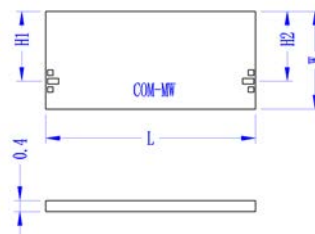
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

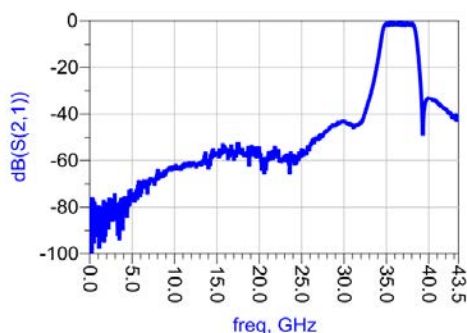
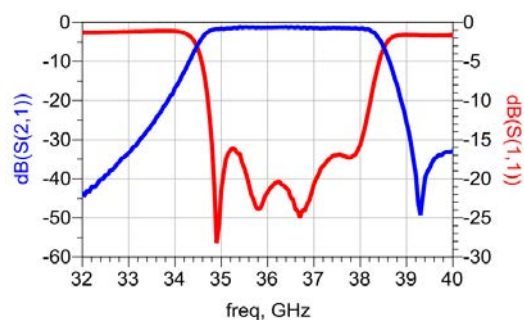
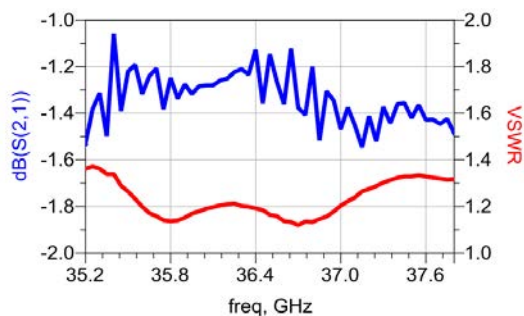


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	7.3	7.4	7.5
W	3.4	3.5	3.6
H1		2.3	
H2		2.3	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

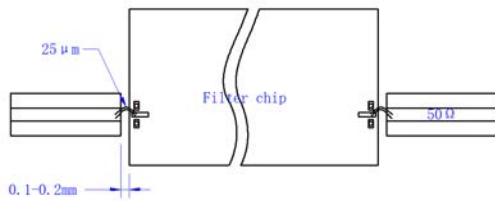
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	35600	~	37800	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	34.8&38.8	GHz≥	20			dB
带外抑制	34.6&39.05	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-34.4	GHz≥	40			dB
带外抑制	39.25-43.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C) 相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝(金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

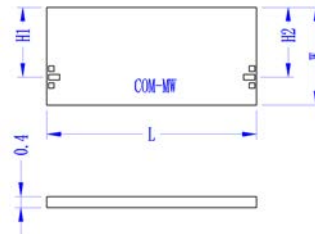
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm	ER:2.2 H:0.254mm
Frequency range 10-20GHz	Frequency range >20GHz

参考实物图

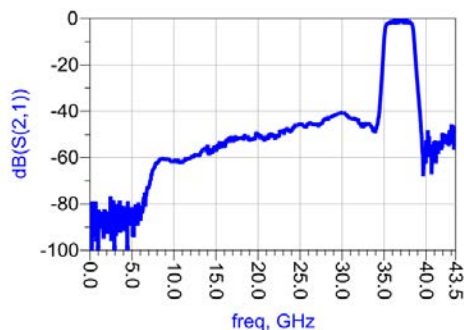
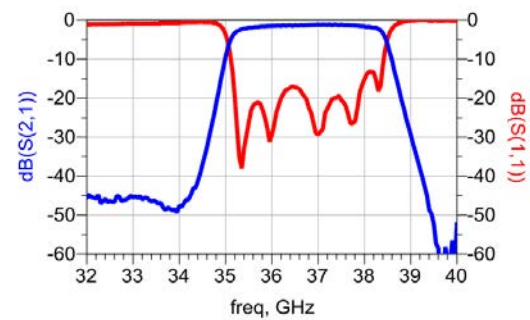
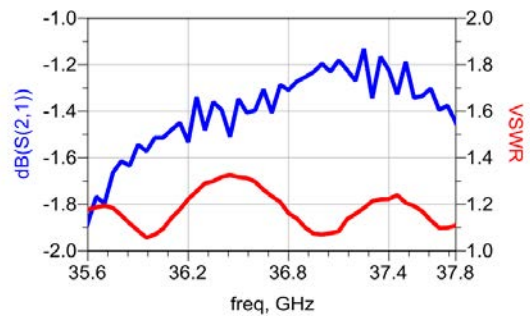


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.7	6.8	6.9
W	3.3	3.4	3.5
H1		3.01	
H2		3.01	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,
50Ω共面波导输出, 金丝键合。

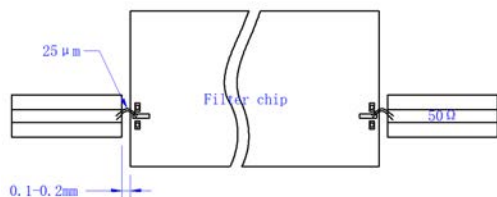
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	38000	~	40600	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	37.15&41.5	GHz≥	20			dB
带外抑制	36.95&41.7	GHz≥	30			dB
带外抑制	DC-36.8	GHz≥	40			dB
带外抑制	41.85-43.5	GHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.5ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

装配示意图



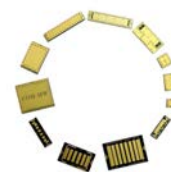
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐或与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

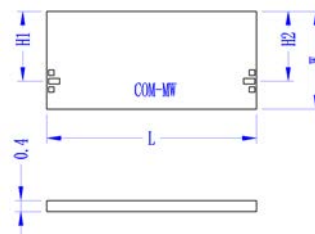
建议PCB布局图

ER:2.2 H:0.254mm Frequency range 10-20GHz	ER:2.2 H:0.254mm Frequency range >20GHz
---	--

参考实物图

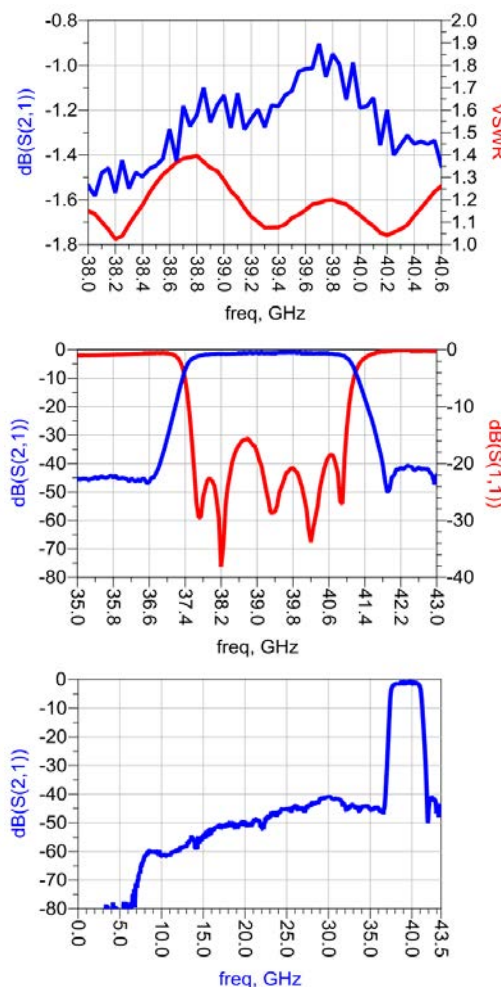


外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	6.2	6.3	6.4
W	3.9	4.0	4.1
H1		2.81	
H2		2.81	

典型测试曲线图



产品特点

高精度硅基 MEMS 加工工艺,

50Ω共面波导输出, 金丝键合。

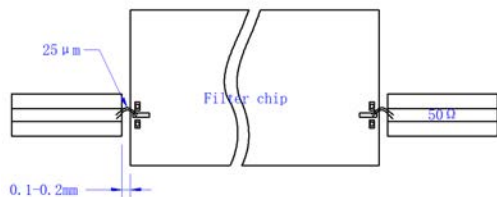
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	38600	~	39100	MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	37.35&41.45	GHz≥	30			dB
带外抑制	36.9&42.65	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-36.25	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	35dBm设计保证
时延波动	≤0.2ns
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	MEMS

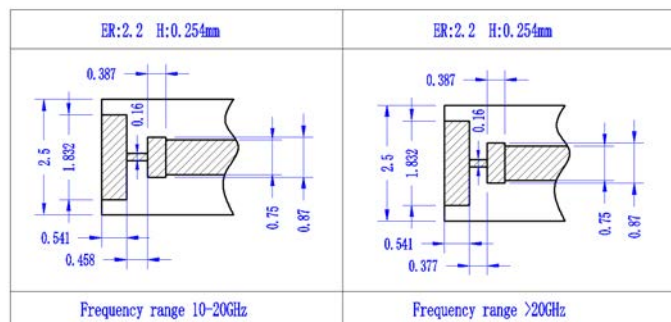
装配示意图



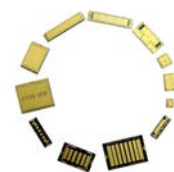
装配及使用说明

- 1、芯片建议安装在金属腔体中, 芯片两侧距离侧壁 0.1mm, 芯片上表面距离上金属屏蔽盖板间隙 ≥3mm;
- 2、芯片推荐采用低温焊料焊接或低应力导电胶粘接;
- 3、芯片应安装在可伐等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度 ≥0.2mm;
- 4、微带线与芯片键合时, 建议使用 50μm×10μm 的金带或 2 根 25μm 的金丝, 要求金丝 (金带) 尽可能短;
- 5、硅基 MEMS 微带带通滤波器通带频率在 10GHz 以上时, 建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配。

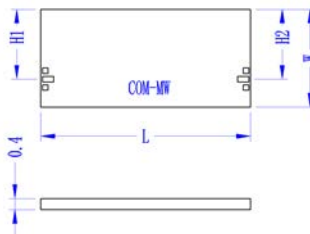
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



尺寸代码	最小值 (mm)	标称值 (mm)	最大值 (mm)
L	8.1	8.2	8.3
W	1.9	2.0	2.1
H1		1.0	
H2		1.0	

典型测试曲线图

